

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2004年1月15日 (15.01.2004)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2004/006017 A1

(51) 国際特許分類: G03F 1/16, H01L 21/027
 (21) 国際出願番号: PCT/JP2003/008377
 (22) 国際出願日: 2003年7月1日 (01.07.2003)
 (25) 国際出願の言語: 日本語
 (26) 国際公開の言語: 日本語
 (30) 優先権データ:
 特願2002-193168 2002年7月2日 (02.07.2002) JP
 特願2002-200777 2002年7月10日 (10.07.2002) JP
 (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): ソニー株式会社 (SONY CORPORATION) [JP/JP]; 〒141-0001 東京都品川区北品川6丁目7番35号 Tokyo (JP).

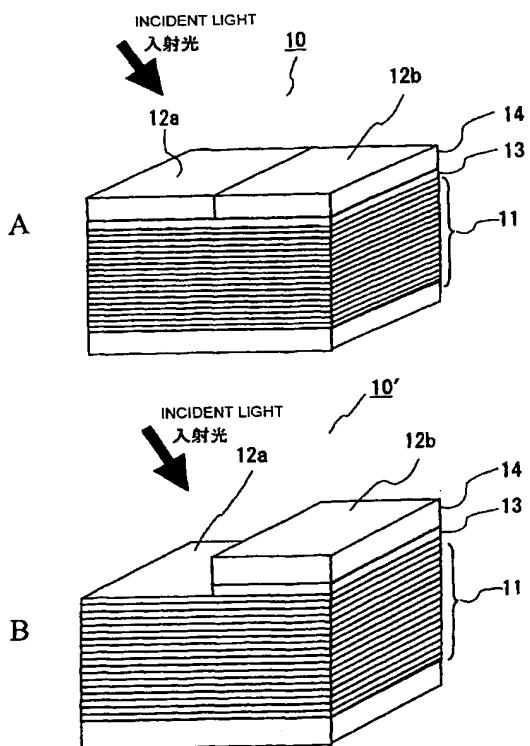
(72) 発明者; および
 (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 普原 稔 (SUGAWARA, Minoru) [JP/JP]; 〒141-0001 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内 Tokyo (JP).
 (74) 代理人: 中村 友之 (NAKAMURA, Tomoyuki); 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目2番3号 虎ノ門第一ビル9階 三好内外国特許事務所内 Tokyo (JP).
 (81) 指定国(国内): KR, US.
 (84) 指定国(広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

[続葉有]

(54) Title: PHASE SHIFT MASK AND PRODUCTION METHOD THEREFOR AND PRODUCTION METHOD FOR SEMICONDUCTOR DEVICE

(54) 発明の名称: 位相シフトマスクおよびその製造方法並びに半導体装置の製造方法



WO 2004/006017 A1

外光の反射光とで所定の位相差が生じるように、第1領域(12a)における各膜厚および各複素屈折率を設定する。

(57) Abstract: A phase shift mask for ultra-short ultraviolet ray capable of being actually constituted by properly combining refractive index and absorption coefficient even if a ultra-short ultraviolet ray is reflected. A phase shift mask (10) comprising a reflection multi-layer film substrate (11), and a first region (12a) and a second region (12b) formed on the substrate (11) is formed by specifying the phase and reflectance of a reflection light of a ultra-short ultraviolet ray obtained from an arbitrary complex refractive index for a ultra-short ultraviolet ray and an arbitrary film thickness. Respective film thicknesses and complex refractive indexes of a formed film in the first region (12a) and a formed film in the second region (12b) are set based on the specified results so as to produce a specified phase difference between the reflection light of a ultra-short ultraviolet ray in the first region (12a) and the reflection light of a ultra-short ultraviolet ray in the second region (12b).

(57) 要約: 極短紫外光を反射する場合であっても、適切な屈折率と吸収係数の組み合わせを得ることで、現実に構成することのできる極短紫外光の位相シフトマスクである。短紫外光を反射する反射多層膜基板(11)と、その反射多層膜基板(11)上に形成された第1領域(12a)および第2領域(12b)とを具備してなる位相シフトマスク(10)を構成するのにあたって、先ず、極短紫外光に対する任意の複素屈折率と膜の任意の膜厚とについて、当該複素屈折率および当該膜厚から得られる極短紫外光の反射光の位相および反射率を特定する。そして、その特定結果を基にして、第1領域(12a)での極短紫外光の反射光と第2領域(12b)での極短紫外光の反射光とで所定の位相差が生じるように、第1領域(12a)における各膜厚および各複素屈折率を設定する。



2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

明細書

位相シフトマスクおよびその製造方法並びに半導体装置の製造方法

5 技術分野

本発明は、半導体装置の回路パターンを形成するためのリソグラフィ工程にて用いられる位相シフトマスクおよびその製造方法、並びにそのリソグラフィ工程を含む半導体装置の製造方法に関し、特にいわゆる極短紫外光に対応した位相シフトマスクおよびその製造方法並びに半導体装置の製造方法に関する。

10 背景技術

近年、半導体装置の微細化に伴い、ウエハ上に形成される回路パターンやその回路パターンを形成するためのレジストパターン等に対しては、
15 パターン幅（線幅）やパターン間のピッチ等の極小化が要求されている。このような極小化の要求については、レジストの露光に用いる紫外光の波長をより短波長にすることで対応が可能となる。例えば、350nmの設計ルールの半導体装置には365nmの波長、250nmおよび180nmの設計ルールの半導体装置には248nmの波長、130nmおよび100nmの設計ルールの半導体装置には193nmの波長といったように、半導体装置の微細化が進むほど、露光に用いる紫外光の波長も短波長化され、さらには157nmの波長の紫外光が用いられるようになってきている。

20 一般に、これらの波長による解像度は、 $w = k_1 \times (\lambda / NA)$ というレイリーの式で表されることが知られている。ここで、wは解像される最小幅のパターン、NAは投影光学系のレンズの開口数、 λ は露光光の波長である。また、 k_1 は、主にレジストの性能および超解像技術

の選択等により決定されるプロセス定数であって、最適なレジストおよび超解像技術を用いれば $k_1 = 0.35$ 程度まで選択できることが知られている。なお、超解像技術とは、マスクを透過し、マスク上遮光パターンで回折された光の±1次回折光を選択的に用いることにより、波長よりも小さなパターンを得ようとするものである。

このレイリーの式によれば、例えば 157nm の波長を用いた場合に対応が可能な最小のパターン幅は、 $NA = 0.9$ のレンズを用いるとすれば、 $w = 61\text{nm}$ となることがわかる。すなわち、61nm よりも小さなパターン幅を得るためにには、157nm よりもさらに短波長の紫外光を用いる必要がある。

のことから、最近では、157nm よりも短波長の紫外光として、極短紫外光 (EUV ; Extreme Ultra Violet) と呼ばれる 13.5nm の波長のものを用いることも検討されている。ただし、157nm の波長の紫外光までは、例えば CaF_2 (フッ化カルシウム) や SiO_2 (二酸化ケイ素) といった光透過性のある材料が存在するため、当該紫外光を透過させる構成のマスクおよび光学系を作製することができる。ところが、13.5nm の波長の極短紫外光については、当該極短紫外光を所望の厚さでもって透過させる材料が存在していない。そのため、13.5nm の波長の極短紫外光を用いる場合には、光透過型のマスクおよび光学系ではなく、光を反射する反射型マスクおよび反射型光学系によって、マスクおよび光学系を構成する必要がある。

反射型マスクを用いた場合には、マスク面で反射された光が、そのマスクに入射される光と相互に干渉することなく、投影光学系に導かれねばならない。そのため、マスクに入射される光は、必然的にマスク面の法線に対して角度 ϕ を持った斜め入射となる必要が生じる。この角度は、投影光学系のレンズの開口数 NA 、マスク倍率 m 、照明光源の大き

さ σ から決まる。具体的には、例えばウエハ上に 5 倍の縮小倍率を持つマスクを用いた場合、 $NA = 0.3$ 、 $\sigma = 0.8$ の露光装置においては、光が $3.44 \pm 2.75^\circ$ の立体角を持ってマスク上に入射することになる。

また、ウエハ上に 4 倍の縮小倍率を持つマスクを用いた場合、 $NA =$

5 0.25 、 $\sigma = 0.7$ の露光装置においては、光が $3.58 \pm 2.51^\circ$ の立体角を持ってマスク上に入射することになる。これらの立体角を考慮して、マスクに入射する露光光の入射角度は、通常 5° 近傍になるように設定される。ここで、入射角度は、マスク表面に対する法線となす角度として定義される。

10 このような反射型マスクにより 13.5nm の波長の極短紫外光を反射する場合、例えば $NA = 0.25$ の露光装置においては、上述したレイリーの式から $k_1 \geq 0.6$ の条件であれば、 32.4nm の線幅を形成することができるようになる。すなわち、極短紫外光とその極短紫外光でのパターン転写を可能とする反射型マスクを用いることで、光透過型のマスクおよび光学系では達成できなかったパターン幅やパターンピッチ等の極小化にも対応可能となるのである。

ところで、近年では、微細化に対する要望が急速に進んでおり、パターン幅やパターンピッチ等の更なる極小化への対応が望まれている。例えば、特に小さなサイズの要求されるゲート線幅においては、 32.4nm よりも小さなサイズの線幅、すなわち $k_1 < 0.6$ となる条件も要求されるようになってきている。具体的には、加工後ゲート線幅が 15nm で、レジスト上線幅においても 25nm 線幅が要求されるに至っている。この 25nm のレジスト線幅については、波長 13.5nm で $NA = 0.25$ の露光装置の場合に、レイリーの式から $k_1 = 0.46$ となる。このようなサイズの線幅を形成する場合には、単に 13.5nm の波長の極短紫外光とこれを

反射する反射型マスクとを用いるだけではなく、超解像技術を用いることが必要とされる。

超解像技術としては、マスクパターンの±1次回折光を選択的に利用する①変形照明光源（輪帯照明や4つ穴照明等）や②瞳フィルター（輪

5 帯フィルターや4つ穴フィルター等）の他に、③ハーフトーン型位相シフトマスク、④ハーフトーン型位相シフトマスクと変形照明光源の組み合わせ、または⑤レベンソン型位相シフトマスク（または「オルタネーティング位相シフトマスク」ともいう）を用いることが知られている。

③、④および⑤（以下、ハーフトーン型位相シフトマスクおよびレベン
10 ソン型位相シフトマスクを「位相シフトマスク」と総称する）は、い
ずれも光の位相差を利用したものであり、解像性能を向上させ、またパ
ターンコントラストを増大させる上で非常に有効であることから、リソ
グラフィ工程では①または②に比べて多く用いられている。

しかしながら、光を透過させる透過型マスクであれば、周知のように
15 位相シフトマスクを構成することは容易であるが、極短紫外光に対応す
る反射型マスクの場合には、位相シフトマスクを構成することが非常に
困難である。例えば、透過型マスクであればマスク基板を掘り込むこと
で光の位相差が互いに180°異なる領域を形成することができるが、こ
れをそのまま反射型マスクに適用しても、マスク基板を掘り込むことで
20 光の反射率も同時に変化してしまうため、位相シフトマスクを構成する
ことはできない。また、透過型マスクであれば材料の位相シフト効果を
利用することで光の位相差が互いに180°異なる領域を形成する能够
性があるが、これを反射型マスクに適用しても、極短紫外光の露光波長に
25 対して吸収の無い材料は存在せず、単一材料では所望の反射率と位相シ
フト効果を奏する構成が得られないため、位相シフトマスクを構成する
ことができない。さらには、極短紫外光の反射型マスクに用いられる反

射多層膜基板は Si (ケイ素) 層と Mo (モリブデン) 層を交互に積層した構造（例えば 40 層の繰り返し）のものが一般的であることから、その積層順序が相互に逆になっている領域を別々に形成することで位相差が 180° で反射率が互いに等しい領域を構成することも提案されているが、そのような積層構造を作製することは甚だ困難であり未だそのような積層構造の位相シフトマスクは実用化されていない。これらのことから、極短紫外光に対応した反射型の位相シフトマスクについては、これを現実に構成することは不可能であると考えられてきた。

そこで、本発明は、極短紫外光の波長に対してはマスク用材料として適している材料の屈折率が 0.89 から 1.01 の間に存在していることを鑑み、適切な屈折率と吸収係数の組み合わせを得ることで、現実に構成することのできる極短紫外光の位相シフトマスクおよびその製造方法並びに半導体装置の製造方法を提供することを目的とする。

15 発明の開示

本発明は、上記目的を達成するために案出された露光光の位相シフトマスクで、露光光を反射して被露光体上に所望パターンを転写するため用いられる露光光の位相シフトマスクであって、露光光を反射する反射多層膜基板と、当該反射多層膜基板上に形成された第 1 領域および第 2 領域とを具備するとともに、前記第 1 領域の形成膜および前記第 2 領域の形成膜における各膜厚および各複素屈折率が、前記第 1 領域での露光光の反射光と前記第 2 領域での露光光の反射光とで所定の位相差が生じるように設定されていることを特徴とするものである。

また、本発明は、上記目的を達成するために案出された露光光の位相シフトマスクの製造方法で、露光光を反射する反射多層膜基板と、当該反射多層膜基板上に形成された第 1 領域および第 2 領域とを具備してな

る露光光の位相シフトマスクの製造方法であって、前記露光光に対する任意の複素屈折率と、前記反射多層膜基板上に形成する膜の任意の膜厚とについて、当該複素屈折率および当該膜厚から得られる前記露光光の反射光の位相および反射率を特定し、特定した位相および反射率に基づいて、前記第1領域での露光光の反射光と前記第2領域での露光光の反射光とで所定の位相差が生じるように、前記第1領域の形成膜および前記第2領域の形成膜における各膜厚および各複素屈折率を選定することを特徴とする。

また、本発明は、上記目的を達成するために案出された半導体装置の製造方法で、露光光の位相シフトマスクを用いて被露光体上に所望パターンを転写するリソグラフィ工程を含む半導体装置の製造方法であって、前記露光光に対する任意の複素屈折率と、前記反射多層膜基板上に形成する膜の任意の膜厚とについて、当該複素屈折率および当該膜厚から得られる前記露光光の反射光の位相および反射率を特定し、特定した位相および反射率に基づいて、前記反射多層膜基板上の第1領域での露光光の反射光と前記反射多層膜基板上の第2領域での露光光の反射光とで所定の位相差が生じるように、前記第1領域の形成膜および前記第2領域の形成膜における各膜厚および各複素屈折率を選定し、選定した複素屈折率および膜厚にて前記第1領域の形成膜および前記第2領域の形成膜をそれぞれ前記反射多層膜基板上に形成して、前記反射多層膜基板上に前記第1領域および前記第2領域を具備してなる露光光の位相シフトマスクを構成し、構成した露光光の位相シフトマスクを用いて被露光体上に所望パターンを転写することを特徴とする。

上記構成の露光光の位相シフトマスク、上記手順の位相シフトマスクの製造方法、および上記手順の半導体装置の製造方法では、反射多層膜基板上に形成される第1領域および第2領域について、露光光の反射光

に所定の位相差が生じるように、それぞれの膜厚および複素屈折率が設定されている。すなわち、設定された膜厚となるように第1領域の形成膜および第2領域の形成膜が成膜され、設定された複素屈折率となるように第1領域の形成膜および第2領域の形成膜の形成材料が選択されている。設定された複素屈折率とするには、各形成膜を、複数の材料からなる積層構造とすることで達成できる。このように、第1領域の形成膜および第2領域の形成膜における各膜厚および各複素屈折率を設定値に合わせることで、第1領域と第2領域とで露光光の反射光に所定（例えば180°）の位相差が生じる。

本発明は、露光光は極短紫外光、X線、放射線、紫外線、又は、可視光であることを特徴とする。また、位相シフトマスクはハーフトーン型位相シフトマスク、又は、レベンソン型位相シフトマスクであることを特徴とする。

また、本発明は、第1領域の形成膜および第2領域の形成膜における各膜厚および各複素屈折率は、等位相線及び等反射率線を用いて設定され、等位相線は、前記複素屈折率の虚部を固定して求めることを特徴とする。

図面の簡単な説明

第1A図乃至第1B図は、本発明に係る位相シフトマスクの概略構成の一例を示す模式図である。

第2図は、本発明の第1実施形態における位相シフトマスクの製造手順を示すフローチャートである。

第3図は、等位相線の一具体例を示す説明図である。

第4図は、等反射率線の一具体例を示す説明図である。

第5図は、ハーフトーン型位相シフトマスクを得るためのRu膜厚およびTa_N膜厚に対する合成複素屈折率の実部の分布を示す説明図である。

第6図は、ハーフトーン型位相シフトマスクにおけるトータル膜厚と合成複素屈折率の実部(n)および反射率(k)の関係を示す説明図である。

第7図は、ハーフトーン型位相シフトマスクにおけるトータル膜厚とRu膜厚およびTa_N膜厚との関係を示す説明図である。

第8図は、ハーフトーン型位相シフトマスクを得るためのRu膜厚およびTa_N膜厚に対する合成複素屈折率の虚部の分布を示す説明図である。

第9図は、Ru層の膜厚とTa_N層の膜厚に対する位相差およびハーフトーン反射率をマトリクス状に配した例を示す説明図である。

第10図は、Ru層の膜厚とCr層の膜厚に対する位相差をマトリクス状に配した例を示す説明図である。

第11図は、Ru層の膜厚とCr層の膜厚に対するハーフトーン反射率をマトリクス状に配した例を示す説明図である。

第12図は、ハーフトーン型位相シフトマスクのNA=0.25の場合におけるマスク上30nm(ウエハ上座標で表示)の開口部を具備するホールパターンの光強度分布を示す説明図である。

第13図は、ハーフトーン型位相シフトマスクの構成例の断面構造を示す模式図である。

第14図は、本発明の第2の実施の形態における位相シフトマスクの製造手順を示すフローチャートである。

第15図は、等位相線の一具体例を示す説明図である。

第16図は、レベンソン型位相シフトマスクの構成例（構造1）の断面構造を示す模式図である。

第17図は、構造1のレベンソン型位相シフトマスクにおいて膜内多重干渉を考慮した位相と反射率の最適化（Mo膜厚をパラメータとしている）の例を示す説明図である。
5

第18図は、構造1のレベンソン型位相シフトマスクにおける光強度分布を示す説明図である。

第19図は、構造1のレベンソン型位相シフトマスクの位相差（ウエハ上で表示）を示す説明図である。

10 第20図は、構造1のレベンソン型位相シフトマスクの成膜手順の一例を示す説明図（その1）である。

第21図は、構造1のレベンソン型位相シフトマスクの成膜手順の一例を示す説明図（その2）である。

15 第22図は、構造1のレベンソン型位相シフトマスクの成膜手順の一例を示す説明図（その3）である。

第23図は、構造1のレベンソン型位相シフトマスクの成膜手順の一例を示す説明図（その4）である。

第24図は、レベンソン型位相シフトマスクの他の構成例（構造2）の断面構造を示す模式図である。

20 第25図は、構造2のレベンソン型位相シフトマスクにおいて膜内多重干渉を考慮した位相と反射率の最適化（Mo膜厚をパラメータとしている）の例を示す説明図である。

第26図は、構造2のレベンソン型位相シフトマスクにおける光強度分布を示す説明図である。

25 第27図は、構造2のレベンソン型位相シフトマスクの位相差（ウエハ上で表示）を示す説明図である。

第28図は、レベンソン型位相シフトマスクのさらに他の構成例（構造3）の断面構造を示す模式図である。

第29図は、構造3のレベンソン型位相シフトマスクにおいて膜内多重干渉を考慮した位相と反射率の最適化（M○膜厚をパラメータとしている）の例を示す説明図である。

第30図は、構造3のレベンソン型位相シフトマスクにおける光強度分布を示す説明図である。

第31図は、構造3のレベンソン型位相シフトマスクの位相差（ウエハ上で表示）を示す説明図である。

第32図は、レベンソン型位相シフトマスクの第1領域と第2領域とが平坦な構成例（構造4）の断面構造を示す模式図である。

第33図は、構造4のレベンソン型位相シフトマスクにおいて膜内多重干渉を考慮した位相と反射率の最適化（M○膜厚をパラメータとしている）の例を示す説明図である。

第34図は、構造4のレベンソン型位相シフトマスクにおける光強度分布を示す説明図である。

第35図は、構造4のレベンソン型位相シフトマスクの位相差（ウエハ上で表示）を示す説明図である。

第36図は、構造4のレベンソン型位相シフトマスクの成膜手順の一例を示す説明図（その3）である。

第37図は、構造4のレベンソン型位相シフトマスクの成膜手順の一例を示す説明図（その4）である。

第38図は、レベンソン型位相シフトマスクの他の平坦な構成例（構造5）の断面構造を示す模式図である。

第39図は、構造5のレベンソン型位相シフトマスクにおいて膜内多重干渉を考慮した位相と反射率の最適化（M○膜厚をパラメータとしている）の例を示す説明図である。

第40図は、構造5のレベンソン型位相シフトマスクにおける光強度分布を示す説明図である。

第41図は、構造5のレベンソン型位相シフトマスクの位相差（ウエハ上で表示）を示す説明図である。

第42図は、レベンソン型位相シフトマスクのさらに他の平坦な構成例（構造6）の断面構造を示す模式図である。

第43図は、構造6のレベンソン型位相シフトマスクにおいて膜内多重干渉を考慮した位相と反射率の最適化（M○膜厚をパラメータとしている）の例を示す説明図である。

第44図は、構造6のレベンソン型位相シフトマスクにおける光強度分布を示す説明図である。

第45図は、構造6のレベンソン型位相シフトマスクの位相差（ウエハ上で表示）を示す説明図である。

第46図は、構造5のレベンソン型位相シフトマスクにおけるマスク上TaN幅（ウエハ上で表示）に対する光強度分布（NA=0.25）を示す説明図である。

第47図は、従来のバイナリマスクにおけるマスク上TaN幅（ウエハ上で表示）に対する光強度分布（NA=0.25）を示す説明図である。

第48図は、構造5のレベンソン型位相シフトマスクにおけるマスク上TaN幅（ウエハ上で表示）に対する光強度分布（NA=0.30）を示す説明図である。

以下、図面に基づき本発明に係る露光光の位相シフトマスクおよびその製造方法並びに半導体装置の製造方法について、露光光を極短紫外光とした場合を例にとり、説明する。なお、当然のことではあるが、本発明は、以下に述べる実施の形態に限定されるものではない。

5 [位相シフトマスクの概略構成の説明]

先ず、本発明に係る極短紫外光の位相シフトマスクの概略構成について説明する。ここで説明する位相シフトマスクは、半導体装置の製造方法における一工程であるリソグラフィ工程にて、極短紫外光を反射してウエハ等の被露光体上に所望パターン（例えば回路パターン）を転写するためには用いられるものである。なお、ここで言う「極短紫外光」には、例えば波長が 13.5nm のものに代表されるように、従前のリソグラフィ工程で用いられていた紫外光よりも短波長（例えば、1nm 以上 100nm 以下）のものが該当する。

10 第 1 A 図乃至第 1 B 図は、本発明に係る位相シフトマスクの概略構成の一例を示す模式図である。図例のように、位相シフトマスク 10, 10' は、極短紫外光を反射する反射多層膜基板（マスクブランクス） 11 と、その反射多層膜基板 11 上に形成された第 1 領域 12a および第 2 領域 12b とを具備したものである。

15 反射多層膜基板 11 は、例えば Si (ケイ素) 層と Mo (モリブデン) 層とを交互に積層した構造で構成されるが、その積層の繰り返し数が 40 層であるものが一般的である。また、Si 層および Mo 層の合計の厚さと Mo 層の厚さとの比 Γ は、 $Mo \text{ 層厚} / (Si \text{ 層厚} + Mo \text{ 層厚}) = 0.4$ が適切であることが知られている。したがって、反射多層膜基板 11 では、露光に用いる極短紫外光の波長 λ を 13.5nm とすると、
20 Si 層と Mo 層の合計の膜厚が $(\lambda / 2) / (0.9993 \times 0.6 +$

$0.9211 \times 0.4) = 6.973\text{nm}$ 、 Si 層の厚さが $6.9730 \times 0.6 = 4.184\text{nm}$ 、
 Mo 層の厚さが $6.9730 \times 0.4 = 2.789\text{nm}$ となる。

この反射多層膜基板 11 上には、バッファ膜 13 を介して吸収膜 14 が形成されている。バッファ膜 13 は、吸収膜を形成する際のエッチャン 5 グストップとして、あるいは吸収膜形成後の欠陥除去時のダメージ回避を目的として設けられているもので、例えば Ru (ルテニウム) 層や SiO_2 (二酸化ケイ素) によって構成される。吸収膜 14 は、極短紫外光を吸収する材料からなるもので、例えば TaN (タンタルナイトライド) 層によって構成される。ただし、吸収膜 14 は、極短紫外光のマスク用材料として用いることのできるものであれば、他の材料からなるものであってもよい。具体的には、TaN 以外に Ta (タンタル) または Ta 化合物、Cr (クロム) または Cr 化合物、W (タンゲステン) または W 化合物等が考えられる。

ところで、反射多層膜基板 11 上には、第 1 領域 12a および第 2 領域 12b が形成されている。第 1 領域 12a と第 2 領域 12b とでは、それぞれでの極短紫外光の反射光に、所定 (例えば 180°) の位相差が生じるようになっている。

そのために、第 1 領域 12a と第 2 領域 12b とでは、後述するように、それぞれにおける形成膜 (バッファ膜 13 + 吸収膜 14) の構成材料またはその膜厚が異なる (第 1 A 図参照)。ただし、いずれか一方の領域のみにバッファ膜 13 および吸収膜 14 を形成することによって、各領域 12a, 12b に位相差が生じるようにしたものであってもよい (第 1 B 図参照)。

第 1 領域 12a と第 2 領域 12b との位相差 ψ は、第 1 領域 12a における入射光と反射光の位相差を ϕ_1 、第 2 領域 12b における入射

光と反射光の位相差を ϕ_1 、第1領域12aと第2領域12bとの膜厚の差を h とすると、以下に示す（1）式によって特定することができる。

$$\psi(\lambda) = \phi_1(\lambda) - \phi_2(\lambda) + (4\pi h \cos\theta)/\lambda \quad \dots \quad (1)$$

5 この（1）式において、 θ は、マスクに入射する光がマスク面上法線に対してなす角度である。 λ は露光中心波長である。 ϕ_1 および ϕ_2 は、例えば “Yamamoto and T. Namioka” “Layer-by-layer design method for soft-x-ray multilayers”, Applied Optics, Vol. 31 pp1622-1630, (1992) で開示されている方法で求めればよい。

また、（1）式を用いて位相差 $\psi(\lambda)$ を求めるためには、第1領域12aと第2領域12bの形成材料の複素屈折率が必要である。極短紫外光の露光中心波長が 13.5 nm である場合において、形成材料の複素屈折率は、例えば $M\circ : 0.92108 - 0.00643543i$ 、 $S\circ : 0.9993 - 0.00182645i$ 、 $R\circ : 0.88749 - 0.0174721i$ 、 $T\circ N : 0.94136 - 0.0315738i$ となる。形成材料が任意の m 層の積層構造で構成されている場合には、以下に示す（2）式および（3）式によって得られる合成複素屈折率を用いればよい。

$$n = \sum_1^m n_m d_m \Big/ \sum_1^m d_m \quad \dots \quad (2)$$

20

$$k = \sum_1^m k_m d_m \Big/ \sum_1^m d_m \quad \dots \quad (3)$$

このようにして特定される位相差 ψ が第 1 領域 12a と第 2 領域 12b とで所定値（例えば 180° ）となるように、位相シフトマスク 10, 10' では、第 1 領域 12a および第 2 領域 12b における形成膜（バッファ膜 13 + 吸収膜 14）の構成材料（特に複素屈折率）およびその膜厚が設定されているのである。つまり、本実施形態で説明する位相シフトマスク 10, 10' は、第 1 領域 12a の形成膜および第 2 領域 12b の形成膜における各膜厚および各複素屈折率が、第 1 領域 12a での極短紫外光の反射光と第 2 領域 12b での極短紫外光の反射光とで所定の位相差が生じるように設定されている点に、大きな特徴がある。

10 [位相シフトマスクの製造手順の説明]

次に、以上のような特徴を持つ位相シフトマスク 10, 10' について、その製造手順を説明する。ただし、ここでは、その製造手順を第 1 の実施の形態と第 2 の実施の形態とに分けて説明する。

[第 1 の実施の形態]

15 第 1 の実施の形態では、本発明を適用してハーフトーン型位相シフトマスクを構成する場合を例に挙げて説明する。第 2 図は、第 1 の実施の形態における位相シフトマスクの製造手順を示すフローチャートである。

ハーフトーン型位相シフトマスクの製造にあたっては、先ず、各複素屈折率に対する等位相線および等反射率線を求める（ステップ 101、
20 以下ステップを「S」と略す）。これら等位相線および等反射率線は、既存の材料に限定することなく、任意の複素屈折率に対して求めておく。つまり、極短紫外光に対する任意の複素屈折率について、その複素屈折率から得られる極短紫外光の反射光の位相および反射率を特定する。なお、複素屈折率に対する位相および反射率は、理論的に一意的に特定することができる。また、任意の複素屈折率には、反射多層膜基板 11 の

複素屈折率も含むものとする。すなわち、等位相線および等反射率線は、反射多層膜基板 1 1 に対しても求めておく。

第 3 図は、等位相線の一具体例を示す説明図である。図例の等位相線は、複素屈折率の虚部 (k) を $0.0100i$ に固定して求めている。また、第 4 図は、等反射率線の一具体例を示す説明図である。図例の等反射率線は、複素屈折率の実部 (n) を 0.9100 に固定して求めている。なお、これらの等位相線および等反射率線において、(1) 式の λ で表される露光波長は 13.5nm であり、 θ で表されるマスク上への斜め入射光の入射角度は 4.84° である。

反射率および位相は複素屈折率の実部および複素屈折率の虚部それぞれに依存するが、位相は主に複素屈折率の実部に依存し、反射率は主に複素屈折率の虚部に依存する。したがって、最終的に第 1 領域 1 2 a と第 2 領域 1 2 b とで 180° の位相差および所望の反射率を得るために、近似的にこれら第 3 図の等位相線および第 4 図の等反射率線を用いて、各領域 1 2 a, 1 2 b の構成材料の複素屈折率または膜厚を設定すればよい。あるいは、複素屈折率および膜厚の両方を設定するようにしてもよい。

複素屈折率または膜厚の設定にあたっては、先ず、反射多層膜基板 1 1 上の第 1 領域 1 2 a および第 2 領域 1 2 b に加工可能な材料および膜構成を求める (S 1 0 2)。そして、第 1 領域 1 2 a の材料構成における複素屈折率と、第 2 領域 1 2 b の材料構成における複素屈折率とを、それぞれ求める (S 1 0 3, S 1 0 4)。

ここで、例えば第 1 B 図に示した構成のハーフトーン型位相シフトマスク 1 0'、すなわち第 2 領域 1 2 b にのみバッファ膜 1 3 を介して吸収膜 1 4 が形成され、第 1 領域 1 2 a と第 2 領域 1 2 b とで 180° の位相差が生じる位相シフトマスクを構成する場合を考える。このとき、第

1領域12aと第2領域12bとでは、それぞれ所望の反射率（互いに異なる値）が得られるものとする。また、第2領域12bでは、バッファ膜13の構成材料としてRuを、吸収膜14の構成材料としてTaNを、それぞれ選択しているものとする。

5 第5図は、Ru膜厚とTaN膜厚に対する複素屈折率の実部の分布を示す説明図である。図例からは、Ru膜厚が1nmから20nmおよびTaN膜厚が1nmから50nmの間において、合成複素屈折率の実部が0.890から0.945の間の値を取り得ることがわかる。つまり、第5図の内容から、第2領域12bの材料構成における複素屈折率がわかることになる。なお、第1領域12aについては、バッファ膜13および吸収膜14が形成されていないので、反射多層膜基板11の積層構造から複素屈折率を求めるべき。

10

それぞれの複素屈折率を求めた後は、その第1領域12aにおける屈折率および第2領域12bにおける屈折率と、既に求めている等位相線とから、第1領域12aと第2領域12bとの形成膜の段差、すなわち第2領域12bの形成膜の膜厚を求める（S105）。具体的には、第5図の複素屈折率分布および第3図の等位相線図を基にすれば、反射多層膜基板11との位相差が180°となるための形成膜（バッファ膜13+吸収膜14）のトータル膜厚と合成複素屈折率の実部（n）との関係が、第6図に示すように一意的に求まる。また、反射多層膜基板11との位相差が180°となるためのRu層（バッファ膜13）とTaN層（吸収膜14）のそれぞれの膜厚は、合成複素屈折率が位相差180°を与える条件から、第7図に示すように一意的に求まる。これらのようにして、第2領域12bの形成膜の膜厚、すなわちRu層およびTaN層の膜厚を求めるべき。

15

20

25

Ru層およびTaN層のそれぞれの膜厚が求まると、次いで、第1領域12aの形成膜と第2領域12bにおける極短紫外光の反射率を求める(S106)。反射率は、Ru層およびTaN層の各膜厚からトータル膜厚に対する合成複素屈折率の虚部(k)を求め、その合成複素屈折率の虚部から反射率を求めればよい。第8図は、Ru層およびTaN層の各膜厚と、トータル膜厚に対する合成複素屈折率の虚部(k)との関係を示す説明図である。また、複素屈折率の虚部(k)がわかれば、反射率は、第4図に示した等反射率線から一意的に求まる。第6図には、合成複素屈折率虚部(k)および反射率とトータル膜厚との関係をも併せて示している。

ここで、例えば、反射率を0.075に設定する場合は、第6図の内容からトータル膜厚43nmであり、このとき第7図の内容からRu層の膜厚14nmおよびTaN層の膜厚29nmが最も近い条件として得られる。この膜厚において、以下に述べるように、さらに合成複素屈折率の正確な値を用いて位相差および反射率を求ることで、位相差182.4°および反射率0.075のハーフトーン型位相シフトが得られるようになる。

ただし、第6図の内容によれば、反射率を0.075に設定する場合の膜厚条件は、トータル膜厚が46.3nmおよび48.3nm近傍にも存在していることがわかる。つまり、トータル膜厚は、複素屈折率から単一の条件として定まるものではないので、以下に述べる膜厚調整を含めて様々な条件を総合的に勘案してようく定めるようすればよい。このとき、マスク製造における膜厚ばらつきに対する複素屈折率に対するプロセス余裕度を大きく確保するためには、図中においてトータル膜厚の変化が平坦な部分(例えば50.5nm付近)に設定することが望ましい。このようにすれば、±1.5nm程度の範囲でトータル膜厚がばらついても、複素屈折率は変化しないので、位相差および反射率も変化しないからである。

その後は、第1領域12aと第2領域12bとで 180° の位相および所望の反射率が得られるように、さらに膜厚の調整を行う(S107, S108)。ここで膜厚の調整を行う更なる理由は、第6図で考慮していない膜内多重干渉効果も含めて所望の位相および反射率を得るためにある。具体的には、Ru層の膜厚とTaN層の膜厚をそれぞれ適宜変化させた場合の各位相差と各ハーフトーン反射率を、上述したような手順で求める。第9図は、Ru層の膜厚とTaN層の膜厚に対する位相差およびハーフトーン反射率をマトリクス状に配した例を示す説明図である。ここで、ハーフトーン反射率とは、第1B図の位相シフトマスク10'において、第1領域12aの反射率と第2領域12bの反射率との差である。そして、これらの結果から、所望の位相差とハーフトーン反射率を満たすウインドウ、すなわち調整後の膜厚の設定値を選択すればよい。なお、図例では、位相差 $180.0 \pm 6^{\circ}$ およびハーフトーン反射率 $9.0 \pm 1\%$ 、および位相差 $180.0 \pm 6^{\circ}$ およびハーフトーン反射率 $5.0 \pm 1\%$ の場合を例示している(図中のシャドウ部参照)。これにより、例えば、Ru層の膜厚13nmおよびTaN層の膜厚30nmと設定すれば、位相差 179.4° およびハーフトーン反射率9.5%のハーフトーン型位相シフトが得られるようになる。ここで、反射率は、0.0070で第6図で予測されたものと略一致する。第10図および第11図は、Ru層の膜厚とCr層の膜厚に対する位相差およびハーフトーン反射率をマトリクス状に配した別の例である。これにより、例えば、Ru層の膜厚9nmおよびCr層の膜厚を34nmと設定すれば、位相差 179.2° およびハーフトーン反射率4.1%のハーフトーン型位相シフトマスクが得られるようになる。

25 このようにして第2領域12bの形成膜の複素屈折率および膜厚を設定した後には、その設定に従いつつ反射多層膜基板11上に当該形成膜

を成膜することで、ハーフトーン型位相シフトマスクを構成すればよい。なお、形成膜の成膜については、周知技術を用いて行えばよいいため、ここではその説明を省略する。

つまり、反射多層膜基板11上に形成する第2領域12bを構成する
5 材料群の膜厚および複素屈折率の実部から当該第2領域12bにおける
反射多層膜基板11との位相差を求め、また第2領域12bを構成する
材料群の膜厚および複素屈折率の虚部から当該第2領域12bにおける
反射率を求め、これらから第1領域12a（反射多層膜基板11）と第
2領域12bにおける位相差が180°異なり、かつ、第2領域12bの
10 反射率が所望の値である構成、すなわち上述した構成のハーフトーン型
位相シフトマスクを得るのである。ただし、位相差と反射率は、どちら
を先に求めるようにしても構わない。

このような手順で得られるハーフトーン型位相シフトマスクを用いた
場合の光強度分布について説明する。第12図は、光学条件がNA =
15 0.25、 $\sigma = 0.70$ である場合に、マスク上 30nm（ウエハ上座標で表示、
4倍マスクでは 120nm）の開口部を具備するホールパターンにおける光
強度分布を示す説明図である。図例では、比較のため、従来のバイナリ
マスクに対する光強度分布も併せて示している。図例によれば、ハーフ
トーン型位相シフトマスクを用いた場合には、従来のバイナリマスクに
20 比べてパターンエッジコントラストが向上する効果が得られることが明
らかである。

なお、ここでは、ハーフトーン型位相シフトマスクとして、第1B図
に示した構成の位相シフトマスク10'、すなわち第2領域12bにのみバッファ膜13および吸収膜14が形成されたものを例に挙げたが、
25 例えば第1A図に示すようなハーフトーン型位相シフトマスク10を構
成することも可能である。ただし、その場合であっても、上述したよう

に、第1領域12aと第2領域12bとでは、 180° の位相差が生じる
ように、それぞれにおける形成膜の膜厚および複素屈折率が設定されて
いるものとする。

第13図は、ハーフトーン型位相シフトマスクの構成例の断面構造を
5 示す模式図である。図例のマスクでは、反射多層膜基板11上にて、第
1領域12aにはRu10nm、Si47nmが順に積層され、第2領域12
bにはRu5nm、TaN47nm、Ru5nmが順に積層されている。第1
領域12aの形成膜の構成材料にSiを用いたのは、以下に述べる理由
による。Siの複素屈折率は $0.99932-0.00182645i$ であり、その実部
10 は真空中の屈折率である1に極めて近く、またその虚部は他材料と比較
して小さい。したがって、Si材料には、その膜内多重干渉効果を利用
することにより、位相差および反射率比を調整する役割を担わせること
ができるからである。膜内多重干渉効果を利用することによって、第1
領域12aと第2領域12bとで 180° の位相差が生じ、しかもその上
15 面が完全に平坦なフラット構造のハーフトーン型位相シフトマスクを構
成することが可能となる。

〔第2の実施の形態〕

次に、位相シフトマスクの製造手順の第2の実施の形態について説明
する。第2の実施の形態では、本発明を適用してレベンソン型位相シフ
20 トマスクを構成する場合を例に挙げて説明する。第14図は、第2の実
施の形態における位相シフトマスクの製造手順を示すフローチャートで
ある。

第14図に示すように、レベンソン型位相シフトマスクの製造も、上
述した第1の実施の形態におけるハーフトーン型位相シフトマスクの場
25 合（第2図参照）と略同様にして行う（S201～S208）。ただし、
レベンソン型位相シフトマスクは、第1領域12aと第2領域12bに

おける位相が 180° 異なるだけではなく、第 1 領域 1 2 a と第 2 領域 1 2 b における反射率が略等しい点で、ハーフトーン型位相シフトマスクとは異なる。つまり、レベンソン型位相シフトマスクを構成する場合には、①第 1 領域 1 2 a と第 2 領域 1 2 b とで反射率が略等しいこと、②

5 第 1 領域 1 2 a と第 2 領域 1 2 b との位相差が 180° であること、の 2 条件を満足しなければならない (S 208)。

これらの条件を満足するか否かの判定は、次のようにして行えばよい。

先ず、第 1 領域 1 2 a の反射率を R_1 、第 2 領域 1 2 b の反射率を R_2 と

した場合に、以下に示す (4) 式によって得られる反射率比 P を特定す

10 る。

$$P = (1 - R_1(\lambda) / R_2(\lambda)) \times 100 \text{ } (\%) \quad \dots \dots (4)$$

そして、特定した反射率比 P に対して、判定基準 1 : $|P| \leq 3.0\%$ を適用し、この判定基準 1 に合致していれば、上記①の条件を満足して

15 いると判定する。

また、上記②の条件については、第 1 の実施の形態で説明した (1) 式によって得られる $\psi(\lambda)$ に対して、判定基準 2 : $|\psi(\lambda)| \leq 6^\circ$ を適用する。そして、この判定基準 2 に合致していれば、上記②の条件を満足していると判定する。

20 このようにして得られるレベンソン型位相シフトマスクとしては、第 1 A 図に示した構成のもの、すなわち第 1 領域 1 2 a および第 2 領域 1 2 b のいずれにもバッファ膜 1 3 および吸収膜 1 4 が形成された構成のものが考えられる。

ここで、第 1 A 図に示す構成のレベンソン型位相シフトマスクの製造

25 手順について、具体例を挙げてさらに詳しく説明する。レベンソン型位

相シフトマスクを構成する場合にも、第1の実施の形態で説明したハーフトーン型位相シフトマスクの場合と同様に、先ず、任意の複素屈折率に対する等位相線および等反射率線を求める。第15図は、等位相線の一具体例を示す説明図である。図例の等位相線は、複素屈折率の虚部

5 (k) を 0.0100i に固定して求めている。

ところで、レベンソン型位相シフトマスクでは、第1領域12aの形成膜と反射多層膜基板11との位相差 $\psi_1(\lambda)$ が、以下に示す(5)式によって特定される。

$$\psi_1(\lambda) = \phi_1(\lambda) - \phi s(\lambda) + (4\pi h_1 \cos\theta)/\lambda \quad \dots \quad (5)$$

10

また、第2領域12bの形成膜と反射多層膜基板11との位相差 $\psi_2(\lambda)$ が、以下に示す(6)式によって特定される。

$$\psi_2(\lambda) = \phi_2(\lambda) - \phi s(\lambda) + (4\pi h_2 \cos\theta)/\lambda \quad \dots \quad (6)$$

15

したがって、第1領域12aと第2領域12bの位相差 $\psi(\lambda)$ は、以下に示す(7)式によって特定されることになる。

$$\psi(\lambda) = \psi_1(\lambda) - \psi_2(\lambda) \quad \dots \quad (7)$$

この(7)式によって特定される関係は、第15図に示したように、
20 等位相線の相対関係で表される。例えば、図中において、複素屈折率の実部が 0.94 であるような材料で、第1領域12aと第2領域12bの位相差が 180° であるためには、第1領域12aと第2領域12bの段差は 56nm であれば良いことがわかる(図中 [1] 参照)。また、複素

屈折率の実部が第1領域12aにおいて0.96、第2領域12bにおいて0.94であるような材料で、第1領域12aと第2領域12bの位相差が180°であるためには、第1領域12aと第2領域12bの段差は42nmであれば良いことがわかる（図中〔2〕参照）。一方、反射率を求める場合は、相対値ではなくトータル膜厚に対する絶対値をそのまま用いる。

レベンソン型位相シフトマスクを構成する場合にも、このような等位相線（第15図参照）および等反射率線（第4図参照）を基に、判定基準1および判定基準2を満たすような形成膜の膜厚および複素屈折率を設定すればよい。

つまり、反射多層膜基板11上に形成する第1領域12aを構成する材料群の膜厚および複素屈折率の実部から第1領域12aにおける反射多層膜基板との位相差を求め、さらには反射多層膜基板11上に形成する第2領域12bを構成する材料群の膜厚および複素屈折率の実部から第2領域12bにおける反射多層膜基板との位相差を求める。また、反射多層膜基板11上に形成する第1領域12aを構成する材料群の膜厚および複素屈折率の虚部から第1領域12aにおける反射率を求め、さらには反射多層膜基板11上に形成する第2領域12bを構成する材料群の膜厚および複素屈折率の虚部から第2領域12bにおける反射率を求める。そして、これらの結果から、判定基準1および判定基準2を満たす構成、すなわち第1領域12aと第2領域12bにおける位相差が180°異なり、かつ、第1領域12aと第2領域12bの反射率が略等しい構成を、レベンソン型位相シフトマスクとして得るのである。なお、位相差と反射率は、どちらを先に求めるようにしても構わない。

ところで、判定基準1および判定基準2を同時に満たすためには、異なった材料を適切に積層して第1領域12aおよび第2領域12bの形

成膜を成膜する必要がある。これは、現実に存在する材料の複素屈折率の制約から、異なった材料を適切に積層しなければ、判定基準1および判定基準2を同時に満たすレベンソン型位相シフトマスクを現実に製造可能な構造として得ることができないからである。

5 このことから、第1領域12aを構成する材料としては、例えばTaN、RuおよびSiを用いる。また、第2領域12bを構成する材料としては、例えばMoおよびRuを用いる。これらの材料を用いるのは、例えばJpn. J. Appl. Phys. Vol40(2001)pp6998-7001の”Approach to patterning of extreme ultraviolet lithography masks”で
10 開示されているように、各材料のエッチング選択比を次に述べるように組み合わせにおいて非常に大きく取ることが公知だからである。すなわち、Si下地に対するRu層のエッチングをCl₂+O₂ガスによるドライエッチングで行う場合、Si下地はRuエッチングに対しエッティングストップとして作用する。Ru下地に対するTaN層のエッチングを
15 Ar+Cl₂ガスによるドライエッチングで行う場合、Ru下地はTaN層エッティングに対しエッティングストップとして作用する。また、Ru下地に対するMo層のエッティングおよびSi層のエッティングもAr+Cl₂ガスによるドライエッティングで行い選択比を大きく取る。なぜならば、Ruの塩化物RuCl₃は比較的安定な物質であり600℃以上で分解する。
20 一方、Siの塩化物SiCl₄の沸点は57.6℃、Moの塩化物MoCl₅の沸点は268℃、Taの塩化物TaCl₅の沸点は242℃であり、Ruの塩化物に対して真空中でエッティング反応ガスとして除去され易いためである。

25 第16図は、レベンソン型位相シフトマスクの構成例の断面構造を示す模式図である。図例の構造（以下「構造1」という）は、第15図の等位相線および第4図の等反射率線を基に設定された、判定基準1およ

び判定基準 2 を満たす構成である。第 1 領域 1 2 a では、反射多層膜基板 1 1 上に Ru 2 nm、Ta N 7 nm、Ru 4 nm の順に積層されて形成膜を構成している。第 1 領域 1 2 a のトータル膜厚は 11 nm、合成複素屈折率の実部は 0.9165 であり、虚部は 0.02507 i である。また、第 2 領域 1 2 b では、Ru 4 nm、Mo 49 nm、Ru 2 nm の順に積層されて形成膜を構成している。第 2 領域 1 2 b のトータル膜厚は 55 nm、合成複素屈折率の実部は 0.9174 であり、虚部は 0.00764 i である。なお、第 1 領域 1 2 a と第 2 領域 1 2 b との境界部分には、膜厚 120 nm の Ta N 吸収層が 40 nm 幅で形成されている。

このような構造 1において、第 1 5 図の等位相線から第 1 領域 1 2 a と第 2 領域 1 2 b の段差を求めるとき、90° と 270° の等位相線の関係から当該段差は 43 nm であり、同様に 180° と 0° の等位相線の関係から求めても 43 nm である。また、第 4 図の等透過率線によれば、第 1 領域 1 2 a の反射率は 0.39 であり、第 2 領域 1 2 b の反射率は 0.38 であることがわかる。そして、構造 1について、詳細に膜内多重干渉効果も含めて第 2 領域 1 2 b の Mo 膜厚を変化させて位相差と反射率比を求めるとき、例えば第 1 7 図に示す結果が得られる。図例の結果から、第 1 6 図に示した構造 1 は、各材料の膜厚調整範囲内において最適構成であることが確認できる。

また、構造 1において、反射率は、第 1 領域 1 2 a に対して 0.388 であり、第 2 領域 1 2 b に対して 0.387 であり、これらの間の反射率比は 0.258 % となる。また、第 1 領域 1 2 a と第 2 領域 1 2 b の位相差は、TE (transverse electric) 波に対して 178.8° 、TM (transverse magnetic) 波に対して 178.7° となる。

このような構造 1 のレベンソン型位相シフトマスクを用いた場合の光強度分布は、構造 1 の 4 倍マスク上に膜厚 120 nm の Ta N 吸収層を

40nm 幅（ウエハ上単位では 10nm）で形成してウエハ上に露光した場合に、NA = 0.25、 $\sigma = 0.70$ という光学条件であると、例えば第 18 図に示すような結果となる。

また、第 1 領域 1 2 a と第 2 領域 1 2 b の位相差が 180° であることは、40nm 幅の TaN 吸収層による 320nm ピッチ（ウエハ上単位では 10nm 幅で 80nm ピッチ）のパターンを用いて、以下に示す（8）式の位相差を求めることで確認できる。なお、（8）式では、ウエハ上における座標を用いている。x 軸の単位は nm である。

$$\phi = I(x+80) - I(x) \quad (0 \leq x \leq 80) \quad \dots \quad (8)$$

10

この（8）式を TEy 波、TMx 波および TMy 波に対してマスク直上において求めた結果を第 19 図に示す。図例によれば、TEy 波および TMx 波とともに、180° の位相差を良好に保持している。一方、TMy 波は、180° からのずれがより顕著ではあるが、転写に及ぼす寄与は 15 0.45% 程度であるため、ほとんど影響を与えない。

これらのことから、構造 1 のレベンソン型位相シフトマスクは、判定基準 1 および判定基準 2 を同時に満たしており、第 1 領域 1 2 a と第 2 領域 1 2 b とで反射率が略等しく、その位相差が 180° であると言える。

次いで、このように複素屈折率および膜厚が設定された第 1 領域 1 2 a の形成膜および第 2 領域 1 2 b の形成膜を、反射多層膜基板 1 1 上に成膜する場合の手順について簡単に説明する。第 20 図～第 23 図は、構造 1 の成膜手順の一例を示す説明図である。構造 1 による形成膜を成膜する場合には、第 20 図に示すように、先ず、反射多層膜基板 1 1 上に Ru 層をスパッタ法により成膜する（工程 1）。Ru 層は、通常、バ 25 イナリマスクでバッファ層として用いられる材料であるので、その通常

の場合と同じ製造装置を用いることができる。そして、Ru層上に、TaN層をスパッタ法により成膜する（工程2）。TaN層は、バイナリマスクで吸収層として用いられる材料であるので、その通常の場合と同じ製造装置を用いることができる。

5 その後は、TaN層上にレジストを塗布し（工程3）、描画およびレジスト現像工程を経て、第2領域12bの部分のレジストを除去する（工程4）。レジスト除去後は、第2領域12bの部分のTaN層をAr+Cl₂ガスによるドライエッチングによって除去する（工程5）。このTaN層の下のRu層はエッチングストップ層として機能することになる。そして、レジストを剥離し（工程6）、再びRu層をスパッタ成膜した後に（工程7）、今度はMo層をスパッタ成膜する（工程8）。
10 Mo層は、反射多層膜基板11の構成材料であるので、多層膜用製造装置を用いることができる。

Mo層を成膜すると、続いて、第21図に示すように、レジストを塗布した後に（工程9）、描画およびレジスト現像工程を経て、第1領域12aの部分のレジストを除去する（工程10）。そして、第1領域12aの部分のMo層をAr+Cl₂ガスによるドライエッチングにより除去する（工程11）。このMo層の下のRu層はエッチングストップ層として機能することになる。その後は、レジストを剥離し（工程12）、再びRu層をスパッタ成膜する（工程13）。

Ru層を成膜した後は、次いで、第22図に示すように、TaN吸収層をスパッタ成膜し（工程14）、さらにレジストを塗布する（工程15）。そして、描画およびレジスト現像工程を経て、吸収層として残す部分以外のレジストを除去する（工程16）。

25 その後、第23図に示すように、TaN吸収層をAr+Cl₂ガスによるドライエッチングにより除去する（工程17）。このTaN吸収層の下

のRu層はエッチングストップ層として機能することになる。そして、レジストを剥離すれば（工程18）、Ru層をエッチングストップ層として有効に用いつつ、構造1のレベンソン型位相シフトマスクを構成することができる。

5 第24図は、レベンソン型位相シフトマスクの他の構成例の断面構造を示す模式図である。図例の構造（以下「構造2」という）も、上述した構造1と同様に、第15図の等位相線および第4図の等反射率線を基に設定された、判定基準1および判定基準2を満たす構成である。第1領域12aでは、反射多層膜基板11上にRu3nm、TaN5nm、Ru
10 7nmの順に積層されて形成膜を構成している。第1領域12aのトータル膜厚は15nm、合成複素屈折率の実部は0.9054であり、虚部は0.02217iである。また、第2領域12bでは、Ru3nm、Mo49nm、Ru4nmの順に積層されて形成膜を構成している。第2領域12bのトータル膜厚は56nm、合成複素屈折率の実部は0.9169であり、虚部
15 は0.00782iである。

このような構造2において、第15図の等位相線から第1領域12aと第2領域12bの段差を求めると、90°と270°の等位相線の関係から当該段差は44nmであり、同様に180°と0°の等位相線の関係から求めても44nmである。また、第4図の等透過率線によれば、第1領域12aの反射率は0.38であり、第2領域12bの反射率は0.36であることがわかる。そして、構造2について、詳細に膜内多重干渉効果も含めて第2領域12bのMo膜厚を変化させて位相差と反射率比を求めると、例えば第25図に示す結果が得られる。図例の結果から、第24図に示した構造2は、各材料の膜厚調整範囲内において最適構成である
25 ことが確認できる。

また、構造 2において、反射率は、第1領域 1 2 aに対して 0.399 であり、第2領域 1 2 bに対して 0.396 であり、これらの間の反射率比は 0.710% となる。したがって、第1領域 1 2 aと第2領域 1 2 bの位相差は、T E 波に対して 178.2°、T M 波に対して 178.3° となる。

5 このような構造 2 のレベンソン型位相シフトマスクを用いた場合の光強度分布は、構造 2 の4倍マスク上に膜厚 120nm のT a N 吸収層を 40nm 幅（ウエハ上単位では 10nm）で形成してウエハ上に露光した場合に、 $NA = 0.25$ 、 $\sigma = 0.70$ という光学条件であると、例えば第 2 6 図に示すような結果となる。

10 また、第1領域 1 2 aと第2領域 1 2 bの位相差が 180° であることは、40nm 幅のT a N 吸収層による 320nm ピッチ（ウエハ上単位では 10nm 幅で 80nm ピッチ）のパターンを用いて、上述した（8）式の位相差を求めることがで確認できる。この（8）式を T E y 波、T M x 波および T M z 波に対してマスク直上において求めた結果を第 2 7 図に示す。 15 図例によれば、T E y 波および T M x 波とともに、180° の位相差を良好に保持している。一方、T M z 波は、180° からのずれがより顕著ではあるが、転写に及ぼす寄与は 0.45% 程度であるため、ほとんど影響を与えない。

20 このように複素屈折率および膜厚が設定された構造 2 の成膜手順については、上述した構造 1 の場合と略同様である。構造 1 の場合とは、工程 5 と工程 6 との間に、第2領域 1 2 b の部分の R u 層を Cl₂+O₂ ガスによるドライエッチングにより除去する工程が追加される点で異なる。

25 第 2 8 図は、レベンソン型位相シフトマスクのさらに他の構成例の断面構造を示す模式図である。図例の構造（以下「構造 3」という）も、上述した構造 1 および構造 2 と同様に、第 1 3 図の等位相線および第 4 図の等反射率線を基に設定された、判定基準 1 および判定基準 2 を満た

す構成である。第1領域12aでは、反射多層膜基板11上にRu5nm、TaN20nm、Si8nm、Ru5nmの順に積層されて形成膜を構成している。また、第2領域12bでは、Ru5nm、Si8nm、Ru43.5nmの順に積層されて形成膜を構成している。

5 この構造3では、構造1または構造2の場合とは異なり、第1領域12aおよび第2領域12bの形成膜の構成材料にSiを用いている。ここで、Siの複素屈折率は、 $0.99932-0.00182645i$ であり、複素屈折率の実部は真空中の屈折率である1に極めて近く、また複素屈折率の虚部は他材料と比較して小さい。そのため、Si材料は、膜内多重干渉効10 果の利用により、位相差および反射率比を調整する役割を担うことになる。

したがって、第15図の等位相線および第4図の等反射率線から判定基準1および判定基準2を満たす構成を得る場合には、Si層を考慮せずに、位相差を重点的に合わせ込む条件を抽出し、その後にSi層の膜15 内多重干渉により反射率を合わせ込むとともに、位相差を 180° 近くに調整する手順を探る、といったことが可能となる。すなわち、判定基準1および判定基準2を満たす構成は、第1領域12aに対しては反射多層膜基板11上にRu5nm、TaN20nm、Ru5nmの順に積層したものと考え、第2領域12bに対してはRu5nm、Ru43.5nmの順に積20 層したものと考える。この場合の第1領域12aのトータル膜厚は30nm、合成複素屈折率の実部は0.9234であり、虚部は0.02687iである。第2領域12bのトータル膜厚は48.5nm、合成複素屈折率の実部は0.8875であり、虚部は0.01747iである。

このような構造3において、第15図の等位相線から第1領域12aと第2領域12bの段差を求めるとき、 90° と 270° の等位相線の関係から当該段差は22nmであり、同様に 180° と 0° の等位相線の関係から25

求めると 16nm である。また、第 4 図の等透過率線によれば、第 1 領域 12a の反射率は 0.14 であり、第 2 領域 12b の反射率は 0.18 であることがわかる。そして、構造 3 について、詳細に膜内多重干渉効果も含めて第 2 領域 12b の Mo 膜厚を変化させて位相差と反射率比を求める 5 と、例えば第 29 図に示す結果が得られる。図例の結果から、第 28 図に示した構造 3 は、各材料の膜厚調整範囲内において最適構成であることが確認できる。この構造 3 では、第 1 領域 12a および第 2 領域 12b の形成膜の構成材料に Si を用いており、その Si 層による膜内多重干渉を効果的に利用していることから、位相差と反射率比が基準値を 10 満たすことになる条件を実現することができる。

また、構造 3において、反射率は、第 1 領域 12a に対して 0.195 であり、第 2 領域 12b に対して 0.200 であり、これらの間の反射率比は 2.41% となる。したがって、第 1 領域 12a と第 2 領域 12b の位相差は、TE 波に対して 185.3°、TM 波に対して 185.1° となる。 15 このような構造 3 のレベンソン型位相シフトマスクを用いた場合の光強度分布は、構造 3 の 4 倍マスク上に膜厚 120nm の TaN 吸収層を 40nm 幅（ウエハ上単位では 10nm）で形成してウエハ上に露光した場合に、NA = 0.25、σ = 0.70 という光学条件であると、例えば第 30 図に示すような結果となる。

また、第 1 領域 12a と第 2 領域 12b の位相差が 180° であることは、40nm 幅の TaN 吸収層による 320nm ピッチ（ウエハ上単位では 10nm 幅で 80nm ピッチ）のパターンを用いて、上述した（8）式の位相差を求ることで確認できる。この（8）式を TEy 波、TMx 波および TMy 波に対してマスク直上において求めた結果を第 31 図に示す。 20 図例によれば、TEy 波および TMx 波とともに、180° の位相差を良好に保持している。一方、TMy 波は、180° からのずれがより顕著では

あるが、転写に及ぼす寄与は 0.45% 程度であるため、ほとんど影響を与えない。

5 このように複素屈折率および膜厚が設定された構造 3 の成膜手順についても、上述した構造 2 の場合と略同様である。構造 2 の場合とは、工程 8 にて、M₀層に代わって S_i層および R_u層をスパッタ成膜する点で異なる。

10 ところで、構造 1 ~ 3 では、いずれも、第 1 領域 12a の形成膜と第 2 領域 12b の形成膜とに膜厚差があり、それぞれの間に段差が生じている。このような構成であっても、上述したように位相シフトの効果を得ることが可能である。ただし、第 1 領域 12a と第 2 領域 12b との境界部分に TaN 吸收層を形成することを考慮すると、その加工の容易さの点で、第 1 領域 12a と第 2 領域 12b との間に段差がなく、平坦に形成されているほうが望ましい。そこで、以下に、第 1 領域 12a と第 2 領域 12b とが平坦である構成の具体例について説明する。

15 第 32 図は、レベンソン型位相シフトマスクの平坦な構成例の断面構造を示す模式図である。図例の構造（以下「構造 4」という）は、第 15 図の等位相線および第 4 図の等反射率線を基に設定された、判定基準 1 および判定基準 2 を満たす構成である。第 1 領域 12a では、反射多層膜基板 11 上に R_u 3 nm、TaN 7 nm、R_u 6 nm、S_i 37 nm、R_u 20 5 nm の順に積層されて形成膜を構成している。また、第 2 領域 12b では、R_u 3 nm、M₀ 47 nm、R_u 8 nm の順に積層されて形成膜を構成している。

25 この構造 4において、第 1 領域 12a の形成膜の構成材料に S_i を用いているのは、構造 3 の場合と同様に、膜内多重干渉効果の利用により位相差および反射率比を調整する役割を担わせるためである。したがって、第 15 図の等位相線および第 4 図の等反射率線から判定基準 1 およ

び判定基準 2 を満たす構成を得る場合には、S i 層を考慮せずに、位相差を重点的に合わせ込む条件を抽出し、その後に S i 層の膜内多重干渉により反射率を合わせ込むとともに、位相差を 180° 近くに調整する手順を探る、といったことが可能となる。すなわち、判定基準 1 および判定基準 2 を満たす構成は、第 1 領域 1 2 a に対しては反射多層膜基板 1 1 上に Ru 3 nm、Ta N 7 nm、Ru 6 nm、Ru 5 nm の順に積層したものと考え、第 2 領域 1 2 b に対しては Ru 3 nm、Mo 47 nm、Ru 8 nm の順に積層したものと考える。この場合の第 1 領域 1 2 a のトータル膜厚は 21 nm、合成複素屈折率の実部は 0.9054 であり、虚部は 0.03631 i である。第 2 領域 1 2 b のトータル膜厚は 58 nm、合成複素屈折率の実部は 0.9147 であり、虚部は 0.000904 i である。

このような構造 4において、第 1 5 図の等位相線から第 1 領域 1 2 a と第 2 領域 1 2 b の段差を求めるに、 90° と 270° の等位相線の関係から当該段差は 40 nm であり、同様に 180° と 0° の等位相線の関係から求めると 43 nm である。また、第 4 図の等透過率線によれば、第 1 領域 1 2 a の反射率は 0.15 であり、第 2 領域 1 2 b の反射率は 0.30 であることがわかる。

このように、構造 4 では、S i 層を考慮しないと、構造 1 および構造 2 に類似しているものの、第 1 領域 1 2 a と第 2 領域 1 2 b とで反射率が一致しない。これを解消するために、構造 4 では、S i 層を挿入し、膜内多重干渉を効果的に利用することで、第 1 領域 1 2 a と第 2 領域 1 2 b における反射率を一致させているのである。

そのために、構造 4においては、第 1 領域 1 2 a の Ta N 層の膜厚、第 2 領域 1 2 b の Mo 層の膜厚、および第 1 領域 1 2 a の S i 層の膜厚を適宜変化させ、判定基準 1 および判定基準 2 を満たす構成を求める。

第 3 3 図は、Ta N 層の膜厚および S i 層の膜厚を一定とし Mo 層の膜

厚をパラメータとして位相差および反射率比を求めた結果である。図例の結果から、第32図に示した構造4は、第1領域12aと第2領域12bの膜厚差が0nmとなる条件で判定基準を満たす構成であることが確認できる。この構造4では、第1領域12aの形成膜の構成材料にSiを用いており、そのSi層による膜内多重干渉を効果的に利用していることから、位相差と反射率比が基準値を満たし、かつ、第1領域12aと第2領域12bとが平坦になる構成を実現することができる。5

また、構造4において、反射率は、第1領域12aに対して0.285であり、第2領域12bに対して0.287であり、これらの間の反射率比は0.65%となる。したがって、第1領域12aと第2領域12bの位相差は、TE波に対して180.8°、TM波に対して180.5°となる。10

このような構造4のレベンソン型位相シフトマスクを用いた場合の光強度分布は、構造4の4倍マスク上に膜厚120nmのTaN吸収層を40nm幅（ウエハ上単位では10nm）で形成してウエハ上に露光した場合に、NA=0.25、σ=0.70という光学条件であると、例えば第34図に示すような結果となる。15

また、第1領域12aと第2領域12bの位相差が180°であることは、40nm幅のTaN吸収層による320nmピッチ（ウエハ上単位では10nm幅で80nmピッチ）のパターンを用いて、上述した（8）式の位相差を求ることで確認できる。この（8）式をTEy波、TMx波およびTMz波に対してマスク直上において求めた結果を第35図に示す。20

図例によれば、TEy波およびTMx波とともに、180°の位相差を良好に保持している。一方、TMz波は、180°からのずれがより顕著ではあるが、転写に及ぼす寄与は0.45%程度であるため、ほとんど影響を与えない。25

5 このように複素屈折率および膜厚が設定された構造4の成膜手順については、上述した構造1の場合（第20図～第23図参照）に加えて、構造2の場合と同様に工程5と工程6との間に第2領域12bの部分のRu層をCl₂+O₂ガスによるドライエッチングにより除去する工程を行うとともに、工程13と工程14との間に第36図、第37図に示すような工程を行えばよい。

すなわち、第36図に示すように、工程13にてRu層を成膜した後は、次いで、Si層をスパッタ成膜し（工程13-1）、さらにレジストを塗布する（工程13-2）。そして、描画およびレジスト現像工程10を経て、第2領域12bの部分のレジストを除去する（工程13-3）。

その後、第37図に示すように、第2領域12bの部分のSi膜をAr+Cl₂ガスによるドライエッチングにより除去する（工程13-4）。このSi層の下のRu層はエッチングストッパ層として機能することになる。そして、レジストを剥離して（工程13-5）、Ru層をスパッタ成膜した後は（工程13-6）、TaN吸収層をスパッタ成膜し（工程14）、それ以降、構造1の場合と同様の処理を行う。このような成膜手順によって、構造4のレベンソン型位相シフトマスクを構成することができる。

20 以上のように、構造4については、第1領域12aのTaN層の膜厚、第2領域12bのMo層の膜厚、および第1領域12aのSi層の膜厚を適宜変化させ、判定基準1および判定基準2を満たし、かつ、第1領域12aと第2領域12bとが平坦である構成を特定している。ただし、このような構成は、以下に述べるような構造においても得ることができる。

25 第38図は、レベンソン型位相シフトマスクの他の平坦な構成例の断面構造を示す模式図である。図例の構造（以下「構造5」という）も、

TaN層の膜厚およびSi層の膜厚を一定にしてMo層の膜厚をパラメータとして位相差および反射率比を求めた結果である。第39図は、TaN層の膜厚およびSi層の膜厚を一定としMo層の膜厚をパラメータとして位相差および反射率比を求めた結果である。図例の結果から、構造5についても、第1領域12aと第2領域12bの膜厚差が0nmとなる条件で判定基準を満たす構成であることが確認できる。この構造5において、反射率は、第1領域12aに対して0.288であり、第2領域12bに対して0.287であり、これらの間の反射率比は0.36%である。また、第1領域12aと第2領域12bの位相差は、TE波に対して181.4°、TM波に対して181.1°である。

このような構造5のレベンソン型位相シフトマスクを用いた場合の光強度分布は、構造5の4倍マスク上に膜厚120nmのTaN吸収層を40nm幅（ウエハ上単位では10nm）で形成してウエハ上に露光した場合に、NA=0.25、 $\sigma=0.70$ という光学条件であると、例えば第40図に示すような結果となる。

また、第1領域12aと第2領域12bの位相差が180°であることは、40nm幅のTaN吸収層による320nmピッチ（ウエハ上単位では10nm幅で80nmピッチ）のパターンを用いて、上述した（8）式の位相差を求ることで確認できる。この（8）式をTEy波、TMx波およびTMz波に対してマスク直上において求めた結果を第41図に示す。図例によれば、TEy波およびTMx波とともに、180°の位相差を良好に保持している。一方、TMz波は、180°からのずれがより顕著ではあるが、転写に及ぼす寄与は0.45%程度であるため、ほとんど影響を与えない。

このような構造5の成膜手順については、上述した構造4の場合と同様である。

第42図は、レベンソン型位相シフトマスクのさらに他の平坦な構成例の断面構造を示す模式図である。図例の構造（以下「構造6」という）も、TaN層の膜厚およびSi層の膜厚を一定にしてMo層の膜厚をパラメータとして位相差および反射率比を求めた結果である。第43図は、TaN層の膜厚およびSi層の膜厚を一定としMo層の膜厚をパラメータとして位相差および反射率比を求めた結果である。図例の結果から、構造6についても、第1領域12aと第2領域12bの膜厚差が0nmとなる条件で判定基準を満たす構成であることが確認できる。この構造6において、反射率は、第1領域12aに対して0.300であり、第2領域12bに対して0.287であり、これらの間の反射率比は0.90%である。また、第1領域12aと第2領域12bの位相差は、TE波に対して180.6°、TM波に対して180.3°である。

このような構造6のレベンソン型位相シフトマスクを用いた場合の光強度分布は、構造6の4倍マスク上に膜厚120nmのTaN吸収層を40nm幅（ウエハ上単位では10nm）で形成してウエハ上に露光した場合に、NA=0.25、 $\sigma=0.70$ という光学条件であると、例えば第44図に示すような結果となる。

また、第1領域12aと第2領域12bの位相差が180°であることは、40nm幅のTaN吸収層による320nmピッチ（ウエハ上単位では10nm幅で80nmピッチ）のパターンを用いて、上述した（8）式の位相差を求ることで確認できる。この（8）式をTEy波、TMx波およびTMz波に対してマスク直上において求めた結果を第45図に示す。図例によれば、TEy波およびTMx波とともに、180°の位相差を良好に保持している。一方、TMz波は、180°からのずれがより顕著ではあるが、転写に及ぼす寄与は0.45%程度であるため、ほとんど影響を与えない。

このような構造 6 の成膜手順についても、上述した構造 4 または構造 5 の場合と同様である。

次に、以上のようなレベンソン型位相シフトマスクにおける効果を、従来の位相シフト効果を用いないバイナリマスクとの比較において説明する。第 4 6 図は、上述した構造 5 のレベンソン型位相シフトマスクについて、構造 5 の 4 倍マスク上に膜厚 120nm の TaN 吸収層を 40nm 幅、30nm 幅、20nm 幅、10nm 幅、0nm 幅（ウエハ上単位では 10nm、7.5nm、5nm、2.5nm、0nm）で形成してウエハ上に露光した場合に、NA = 0.25、 $\sigma = 0.70$ という光学条件で得られた光強度分布を示す説明図である。図例によれば、いずれの TaN 吸収層幅においても、良好なパターンコントラストが得られることがわかる。

これに対して、第 4 7 図は、従来のバイナリマスクについて、そのマスク上に膜厚 120nm の TaN 吸収層を 40nm 幅、30nm 幅、20nm 幅、10nm 幅（ウエハ上単位では 10nm、7.5nm、5nm、2.5nm）で形成してウエハ上に露光した場合に、NA = 0.25、 $\sigma = 0.70$ という光学条件で得られた光強度分布を示す説明図である。図例によれば、TaN 吸収層幅が小さくなるに伴って、パターンコントラストが著しく低下することがわかる。

これらのことから、上述した構造のレベンソン型位相シフトマスクを用いた場合には、TaN 吸収層 10nm 幅（ウエハ上単位では 2.5nm）においてウエハ上で 15nm またはこれ以下のサイズの線幅の転写を行うことが可能となる、といった顕著な効果が得られると言える。さらには、例えば第 4 8 図に示すように、NA = 0.30 の光学条件で露光すれば、TaN 吸収層 10nm 幅（ウエハ上単位では 2.5nm）においてウエハ上で 10nm またはこれ以下のサイズの線幅の転写を行うことが可能になる、といった顕著な効果も得られるようになる。

以上のように、本実施形態（第1および第2の実施の形態）にて説明した位相シフトマスクでは、第1領域12aおよび第2領域12bの形成膜の膜厚および複素屈折率が、それぞれでの極短紫外光の反射光に所定の位相差が生じるように設定されている。さらに詳しくは、位相シフトマスクを構成するのにあたり、先ず、反射多層膜基板11上の形成膜（特に、その構成材料における複素屈折率）に依存することなく、任意の複素屈折率および膜厚について当該複素屈折率および当該膜厚から得られる反射光の位相および反射率を特定し、その特定した位相および反射率に基づいて、第1領域12aと第2領域12bで180°の位相差が生じるように、それぞれにおける形成膜の膜厚および複素屈折率が選定されている。

したがって、本実施形態で説明した位相シフトマスクによれば、極短紫外光に対応する反射型マスクの場合であっても、超解像技術を用いるための位相シフトマスクを構成することが実現可能となる。すなわち、本実施形態で説明した位相シフトマスクの製造方法を用いれば、極短紫外光の位相シフトマスクを構成することができる。

本実施形態では露光光として極短紫外光を使用した場合を例にとり、説明してきたが、露光光は極短紫外光に限らず、X線、放射線、紫外線、又は、可視光であってもよい。これらの露光光によっても、反射型マスクの超解像技術を用いるための位相シフトマスクを構成することが実現可能となる。すなわち、本実施形態で説明した位相シフトマスクの製造方法を用いれば、極短紫外光の位相シフトマスクを構成することができる。

しかも、本実施形態で説明した位相シフトマスクでは、単に極短紫外光を用いるだけではなく、超解像技術をも利用することで、ウエハ上のパターンコントラストを著しく増大させ、従来のバイナリマスクでは得

られなかった解像性を得ることができる。つまり、本実施形態の位相シフトマスクを用いて半導体装置を製造すれば、従来のバイナリマスクを用いた場合よりもより微細なホールパターン、スペースパターンおよびラインパターンを得ることができ、パターンの極小化への対応に非常に
5 好適となる。

また、本実施形態で説明した位相シフトマスクでは、膜内多重干渉を効果的に利用することで、第1領域12aと第2領域12bとで形成膜の膜厚を略等しくして、これら第1領域12aと第2領域12bとが平坦になる構成を実現している。したがって、例えばレベンソン型位相シ
10 フトマスクにおいて第1領域12aと第2領域12bとの境界部分にTaN吸収層を形成する場合であっても、平坦部分にその形成を行えばよいため、加工が非常に容易なものとなり、またその形成精度の確保も容易となる。

また、本実施形態で説明した位相シフトマスクでは、第1領域12aの形成膜および第2領域12bの形成膜の両方またはいずれか一方が、複数の材料からなる積層構造を有している。したがって、任意の複素屈折率および膜厚について当該複素屈折率および当該膜厚から得られる反射光の位相および反射率を特定しても、その任意の複素屈折率および膜厚に対応する形成膜を得ることが可能となる。つまり、複数の材料から
20 なる積層構造を用いることによって、所望する位相シフトマスクを構成することが可能となるのである。

以上に説明したように、本発明に係る露光光の位相シフトマスクおよびその製造方法によれば、適切な屈折率と吸収係数の組み合わせを得ることで、露光光に対応する反射型マスクの場合であっても、超解像技術
25 を用いるための位相シフトマスクを構成することが実現可能となる。ま

た、本発明に係る半導体装置の製造方法によれば、パターンの極小化への対応に非常に好適となる。

特に露光光に極短紫外光を用いた場合に必要となる反射型マスクの超解像技術を用いるための位相シフトマスクを構成することが実現可能となる。すなわち、本実施形態で説明した位相シフトマスクの製造方法を用いれば、極短紫外光の位相シフトマスクを構成することができる。

請求の範囲

1. 露光光を反射して被露光体上に所望パターンを転写するために用いられる露光光の位相シフトマスクであって、

5 露光光を反射する反射多層膜基板と、当該反射多層膜基板上に形成された第1領域および第2領域とを具備するとともに、

前記第1領域の形成膜および前記第2領域の形成膜における各膜厚および各複素屈折率が、前記第1領域での露光光の反射光と前記第2領域での露光光の反射光とで所定の位相差が生じるように設定されている

10 ことを特徴とする露光光の位相シフトマスク。

2. 前記露光光は極短紫外光、X線、放射線、紫外線、又は、可視光であることを特徴とする請求の範囲第1項記載の露光光の位相シフトマスク。

3. 前記所定の位相差に加えて、前記第1領域での露光光の反射率と
15 前記第2領域での露光光の反射率とが略等しくなるように、前記第1領域の形成膜および前記第2領域の形成膜における各膜厚および各複素屈折率が設定されていることを特徴とする請求の範囲第1項記載の露光光の位相シフトマスク。

4. 前記第1領域の形成膜および前記第2領域の形成膜の膜厚が互い
20 に略等しくなるように構成されていることを特徴とする請求の範囲第1項記載の露光光の位相シフトマスク。

5. 前記第1領域の形成膜および前記第2領域の形成膜の両方または
いずれか一方は、複数の材料からなる積層構造を有していることを特徴
とする請求の範囲第1項記載の露光光の位相シフトマスク。

6. 前記第1領域の形成膜および前記第2領域の形成膜における各膜厚および各複素屈折率は、等位相線及び等反射率線を用いて設定されたことを特徴とする請求の範囲第3項記載の露光光の位相シフトマスク。

7. 前記等位相線は、前記複素屈折率の虚部を固定して求めることを特徴とする請求の範囲第6項記載の露光光の位相シフトマスク。

8. 前記位相シフトマスクは、ハーフトーン型位相シフトマスク、又は、レベンソン型位相シフトマスクであることを特徴とする請求の範囲第1項記載の露光光の位相シフトマスク。

9. 露光光を反射する反射多層膜基板と、当該反射多層膜基板上に形成された第1領域および第2領域とを具備してなる露光光の位相シフトマスクの製造方法であって、

前記露光光に対する任意の複素屈折率と、前記反射多層膜基板上に形成する膜の任意の膜厚とについて、当該複素屈折率および当該膜厚から得られる前記露光光の反射光の位相および反射率を特定し、

15 特定した位相および反射率に基づいて、前記第1領域での露光光の反射光と前記第2領域での露光光の反射光とで所定の位相差が生じるよう、前記第1領域の形成膜および前記第2領域の形成膜における各膜厚および各複素屈折率を選定する

ことを特徴とする露光光の位相シフトマスクの製造方法。

20 10. 前記露光光は極短紫外光、X線、放射線、紫外線、又は、可視光であることを特徴とする請求の範囲第9項記載の露光光の位相シフトマスク。

11. 前記第1領域の形成膜および前記第2領域の形成膜の各膜厚の選定にあたり、膜内多重干渉に起因する位相差および反射率の膜厚に対する変動を考慮することを特徴とする請求の範囲第9項記載の露光光の位相シフトマスクの製造方法。

12. 選定した複素屈折率および膜厚を、複数の材料からなる積層構造によって実現される合成複素屈折率および合計膜厚によって得ることを特徴とする請求の範囲第9項記載の露光光の位相シフトマスクの製造方法。

5 13. 前記第1領域の形成膜および前記第2領域の形成膜における各膜厚および各複素屈折率は、等位相線及び等反射率線を用いて設定されたことを特徴とする請求の範囲第9項記載の露光光の位相シフトマスクの製造方法。

14. 前記等位相線は、前記複素屈折率の虚部を固定して求めることを特徴とする請求の範囲第13項記載の露光光の位相シフトマスクの製造方法。

15. 前記位相シフトマスクは、ハーフトーン型位相シフトマスク、又は、レベンソン型位相シフトマスクであることを特徴とする請求の範囲第9項記載の露光光の位相シフトマスクの製造方法。

16. 露光光の位相シフトマスクを用いて被露光体上に所望パターンを転写するリソグラフィ工程を含む半導体装置の製造方法であって、

前記露光光に対する任意の複素屈折率と、前記反射多層膜基板上に形成する膜の任意の膜厚とについて、当該複素屈折率および当該膜厚から得られる前記露光光の反射光の位相および反射率を特定し、

20 特定した位相および反射率に基づいて、前記反射多層膜基板上の第1領域での露光光の反射光と前記反射多層膜基板上の第2領域での露光光の反射光とで所定の位相差が生じるように、前記第1領域の形成膜および前記第2領域の形成膜における各膜厚および各複素屈折率を選定し、選定した複素屈折率および膜厚にて前記第1領域の形成膜および前記第2領域の形成膜をそれぞれ前記反射多層膜基板上に形成して、前記反

射多層膜基板上に前記第1領域および前記第2領域を具備してなる露光光の位相シフトマスクを構成し、

構成した露光光の位相シフトマスクを用いて被露光体上に所望パターンを転写する

5 ことを特徴とする半導体装置の製造方法。

17. 前記露光光は極短紫外光、X線、放射線、紫外線、又は、可視光であることを特徴とする請求の範囲第16項記載の半導体装置の製造方法。

18. 前記第1領域の形成膜および前記第2領域の形成膜における各

10 膜厚および各複素屈折率は、等位相線及び等反射率線を用いて設定されたことを特徴とする請求の範囲第18項記載の半導体装置の製造方法。

19. 前記等位相線は、前記複素屈折率の虚部を固定して求めることを特徴とする請求の範囲第18項記載の半導体装置の製造方法。

20. 前記位相シフトマスクは、ハーフトーン型位相シフトマスク、

15 又は、レベンソン型位相シフトマスクであることを特徴とする請求の範囲第16項記載の半導体装置の製造方法。

Fig.1A

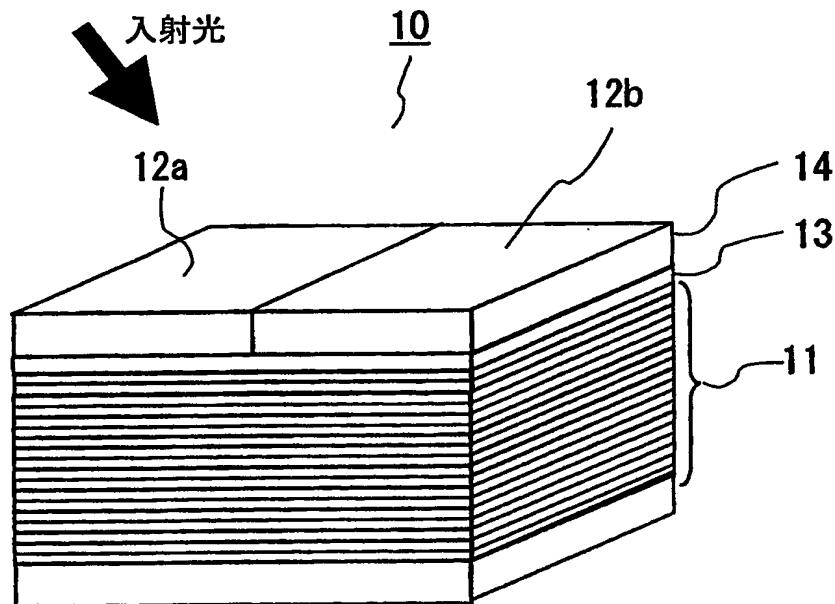
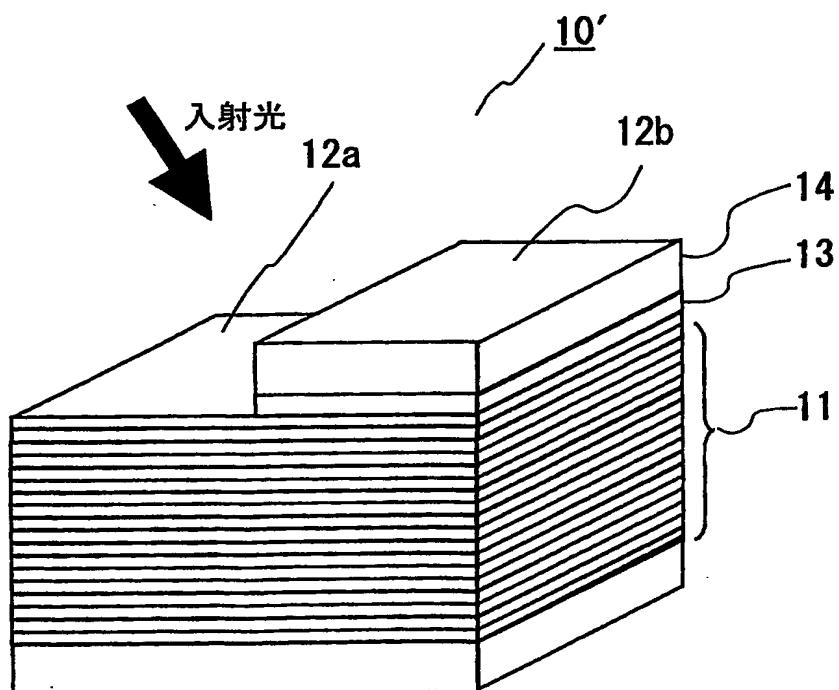


Fig.1B



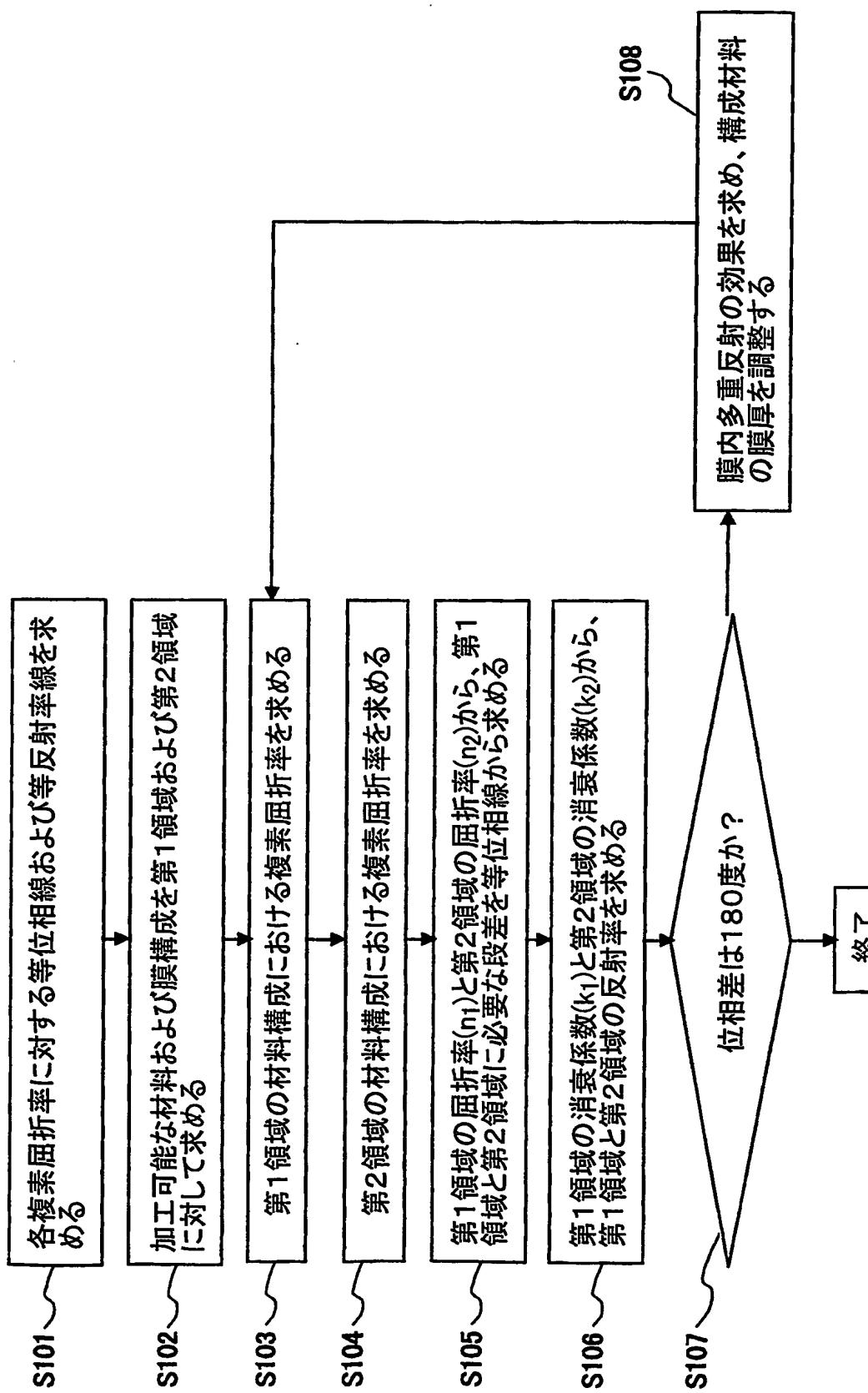


Fig.2

3/48

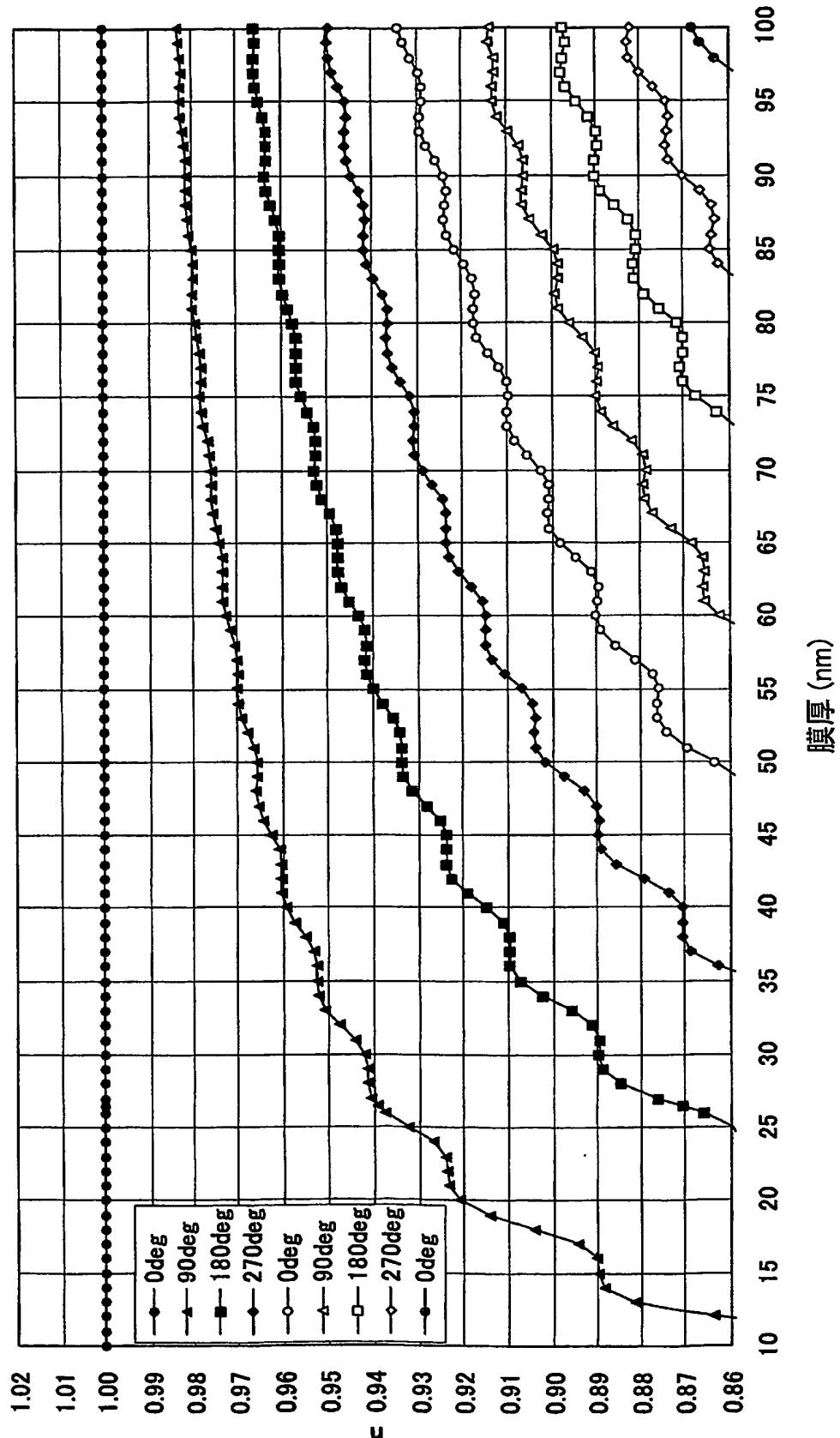


Fig.3

4/48

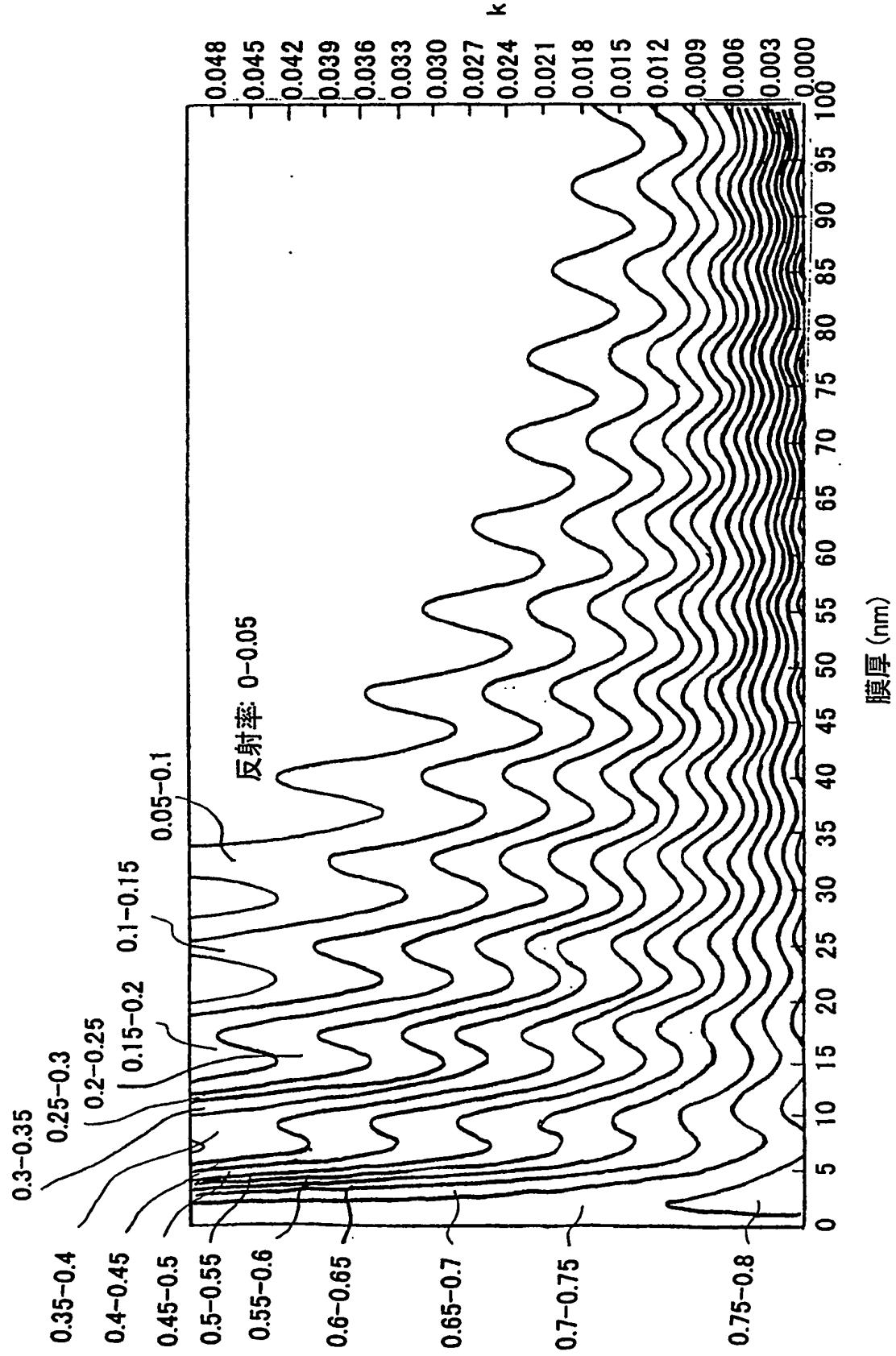
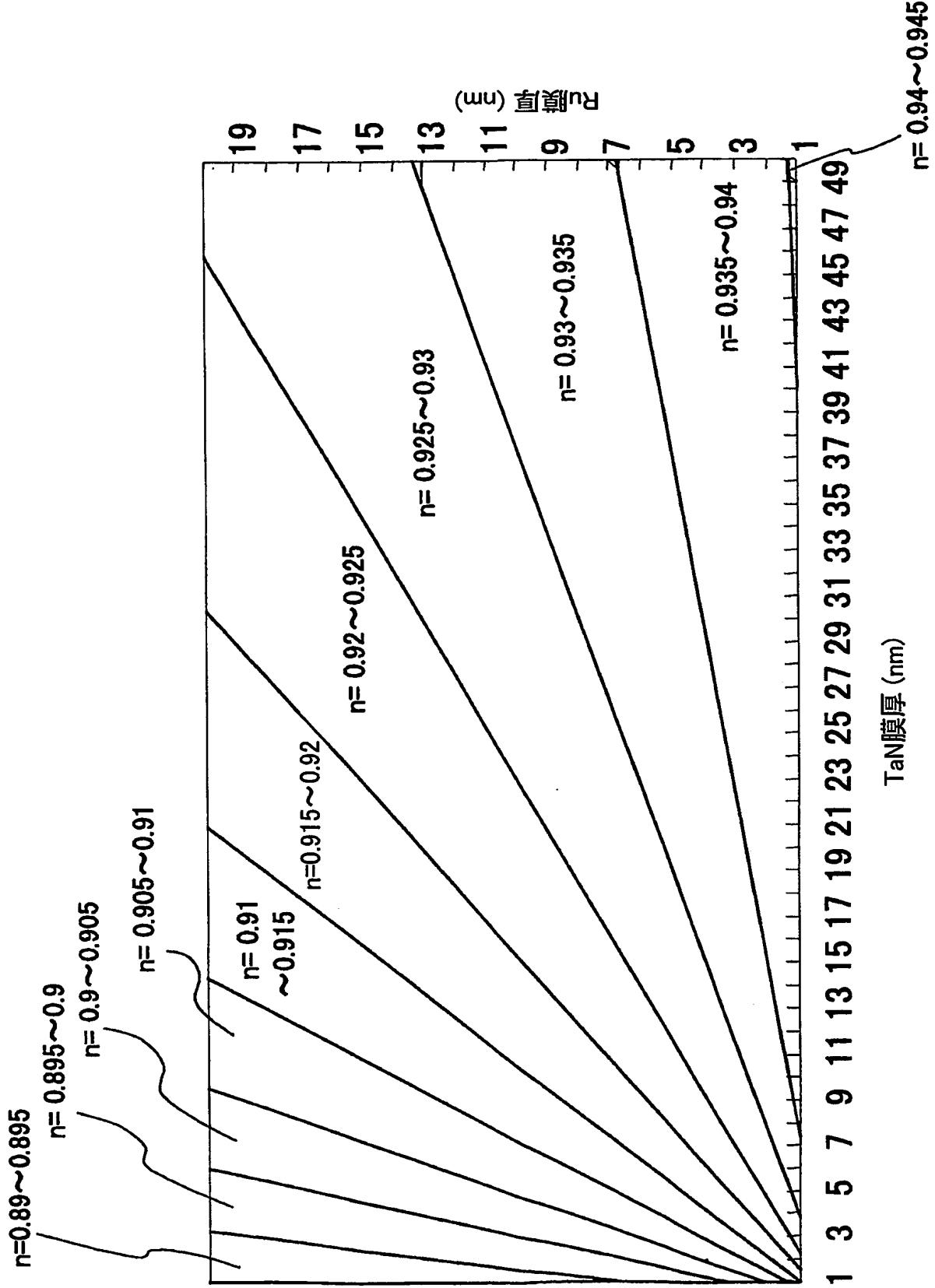


Fig.4



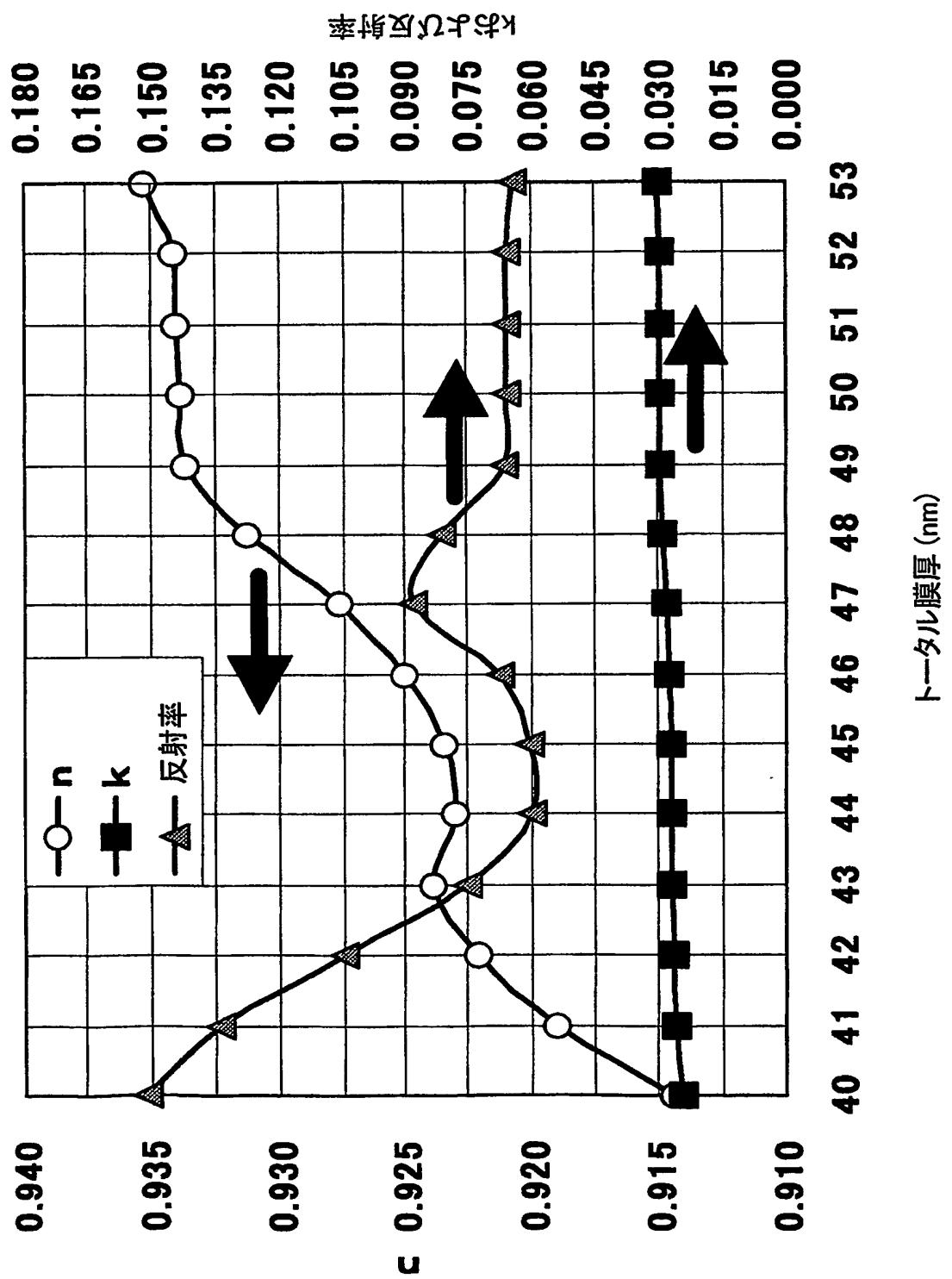


Fig.6

トータル厚 (nm)	Ru厚 (nm)	TaN厚 (nm)
40	20	20
41	17	24
42	15	27
43	14	29
44	15	29
45	15	30
46	14	32
47	12	35
48	9	39
49	7	42
50	7	43
51	7	44
52	7	45
53	6	47

Fig.7

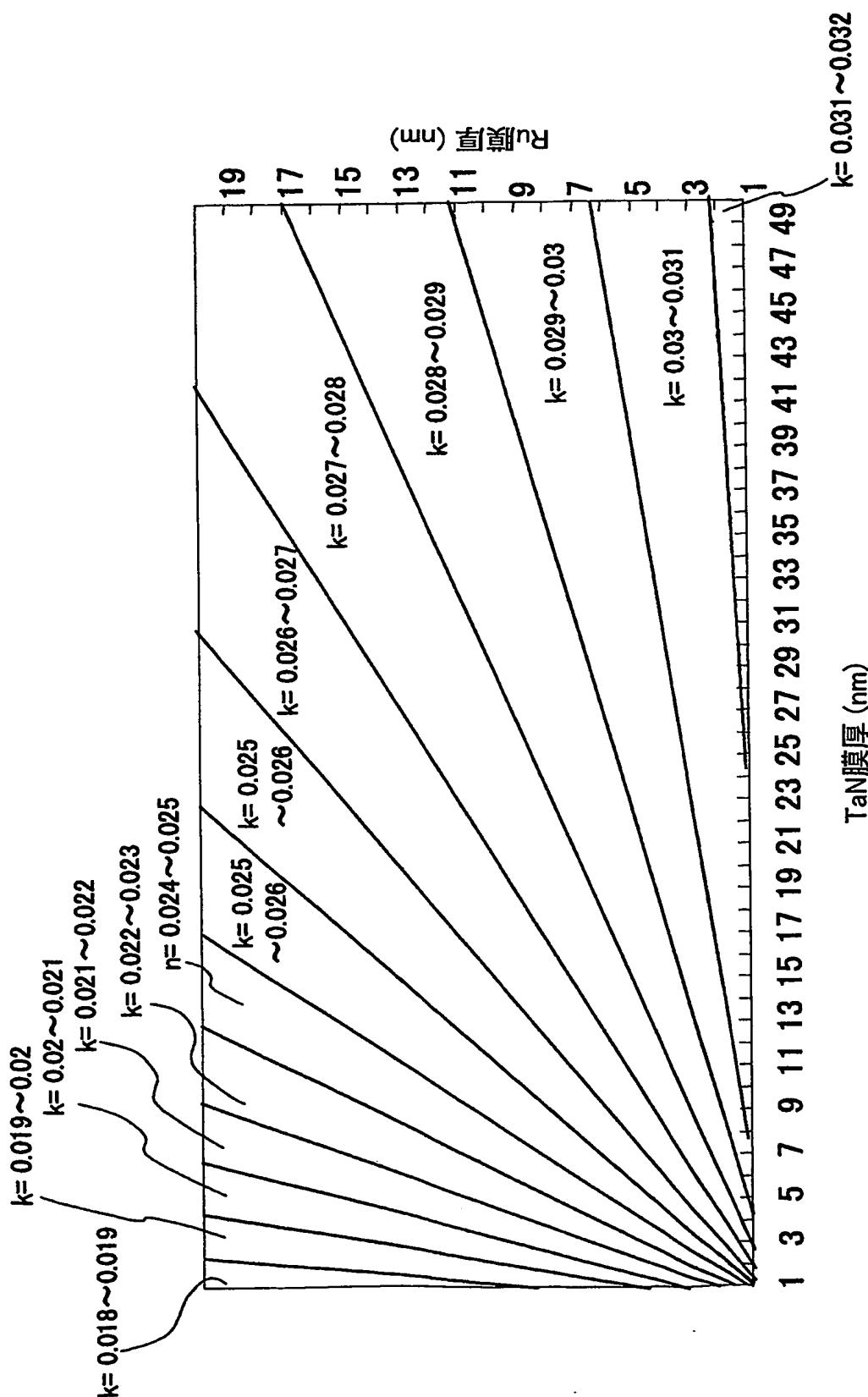


Fig.8

9/48

位相差	Ru/TiN	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
3																							166.7
4																							171.8
5																							174.5
6																							176.2
7																							174.7
8																							176.2
9																							183.0
10																							193.9
11																							
12																							190.8
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							

ハーフトーン反射率範囲		8-10	4-6	%
Ru/TiN	24	25	26	27
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Fig.9

位相差

Ru/Cr	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
0					106.3	159.4	168.7	178.9	186.2	186.8	180.9	177.5	
1									133.953	128.115	124.696	129.087	
2										126.647	130.742	140.4	
3										134.212	143.416	154.824	
4										138.817	147.444	158.579	168.608
5										158.6	151.3	162.2	172.4
6										146.2	154.0	164.7	177.2
7										147.361	155.0	165.7	176.0
8										147.4	155.0	165.8	176.1
9										148.0	155.5	166.1	176.4
10										157.5	167.9	178.1	184.0
11										153.3	149.2	154.6	161.2
12										159.5	165.6	175.3	185.39
13										169.5	178.9	188.971	196.115
14										181	191.146	198.528	199.238

Ru/Cr	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
0	182.0	191.9	203.7	213.5	216.3	208.7	200.9	203.7	214.2	227.8	240.4	246.7	238.9
1	138.996	150.8	160.6	163.4	155.9	148.1	150.8	161.3	174.8	367.4	373.7	366.1	171.8
2	152.0	161.9	165.0	158.0	150.2	152.6	162.7	176.0	188.6	195.1	188.2	174.2	173.5
3	164.7	168.5	162.4	154.6	156.2	165.7	178.7	191.2	198.2	192.6	179.1	177.3	187.0
4	173.1	168.2	160.3	161.0	169.8	182.3	194.8	202.4	198.4	185.4	182.4	191.1	
5	173.6	165.8	165.6	173.7	185.8	198.3	206.4	203.8	191.4	187.3	195.0	208.5	
6	169.5	168.7	176.3	188.3	200.701	209.2	207.5	195.5	195.5				
7	169.8	177.3	189.2	201.7	210.3	208.9	197.0	191.8					
8	177.3	189.252	201.7	210.4	209.0								
9	189.621	202.003											
10	203.604												
11	215.695												
12	221.344												
13													
14													

Fig.10

ハーフトーン反射率 4-6%

Ru/Cr	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
0					12.9	12.9	13.0	11.1	8.3	6.0	5.3	6.2	
1									6.0	5.3	6.3	7.8	
2									6.52266	8.06266	8.7		
3									8.5	9.2	8.4		
4									8.9	9.8	9.1	7.1	
5								2.8	10.3	9.7	7.6	5.3	
6							9.4	10.5	10.0	8.0	5.5	4.0	
7					9.32535	10.5	10.0	8.0	5.6	4.0	4.0		
8				9.3	10.4	10.0	8.0	5.6	4.0	4.0	5.2		
9	6.0	7.9	9.5	10.7	10.2	8.2	5.8	4.1	4.1	5.4	6.6		
10	8.1	8.4	10.1	11.3	10.9	8.8	6.3	4.5	4.4	5.6	6.9	7.2	
11	9.0	9.1	10.7	12.0	11.7	9.7	7.0	5.0	4.8	6.0	7.4	7.7	6.5
12	9.7	11.3	12.7	12.5	10.5	7.7	5.6	5.1	6.2	7.7	8.2	7.1	5.1
13	11.6	13.1	13.0	11.1	8.3	6.0	5.3	6.4	7.9	8.4			
14	13.1	13.1	11.3	8.4	6.1	5.3	7.8	8.5	7.6				

Ru/Cr	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
0	7.7	8.4	7.5	5.5	3.6	2.7	3.3	4.5	5.4	5.1	3.8	2.3	1.4
1	8.4	7.5	5.6	3.6	2.8	3.3	4.5	5.4	5.1	3.9	2.3	1.4	1.6
2	7.9	5.9	3.9	2.9	3.4	4.7	5.6	5.3	4.1	2.5	1.5	1.7	2.6
3	6.4	4.3	3.2	3.6	4.9	5.9	5.7	4.4	2.8	1.7	1.8	2.7	3.7
4	4.8	3.5	3.8	5.1	6.2	6.1	4.8	3.1	1.9	1.9	2.8	3.8	
5	3.8	4.0	5.2	6.4	6.4	5.2	3.4	2.1	2.0	2.8	3.9	4.3	
6	4.0	5.3	6.5	6.6	5.4	3.6	2.2	2.0					
7	5.2	6.5	6.6	5.5	3.7	2.3	2.0	2.8					
8	6.5	6.6	5.5	3.7	2.3								
9	6.8	5.6											
10	6.0												
11	4.5986												
12	3.3												
13													
14													

Fig.11

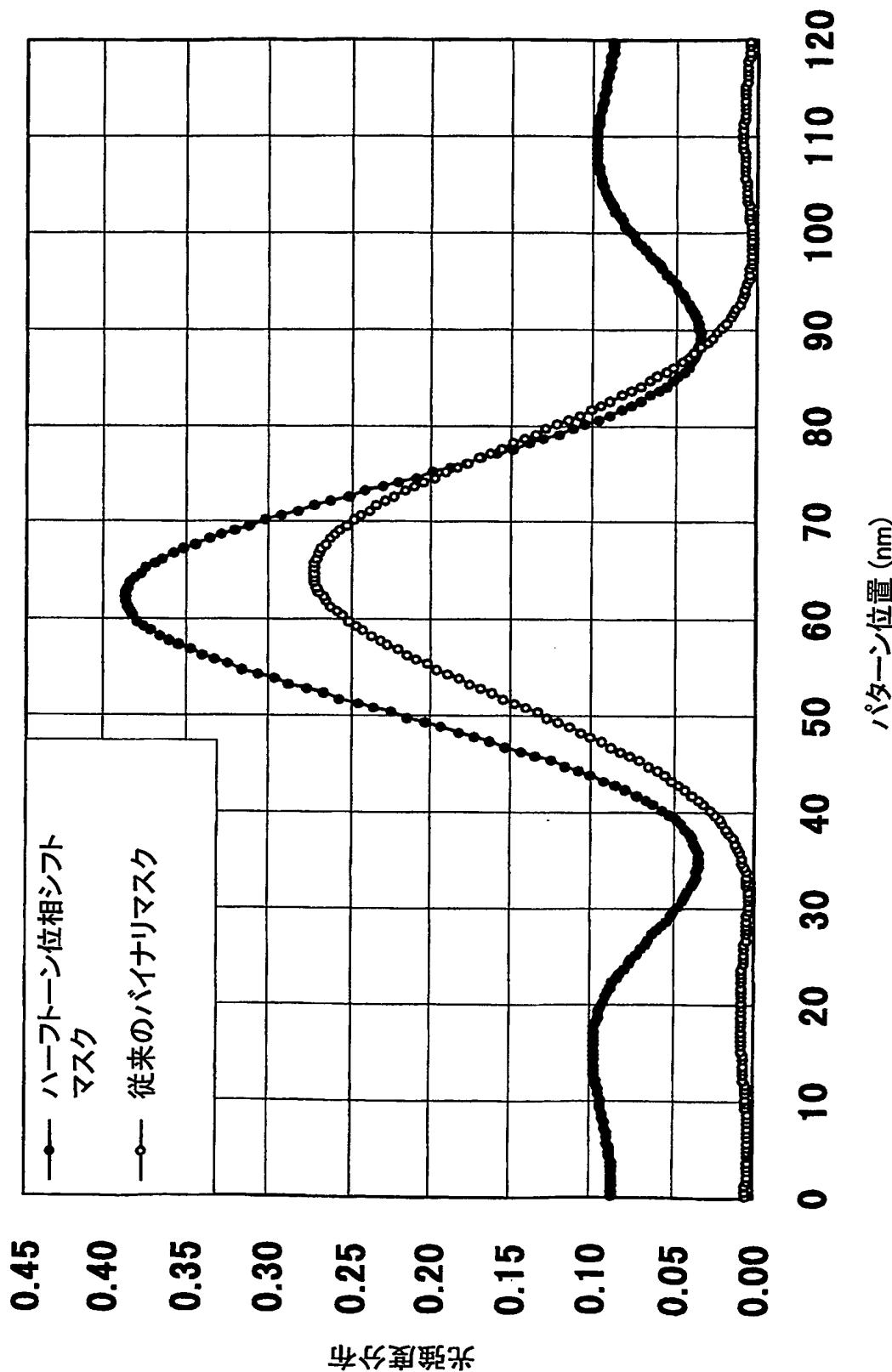


Fig.12

13/48

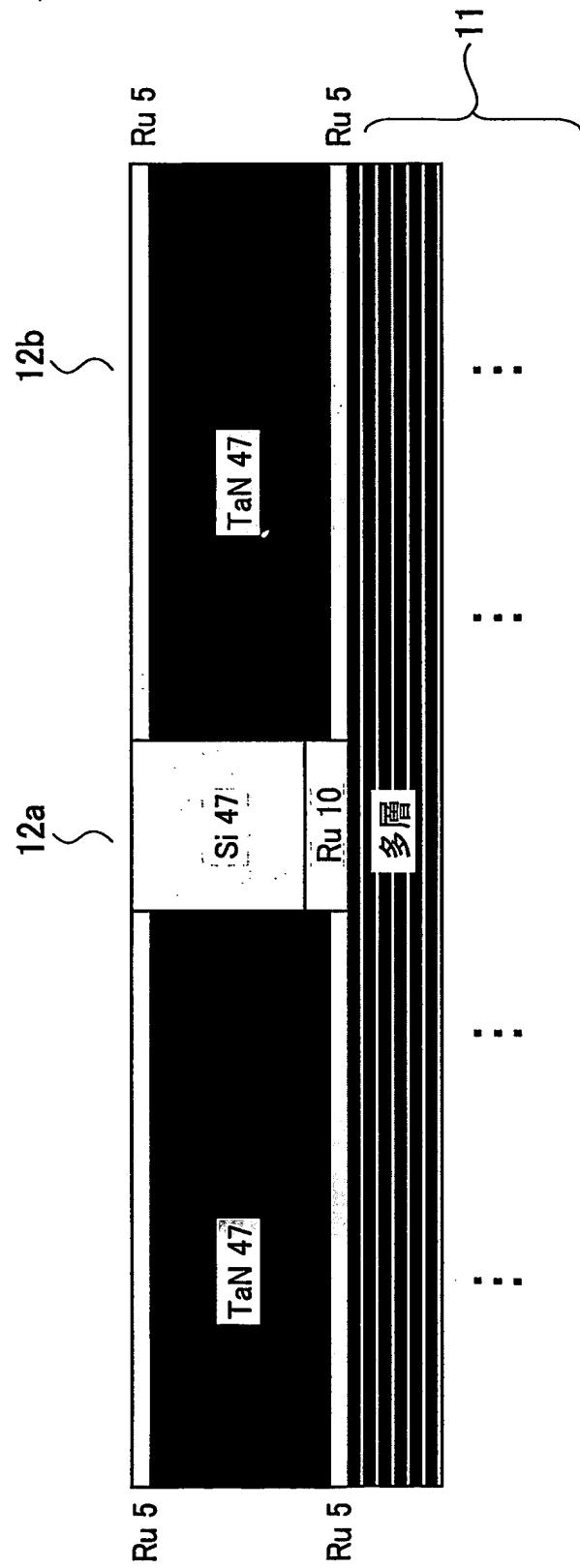


Fig. 13

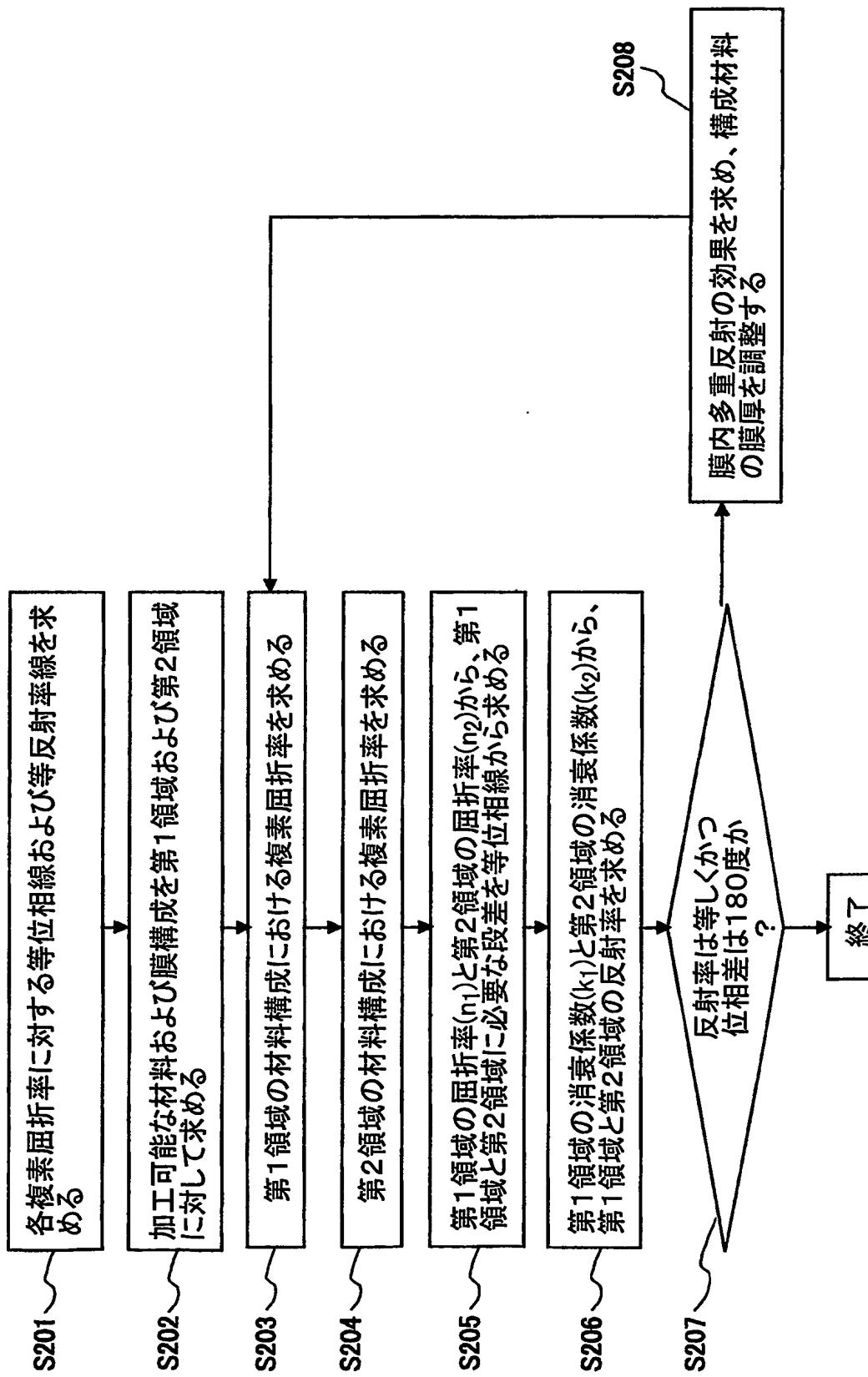


Fig.14

15/48

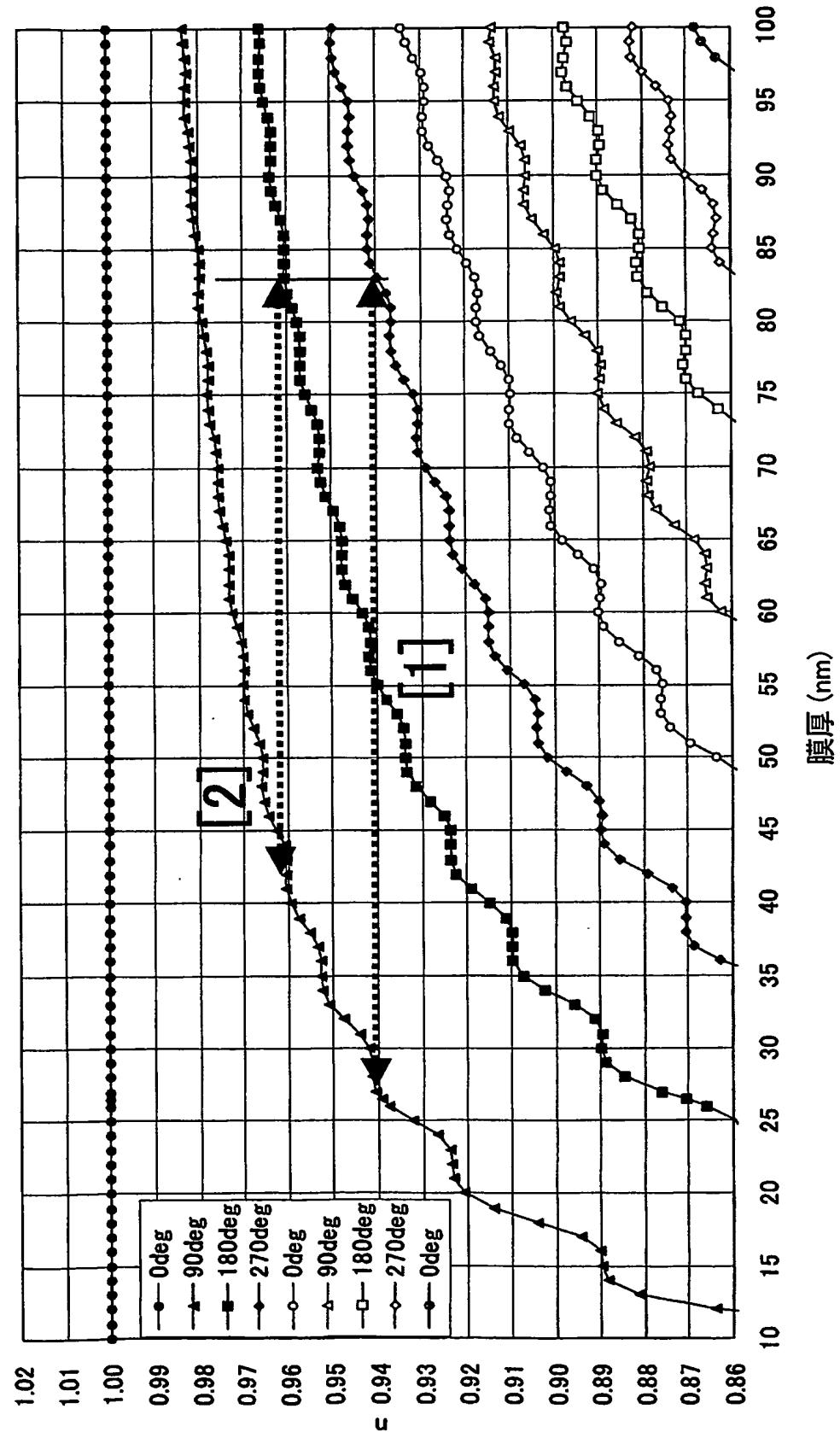


Fig.15

16/48

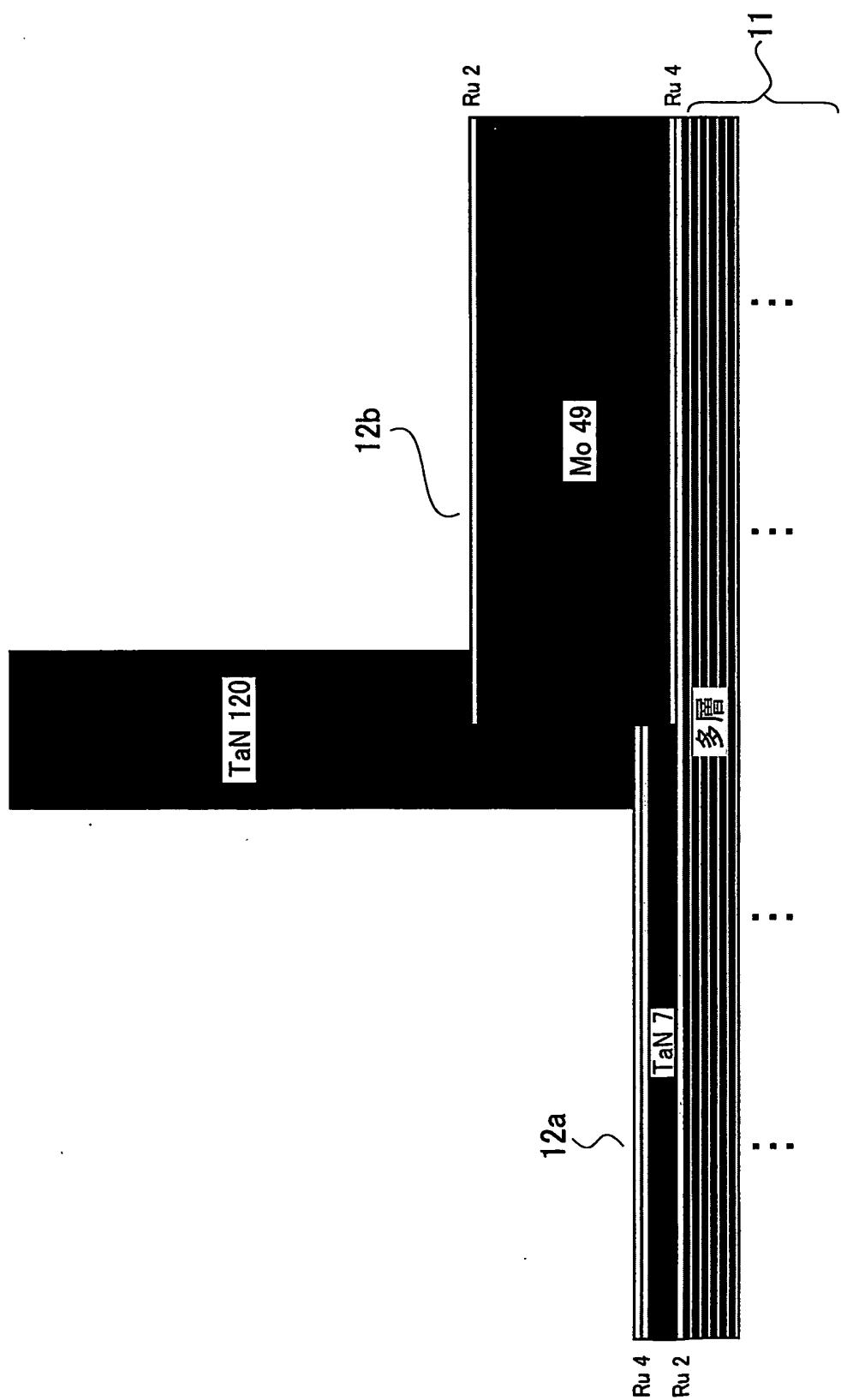


Fig.16

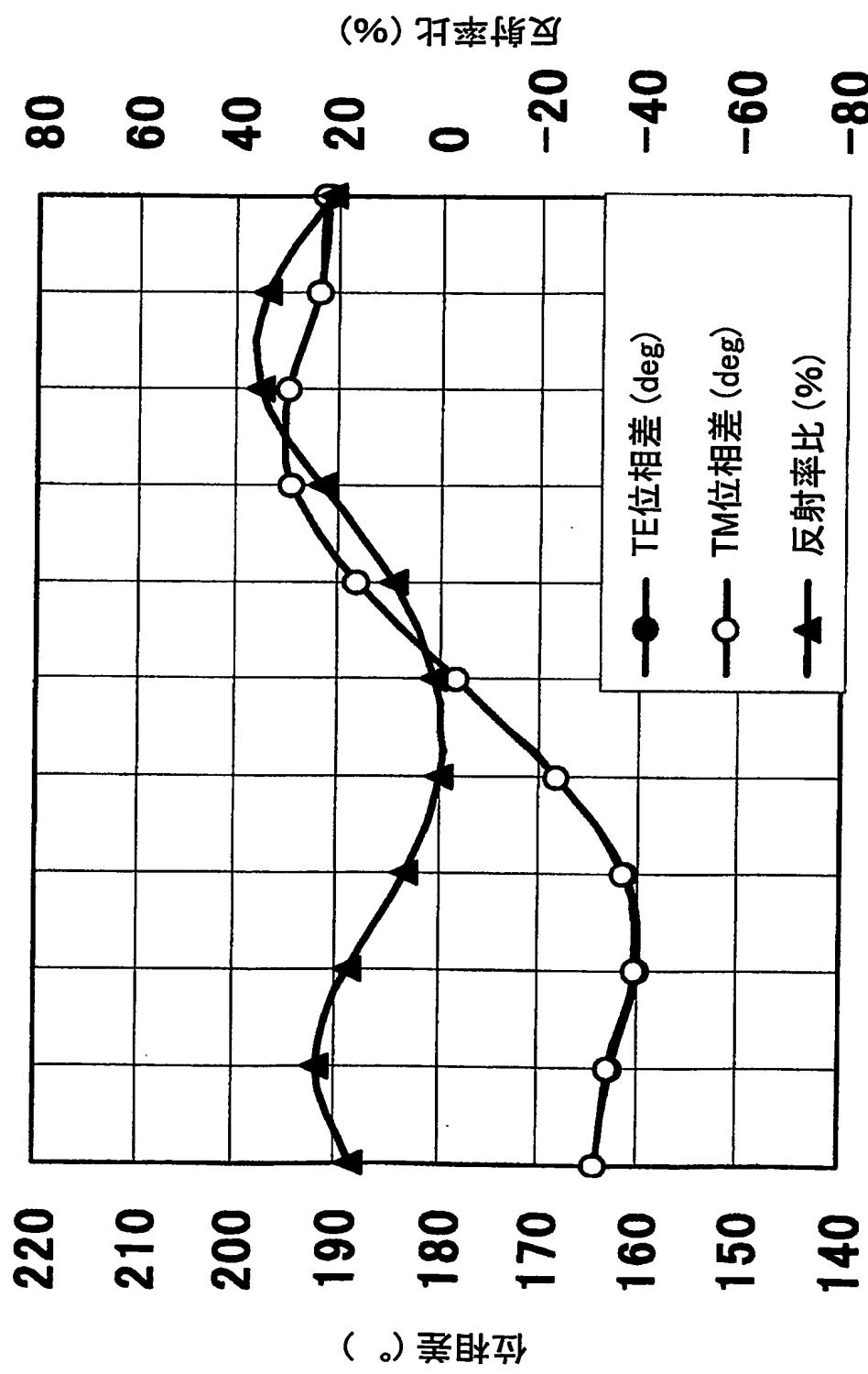


Fig.17

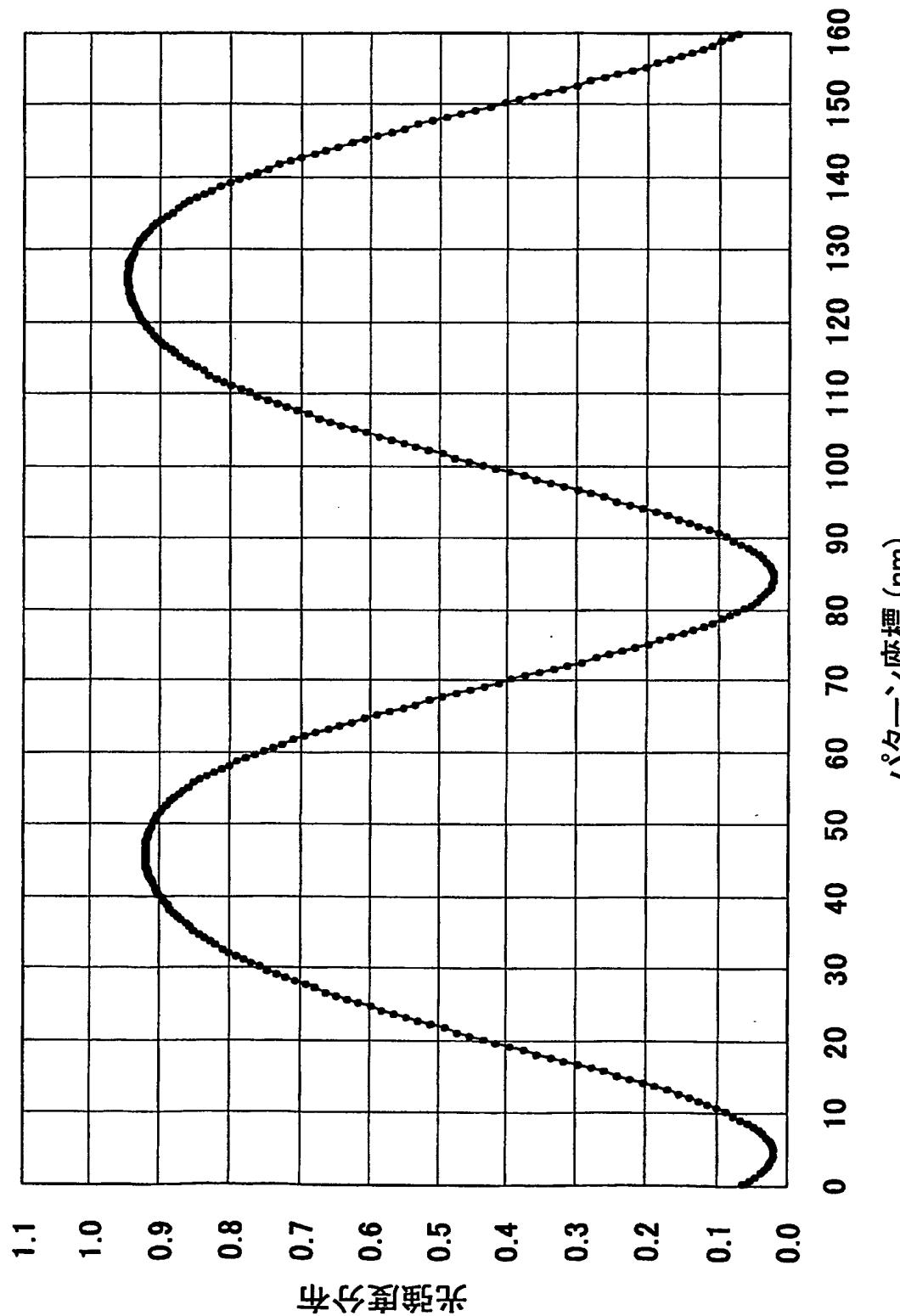


Fig.18

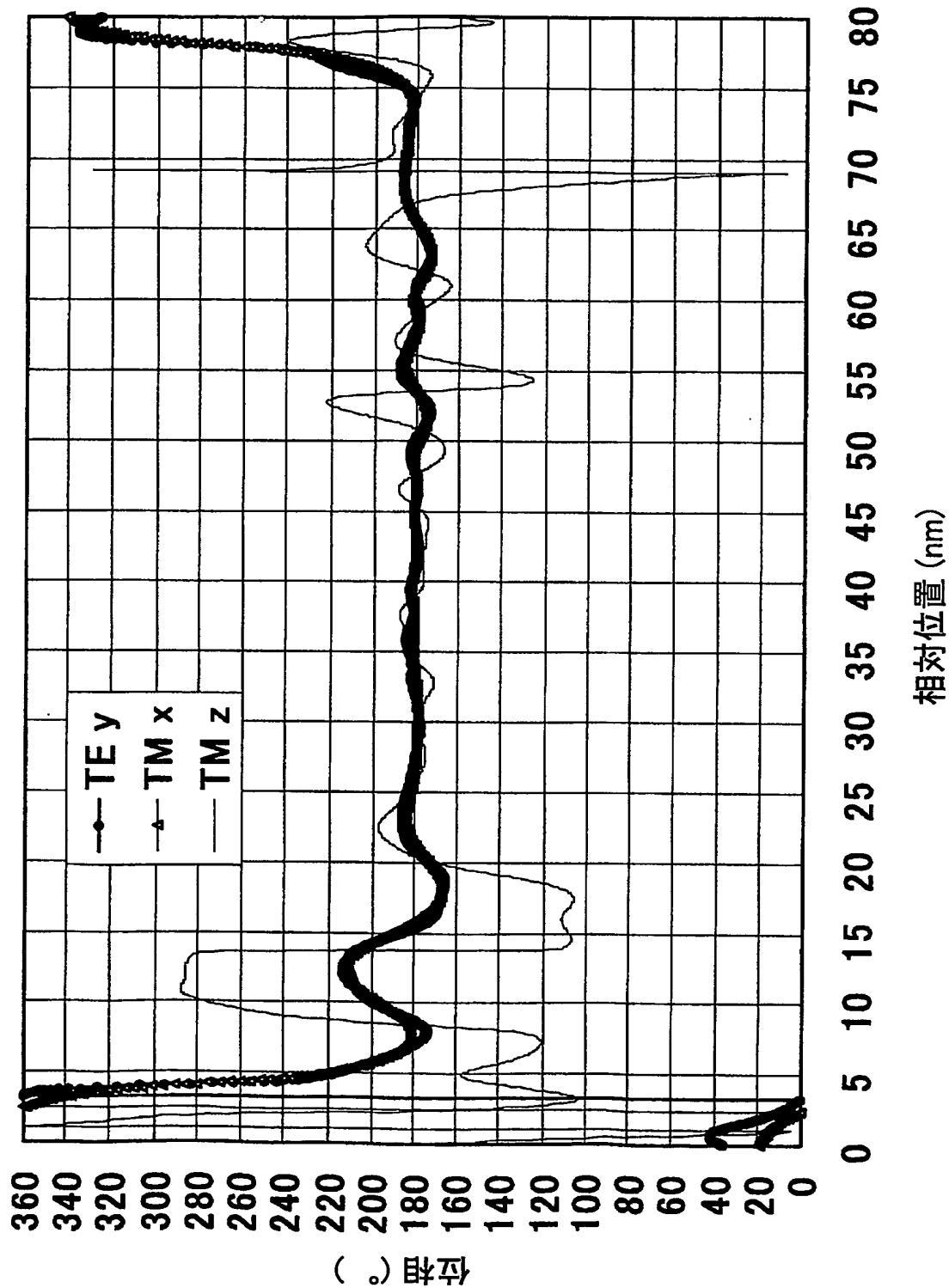
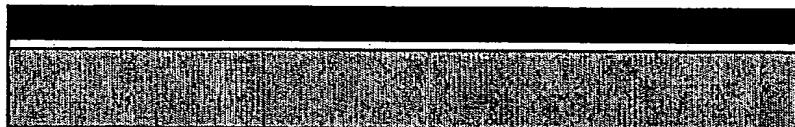


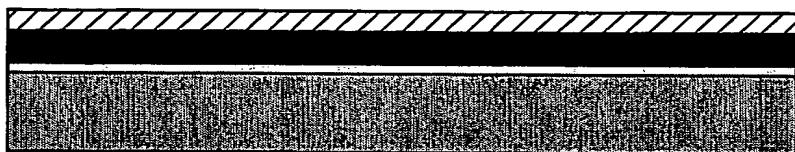
Fig.19



工程1 Ruコート



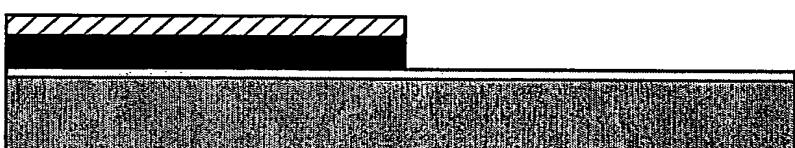
工程2 TaNコート



工程3 レジストコート



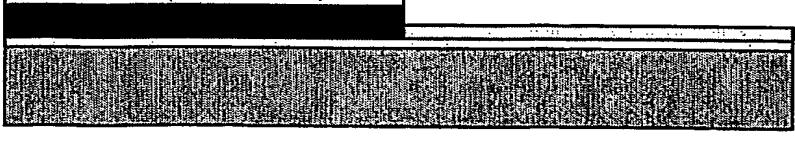
工程4 レジストパターニング



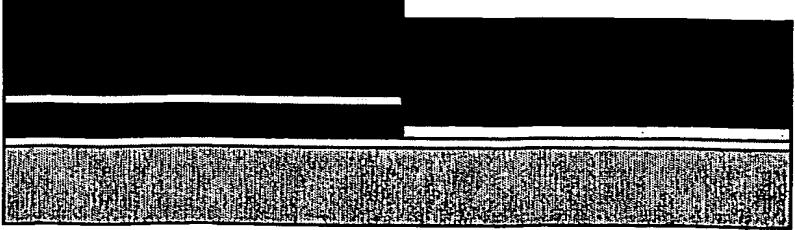
工程5 TaNエッチング



工程6 レジスト剥離



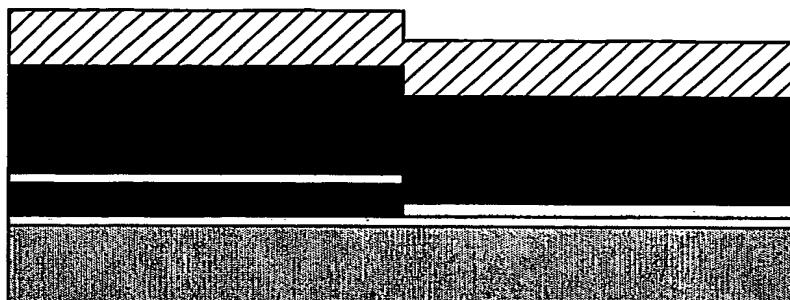
工程7 Ruコート



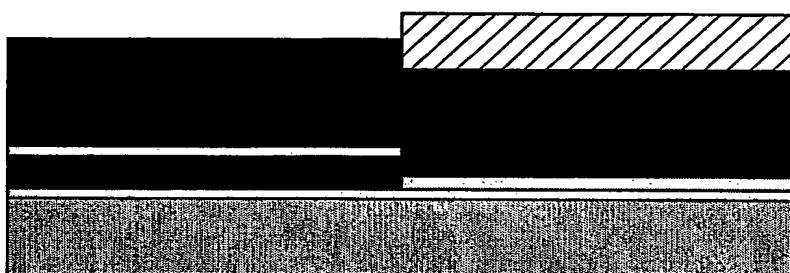
工程8 Moコート

Fig.20

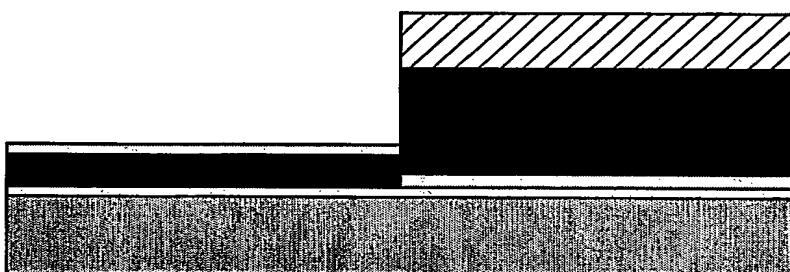
21/48



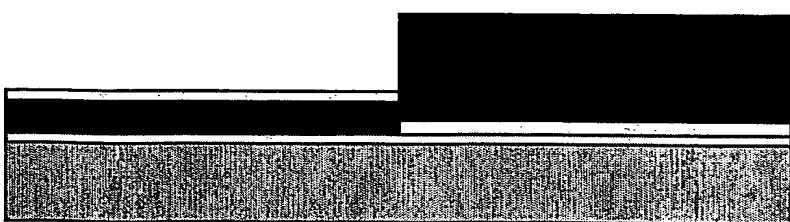
工程9 レジストコート



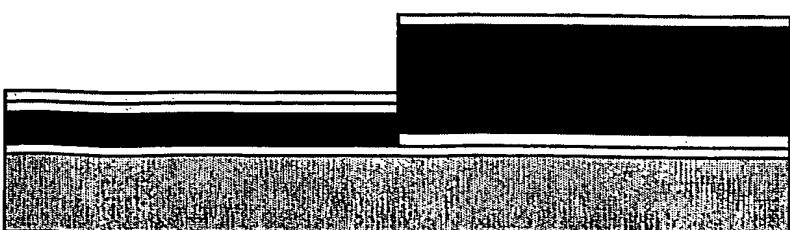
工程10 レジストパターニング



工程11 Moエッチング

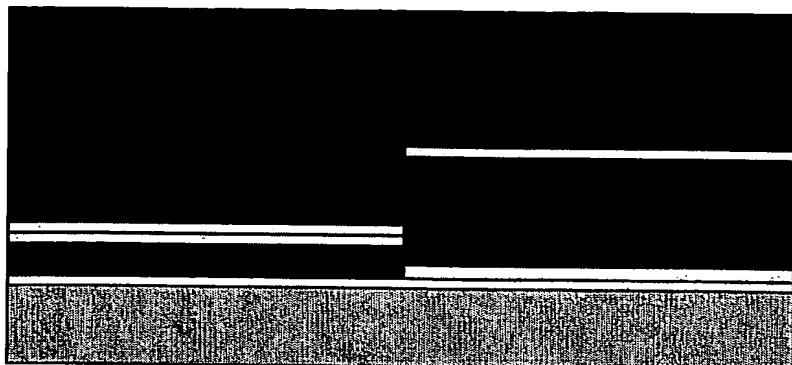


工程12 レジスト剥離

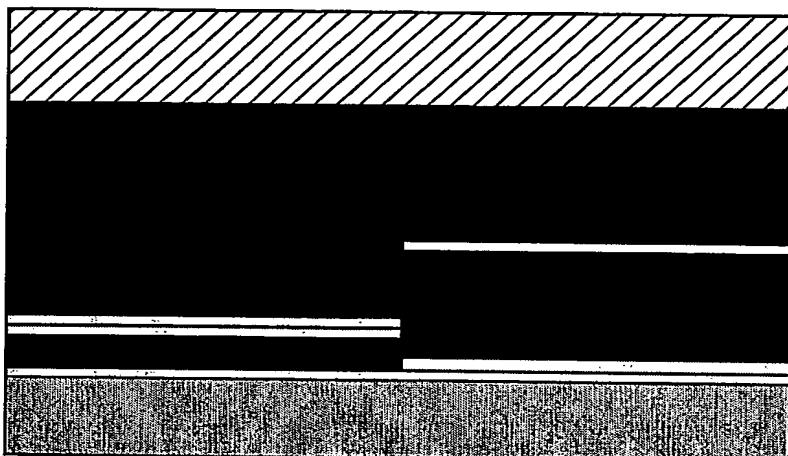


工程13 Ruコート

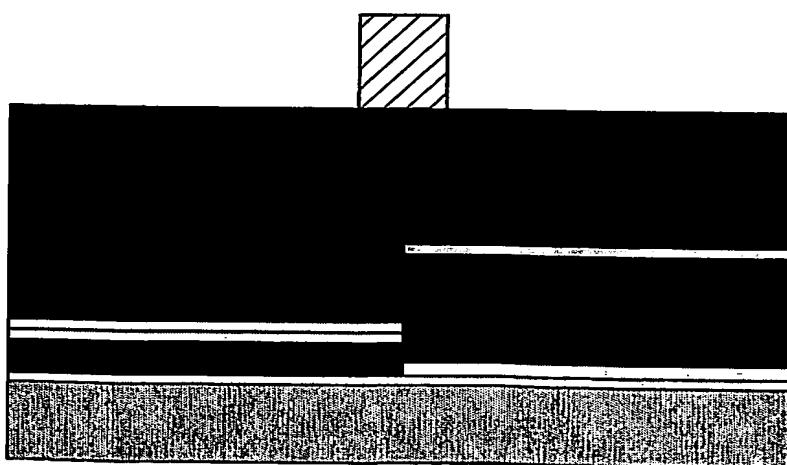
Fig.21



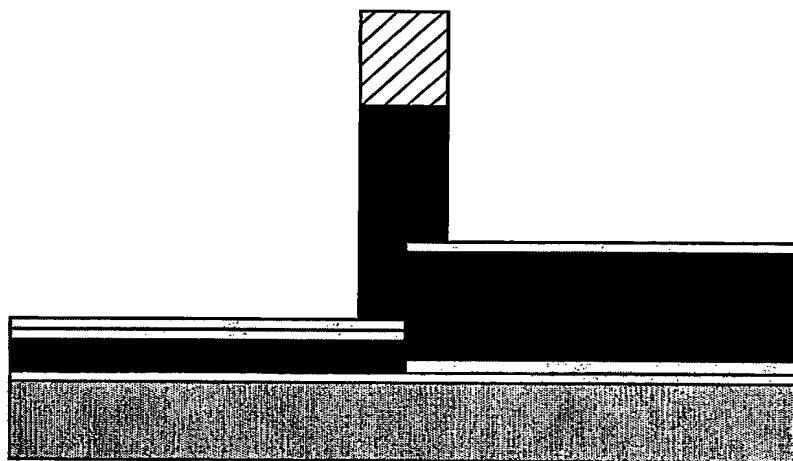
工程14 TaNコート



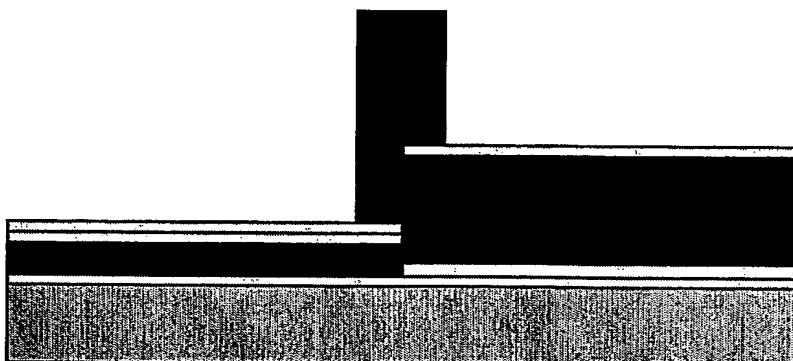
工程15 レジストコート



工程16 レジストパターニング



工程17 TaNエッチング



工程18 レジスト剥離

Fig.23

24/48

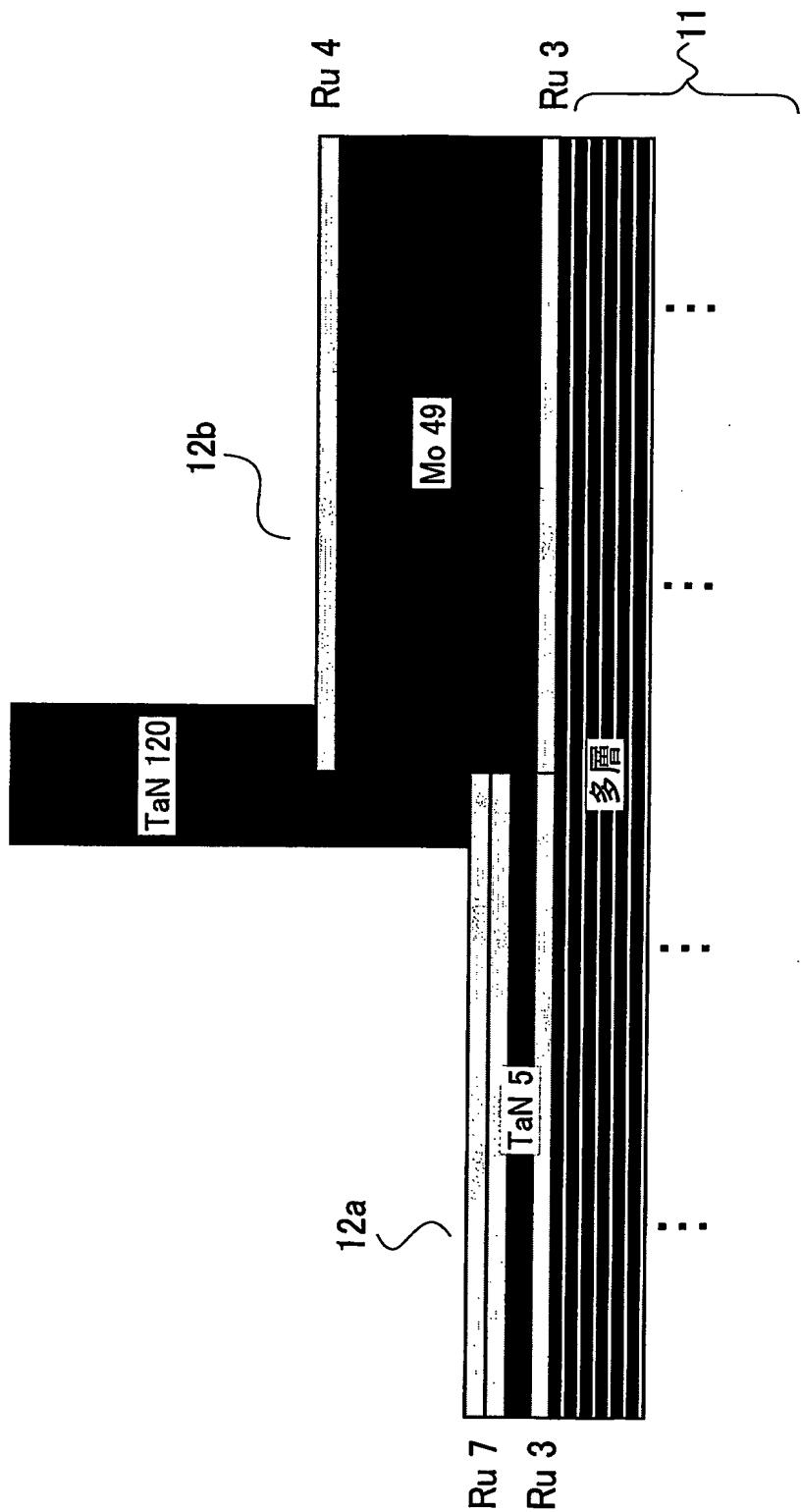


Fig.24

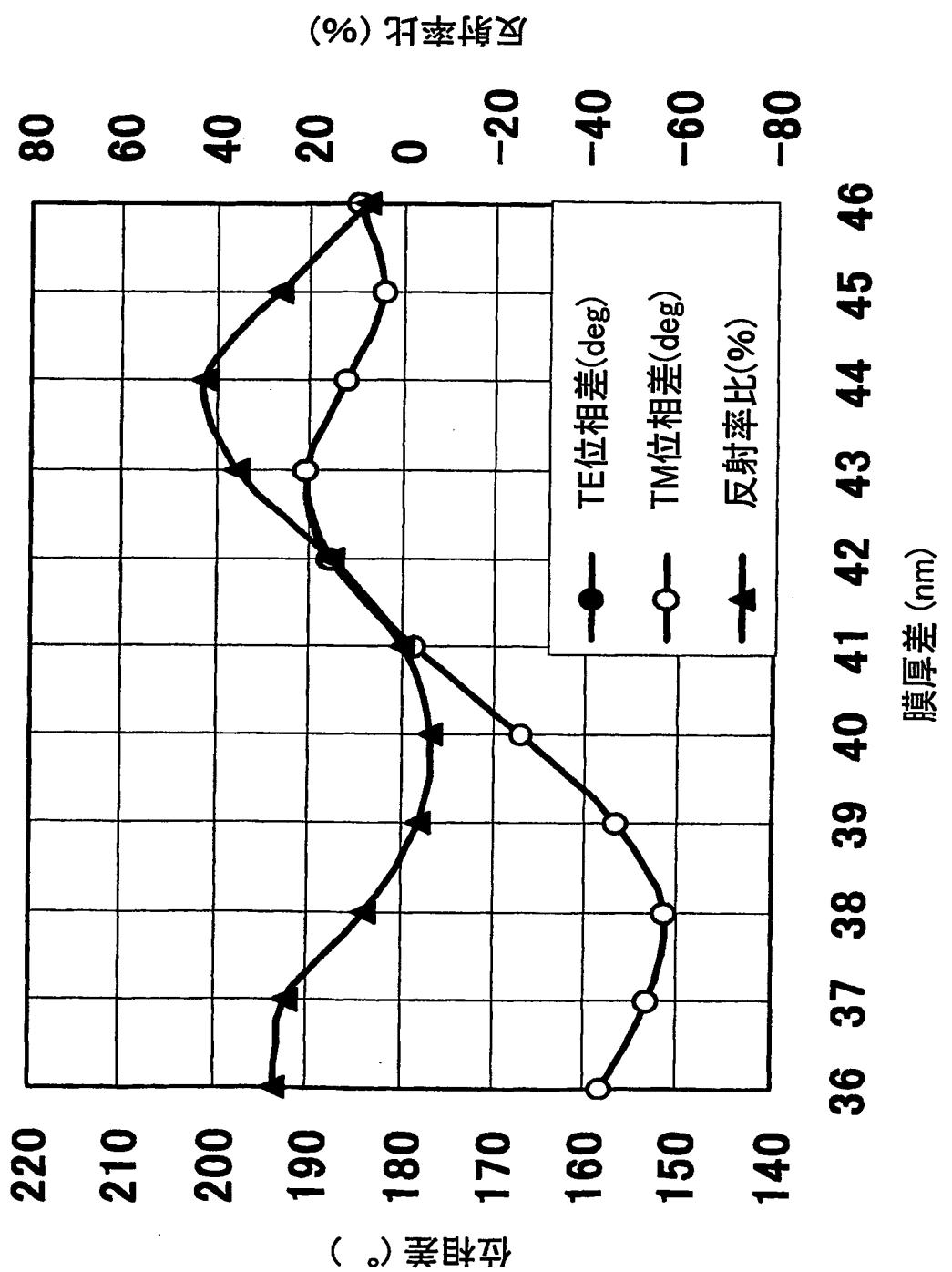


Fig. 25

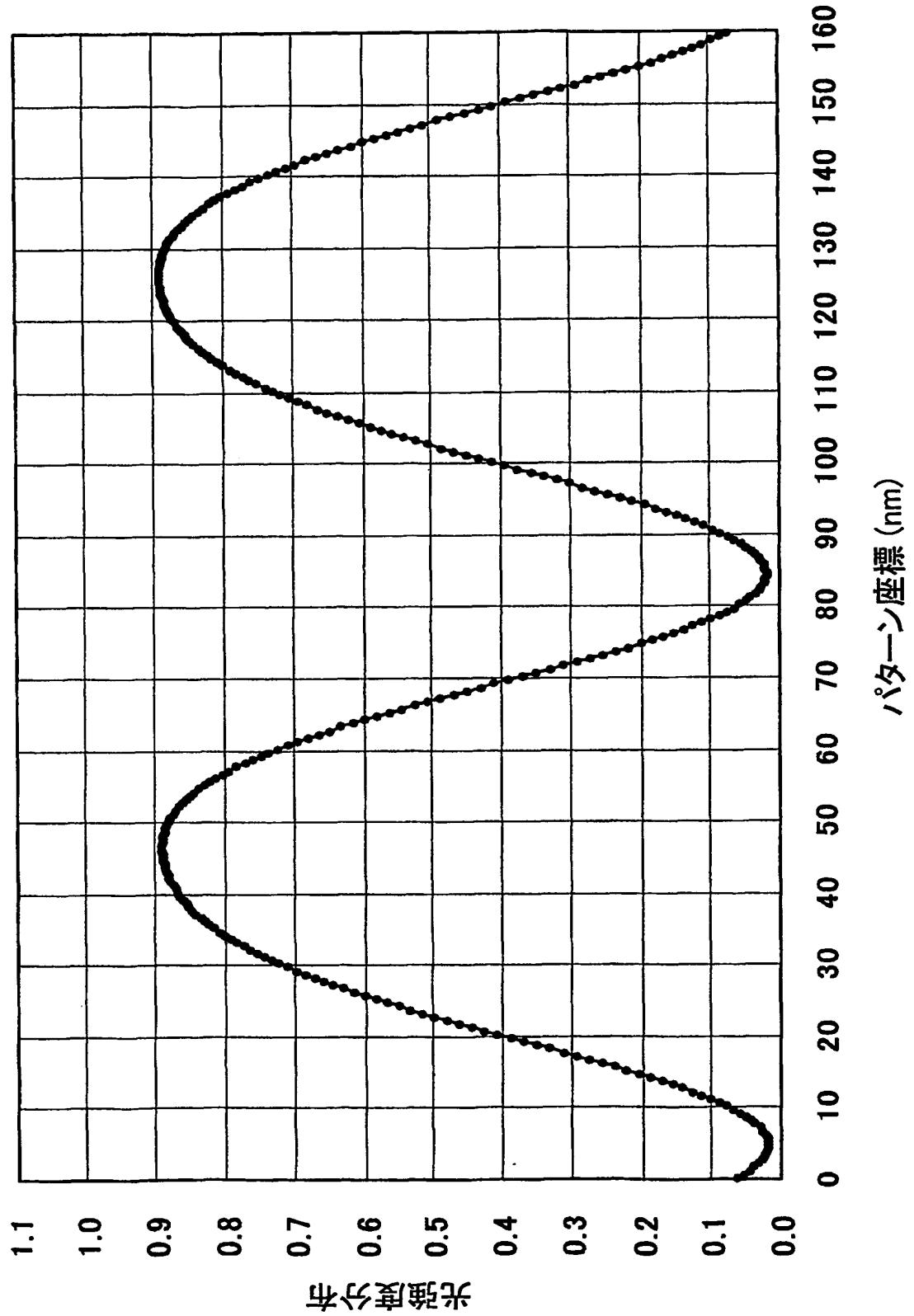
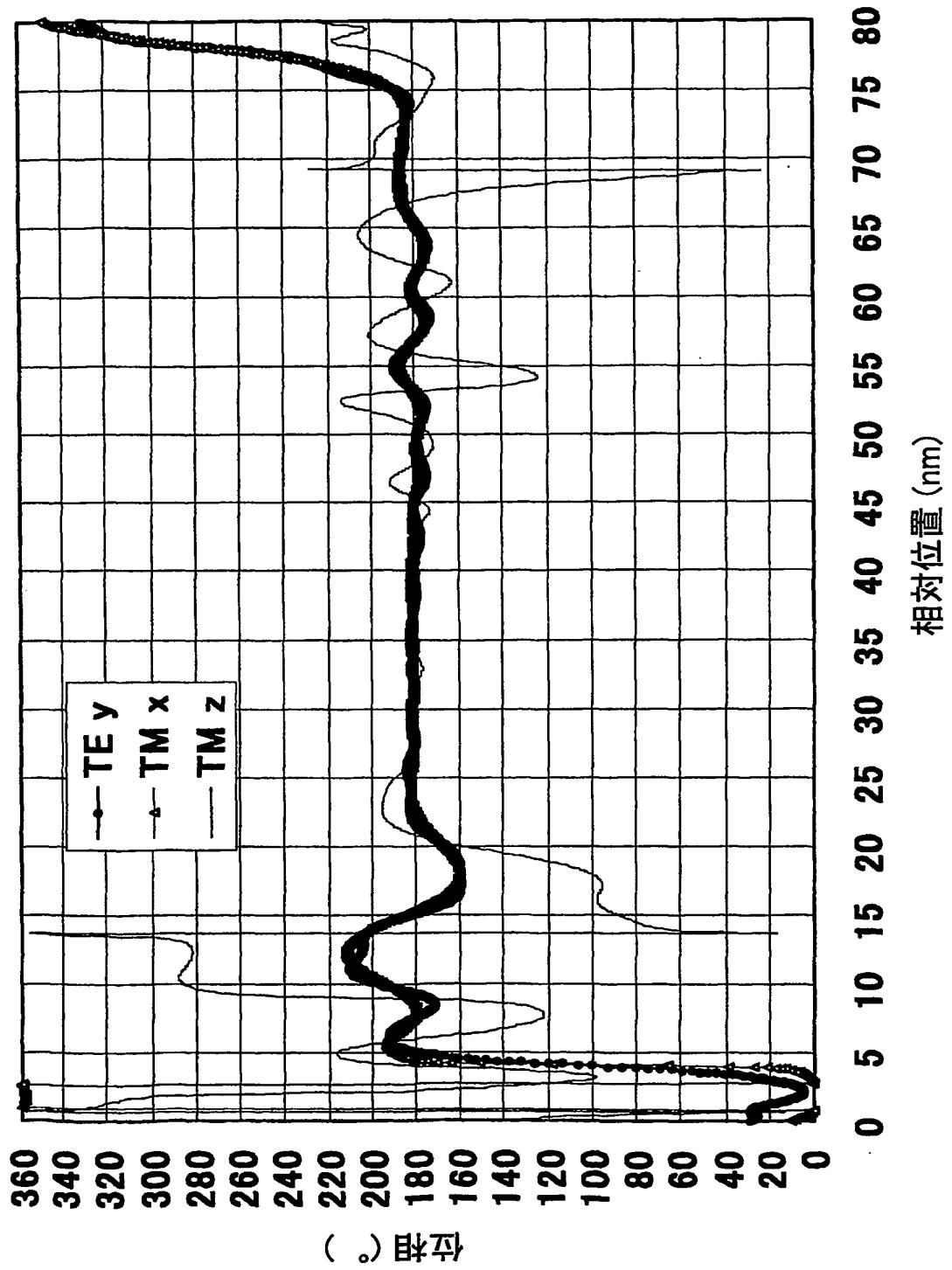


Fig.26



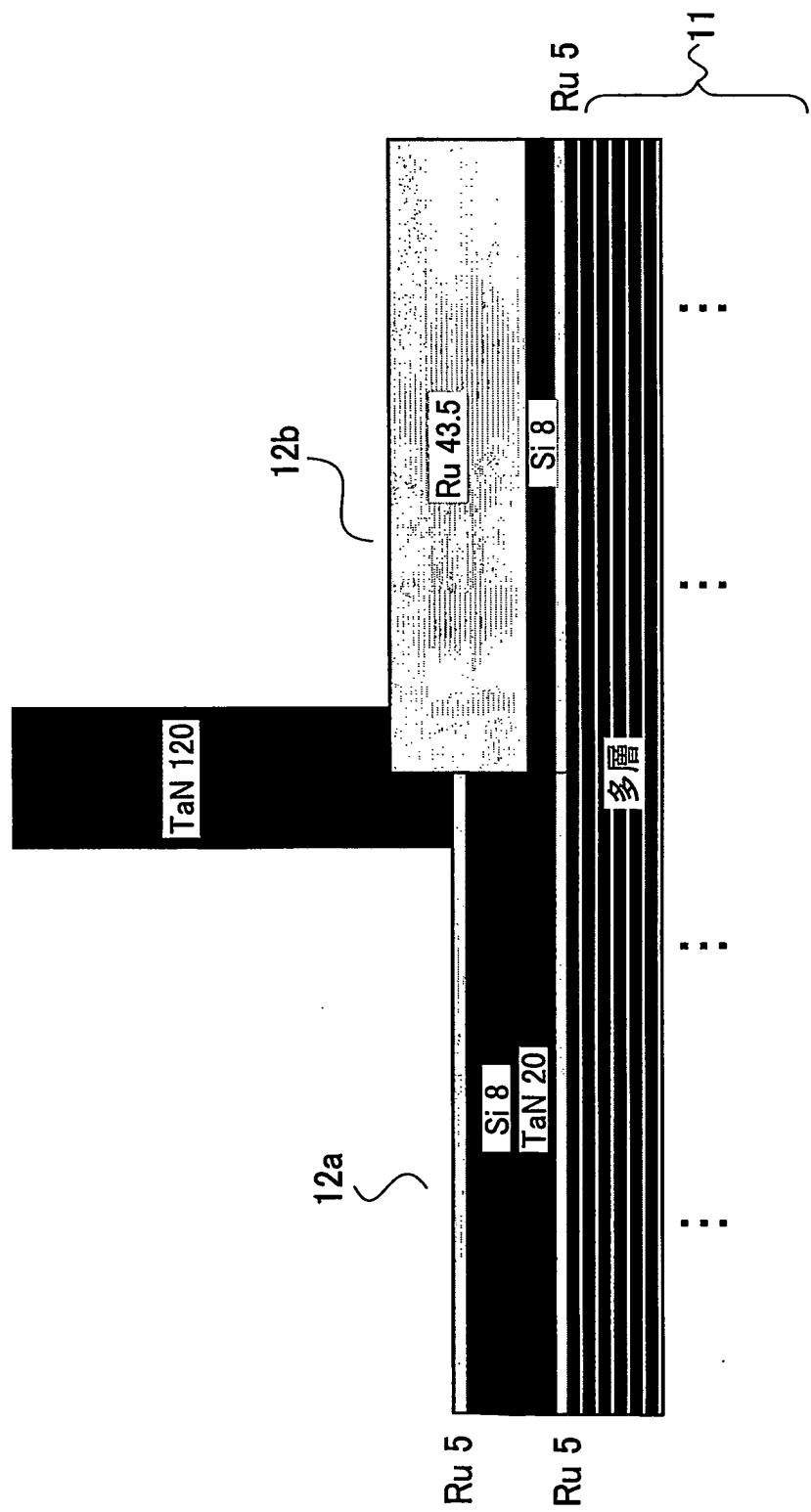


Fig.28

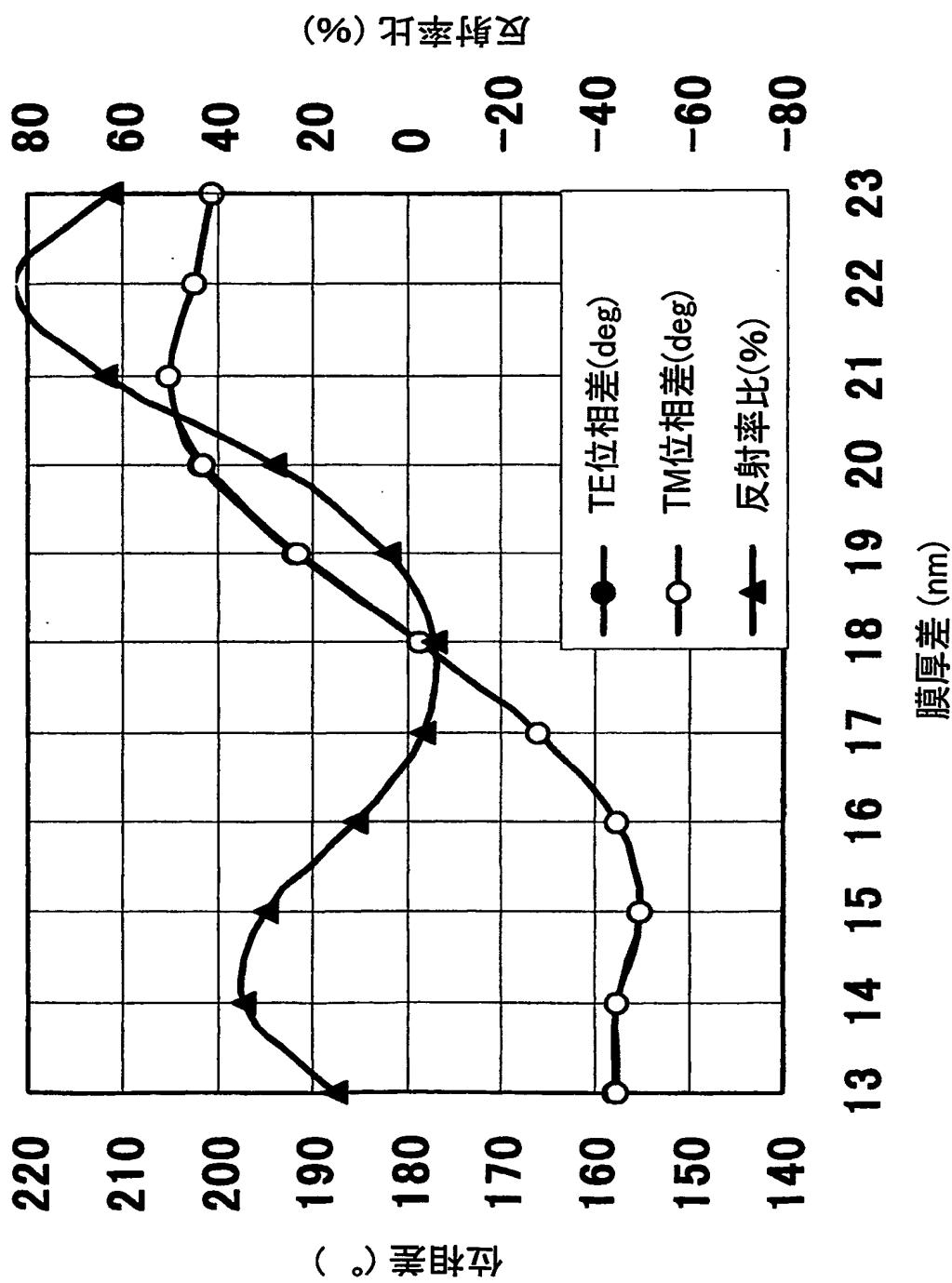


Fig.29

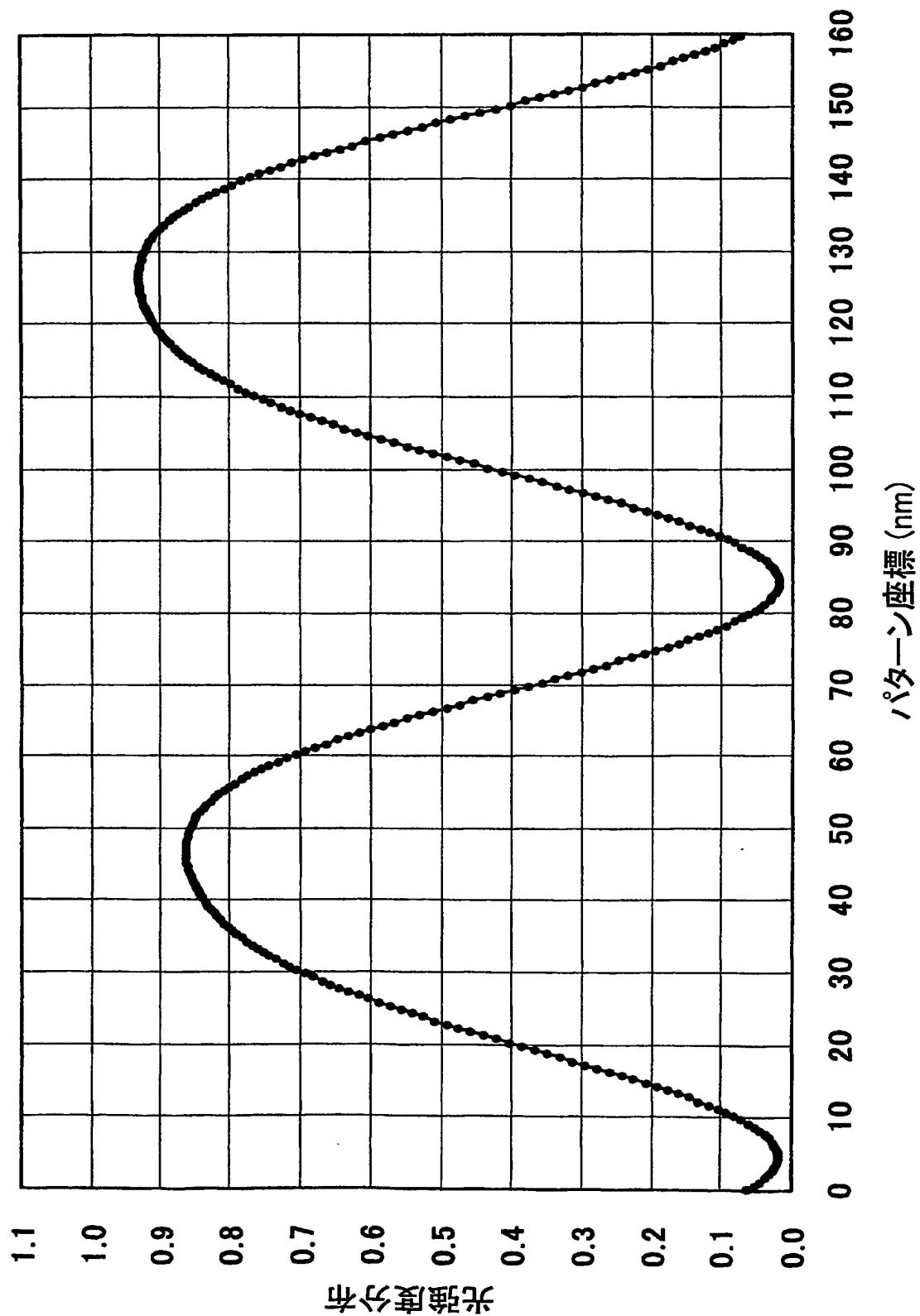


Fig.30

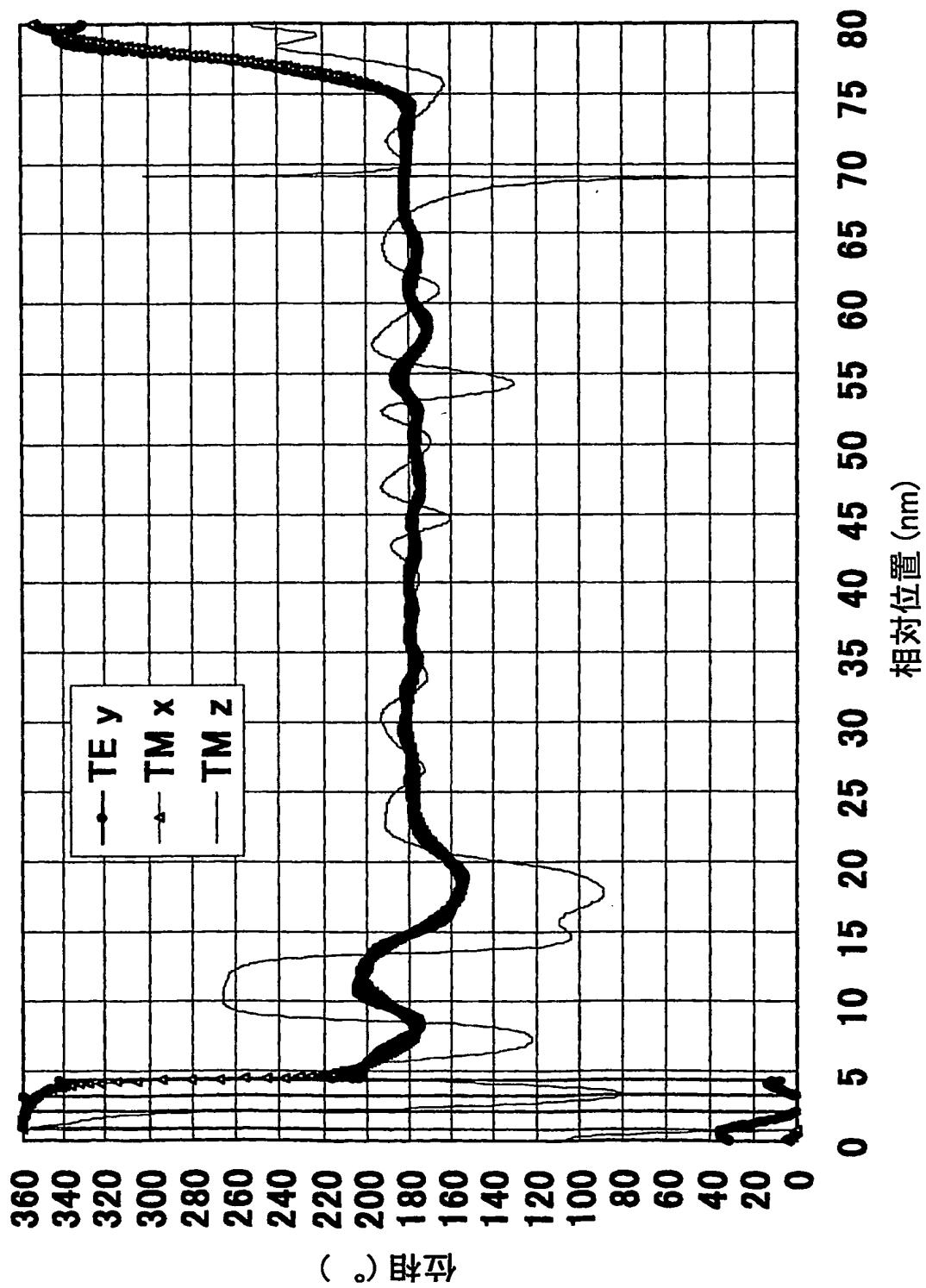


Fig.31

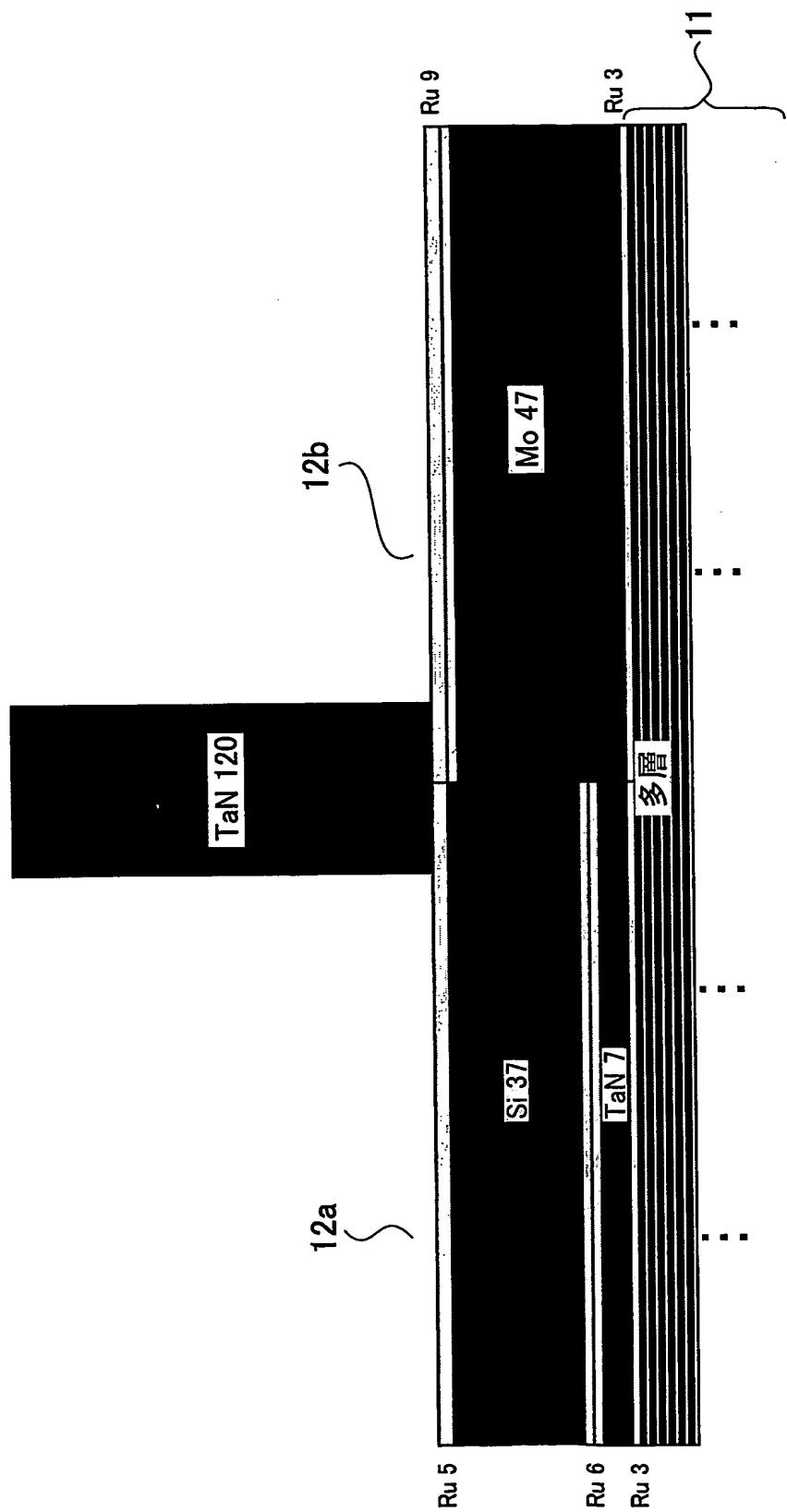


Fig.32

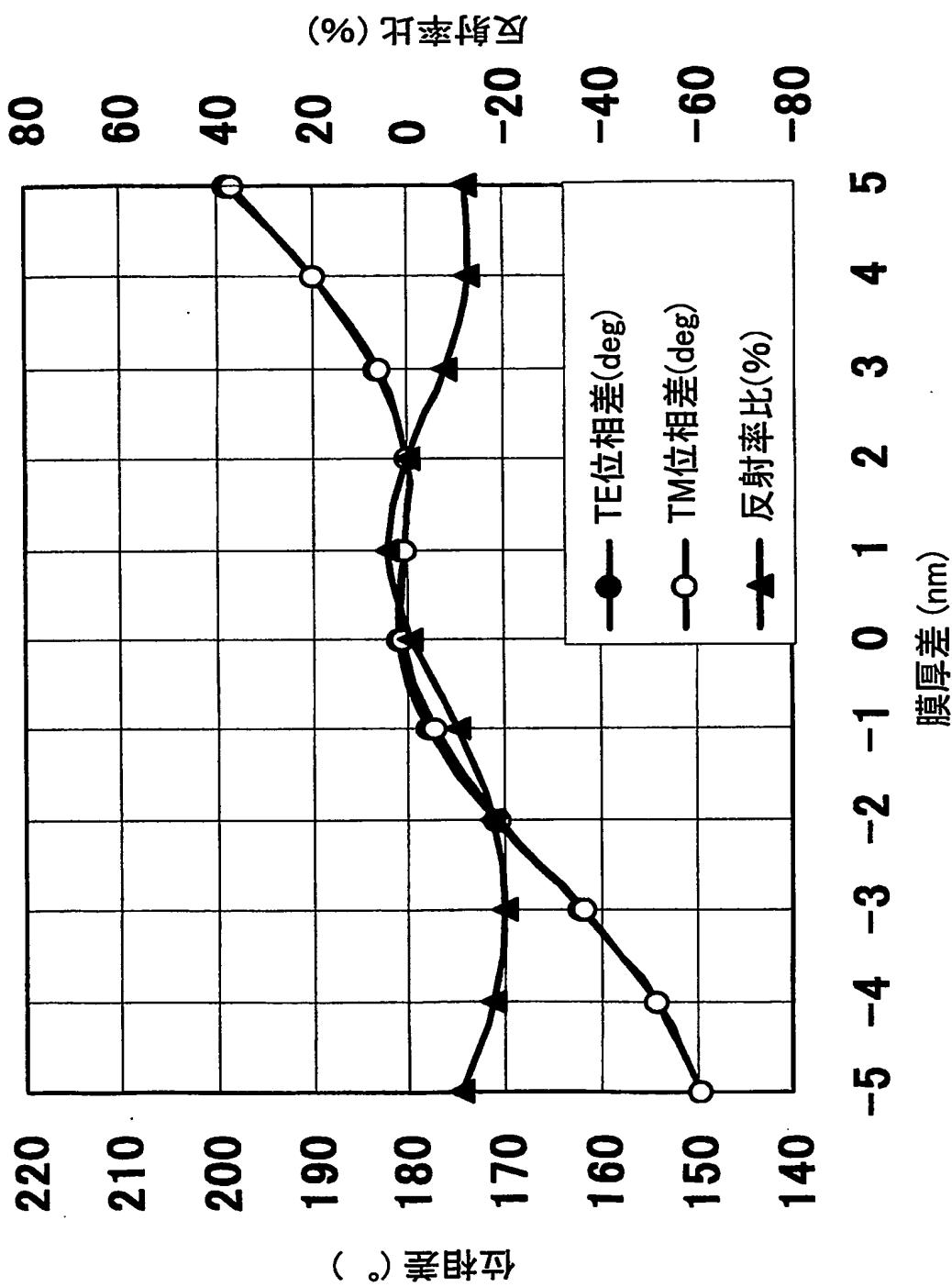


Fig.33

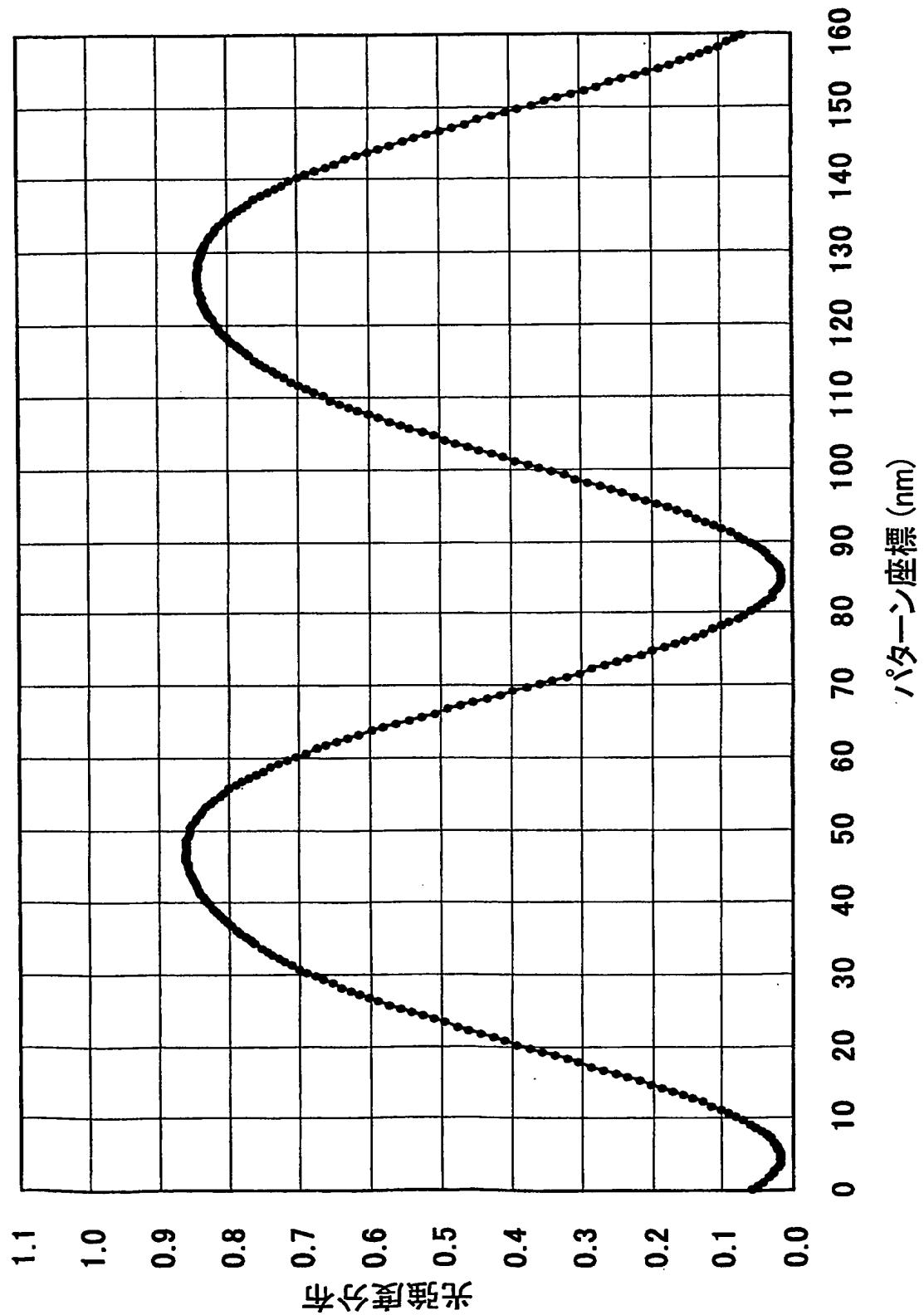


Fig.34

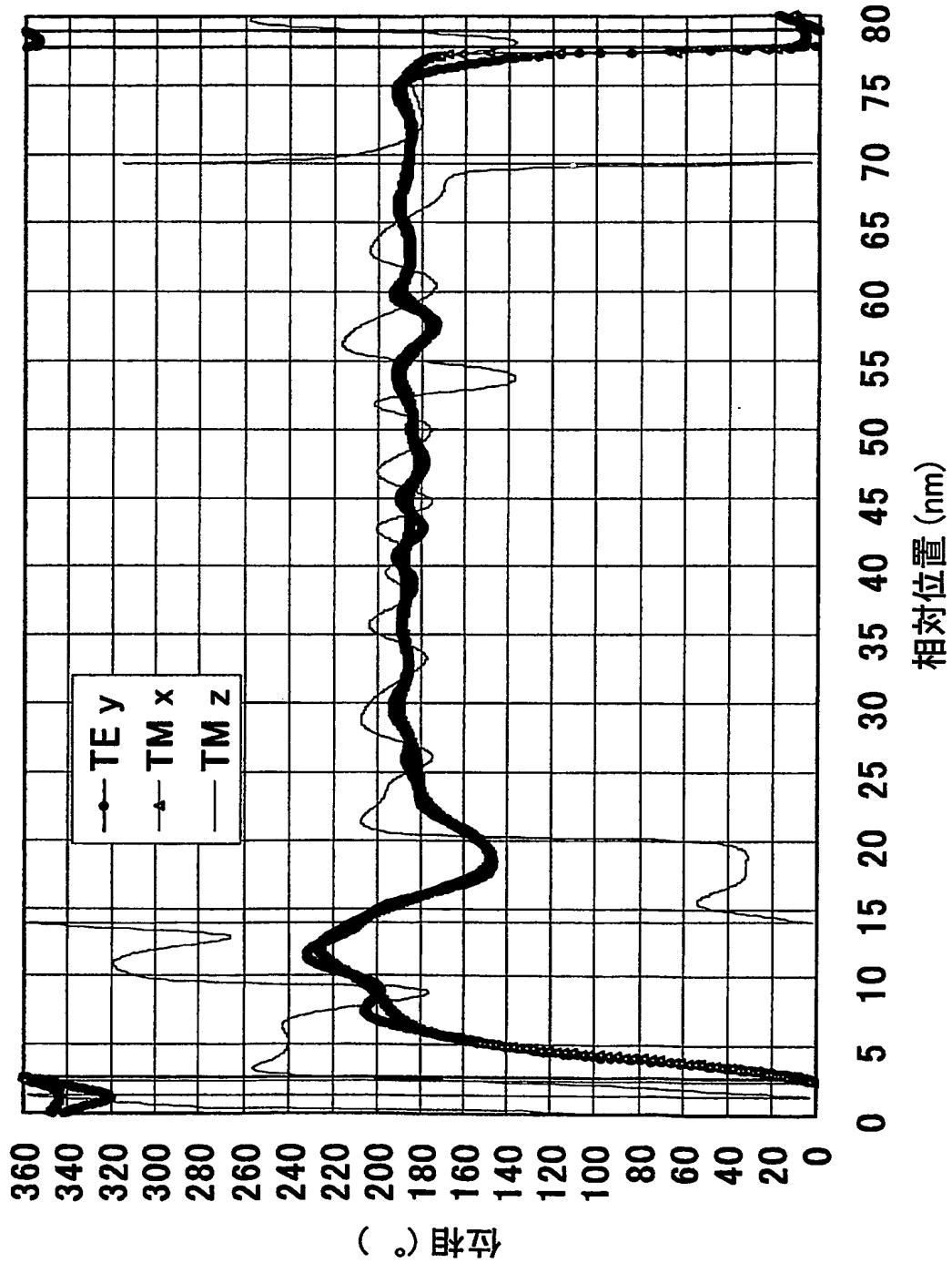


Fig.35

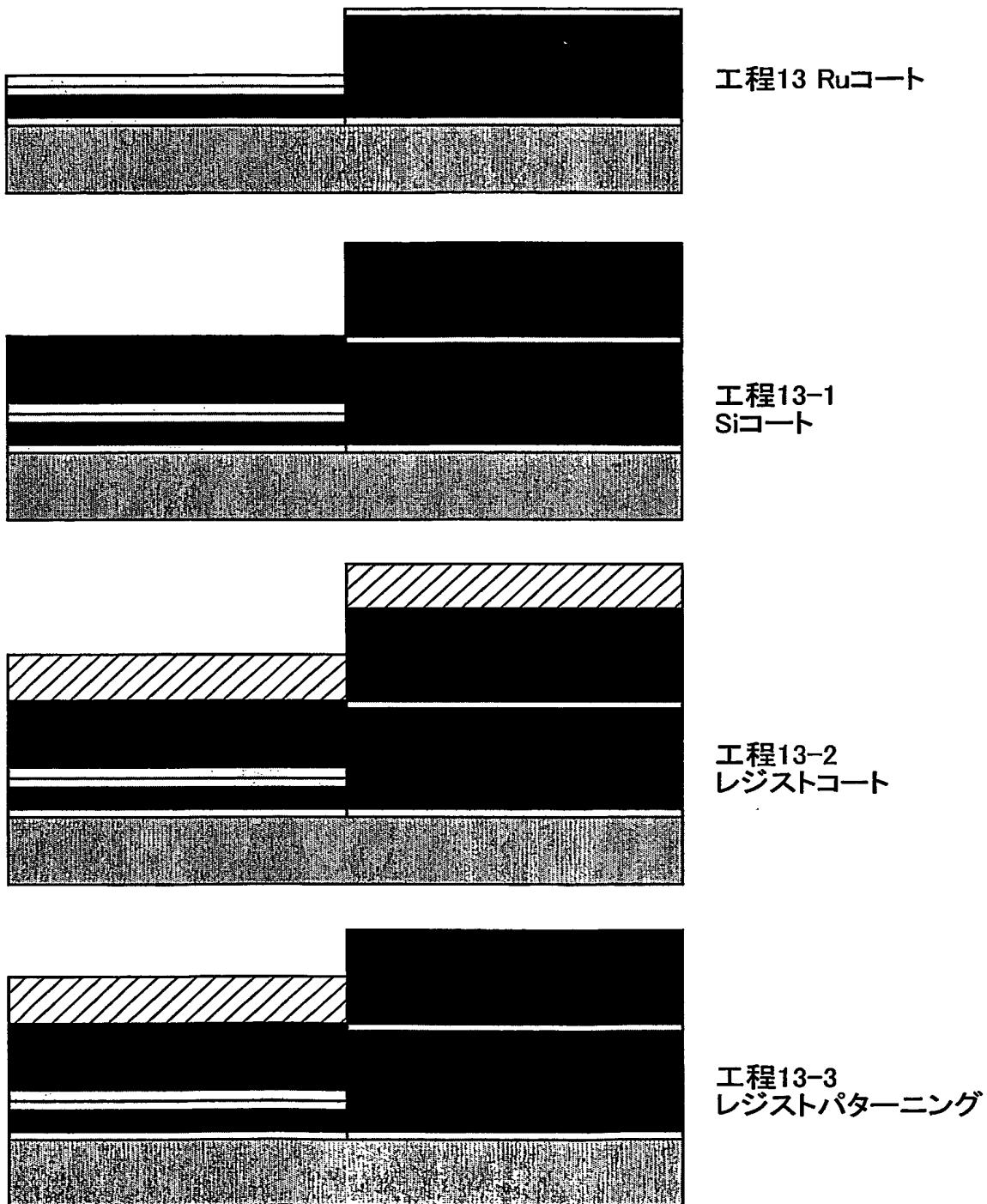
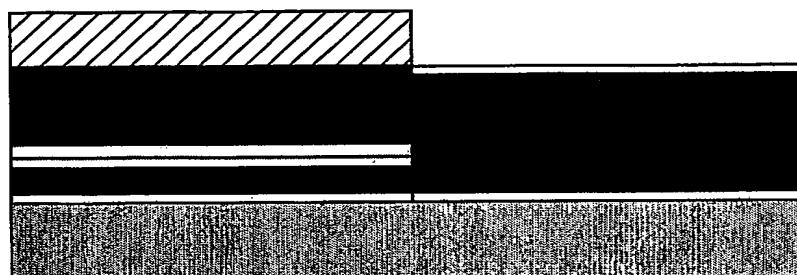
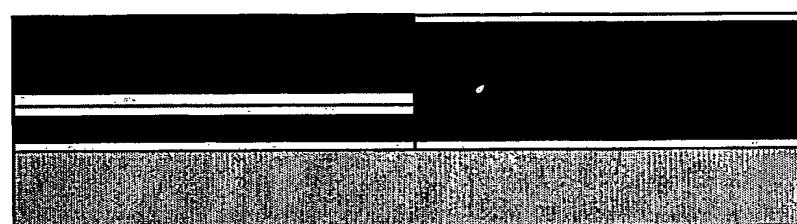


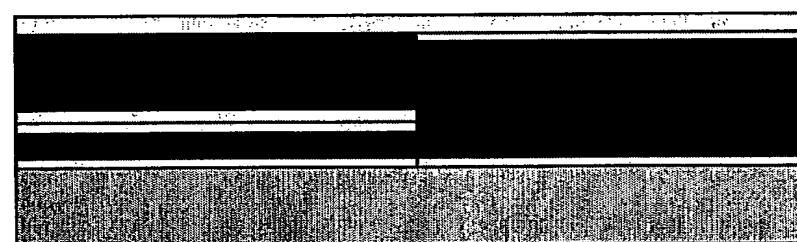
Fig.36



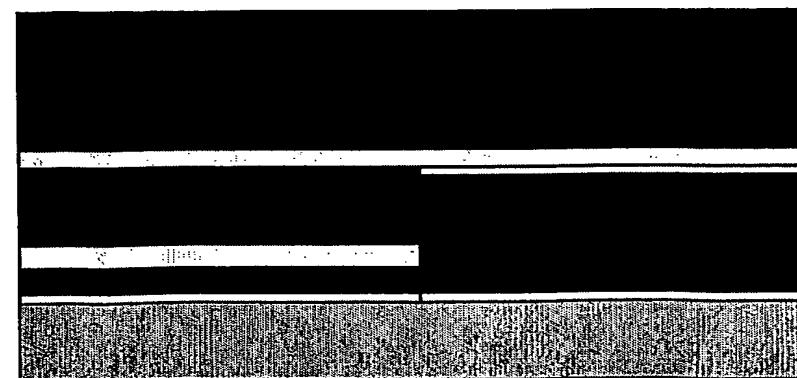
工程13-4
Siエッチング



工程13-5
レジスト剥離



工程13-6
Ruコート



工程14
TaNコート

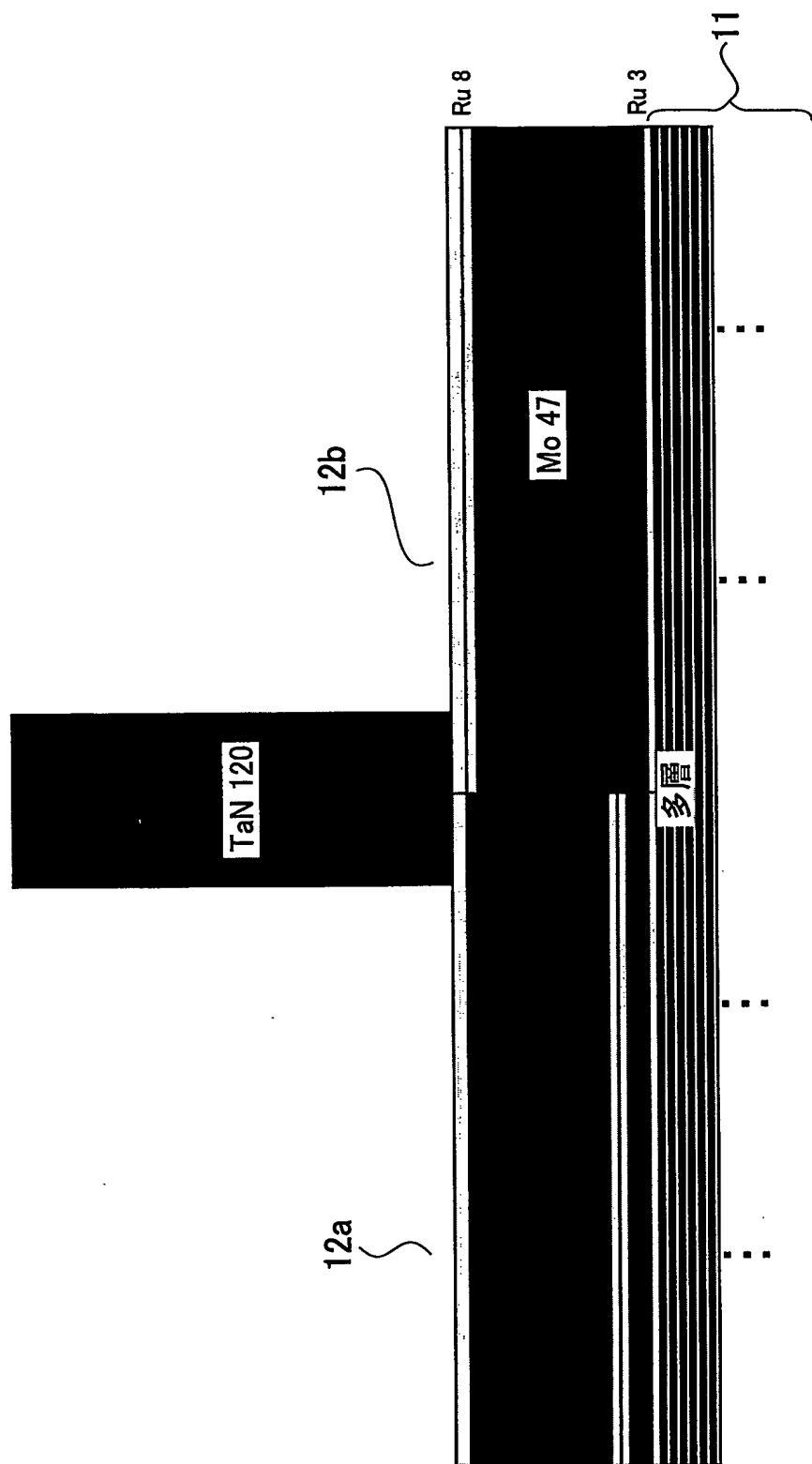


Fig.38

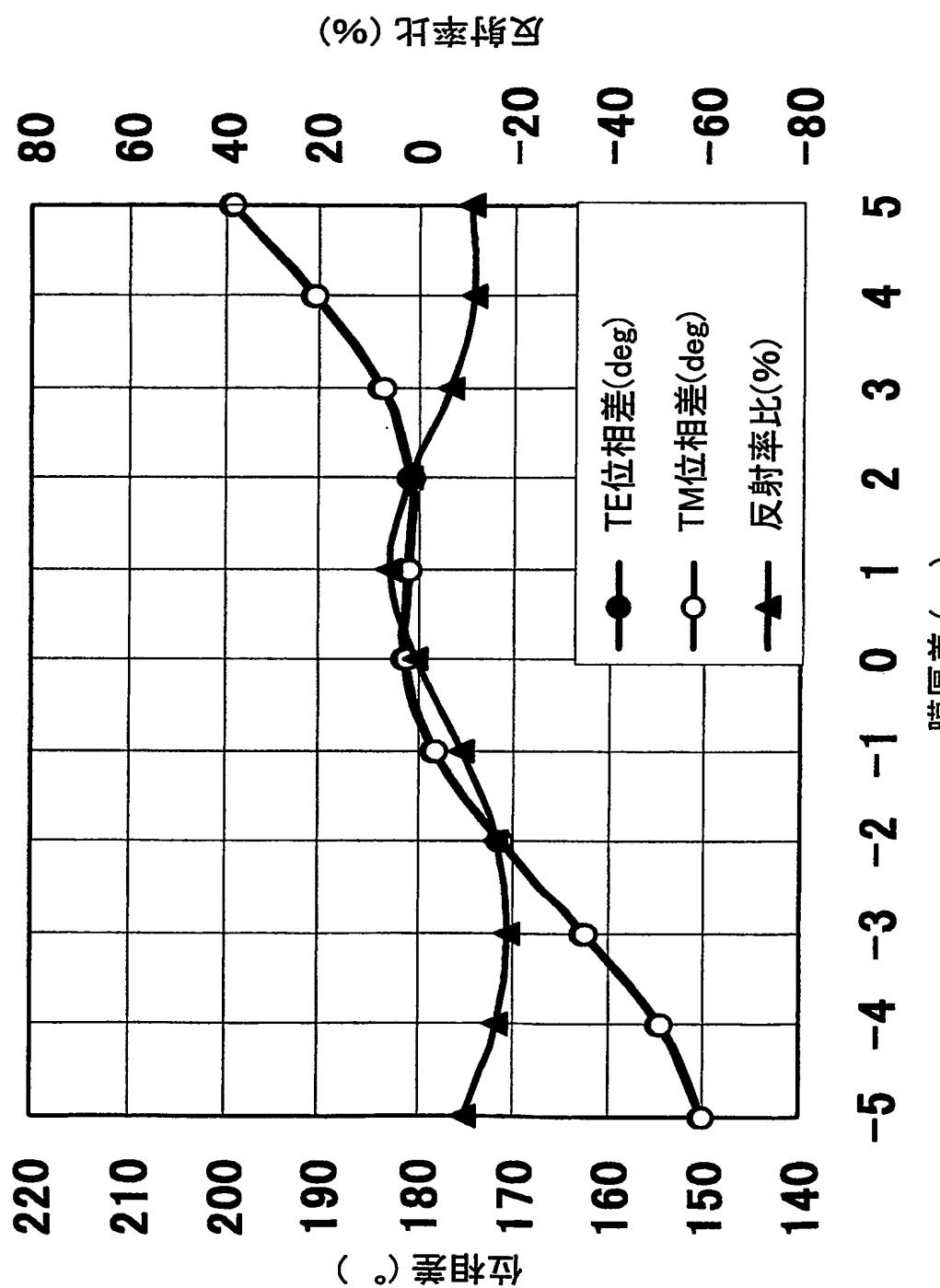


Fig.39

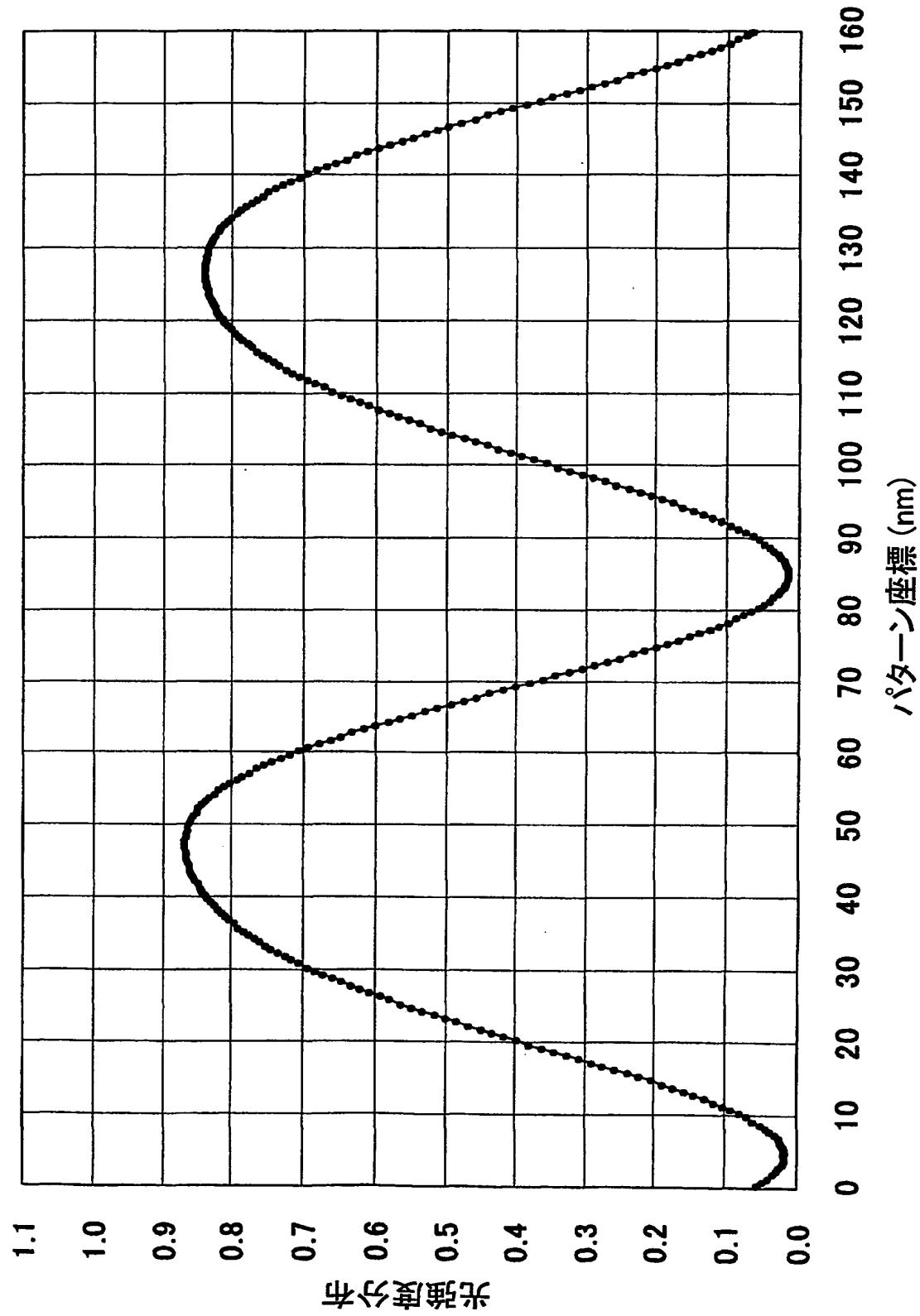


Fig.40

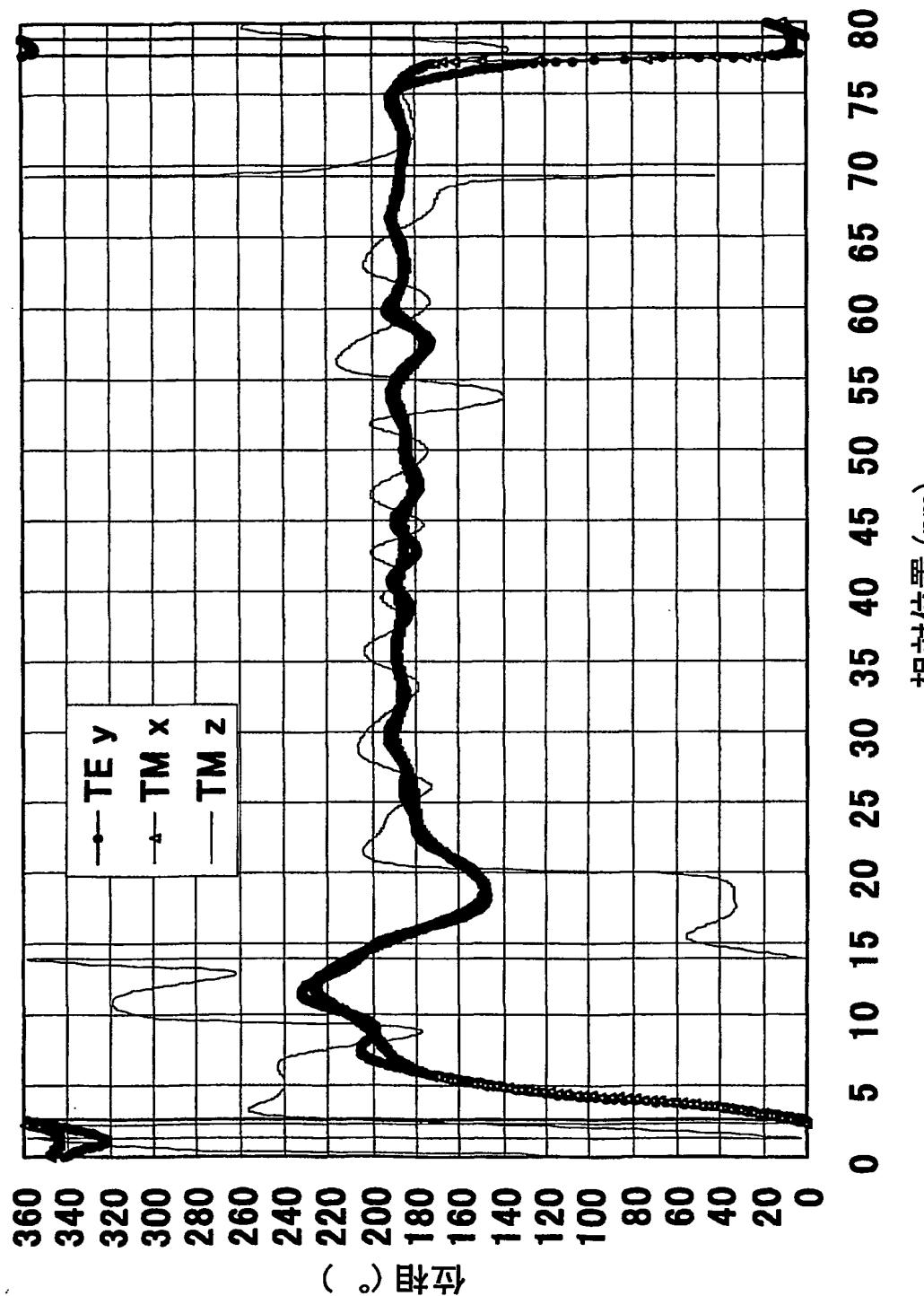


Fig.41

42/48

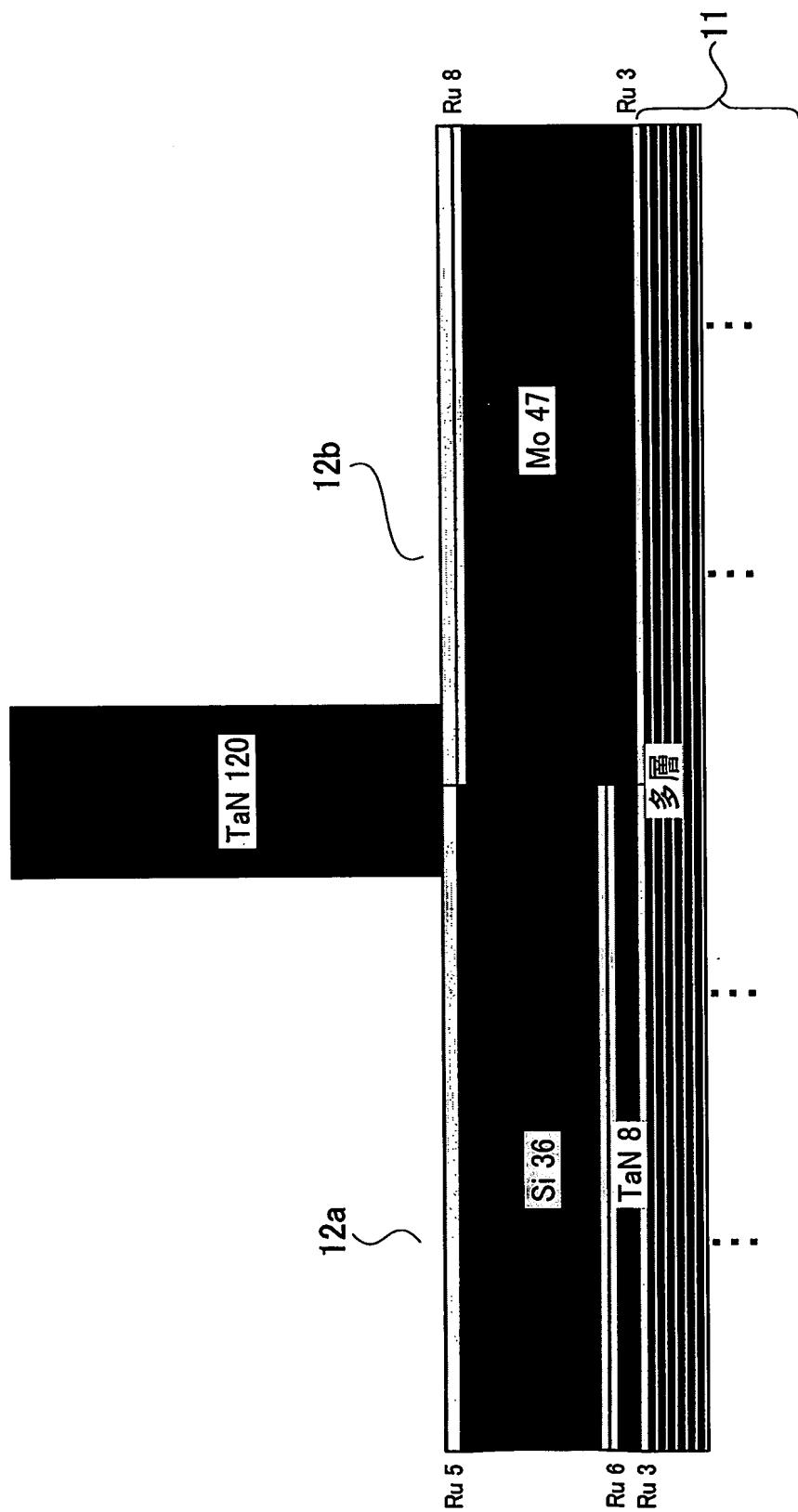


Fig.42

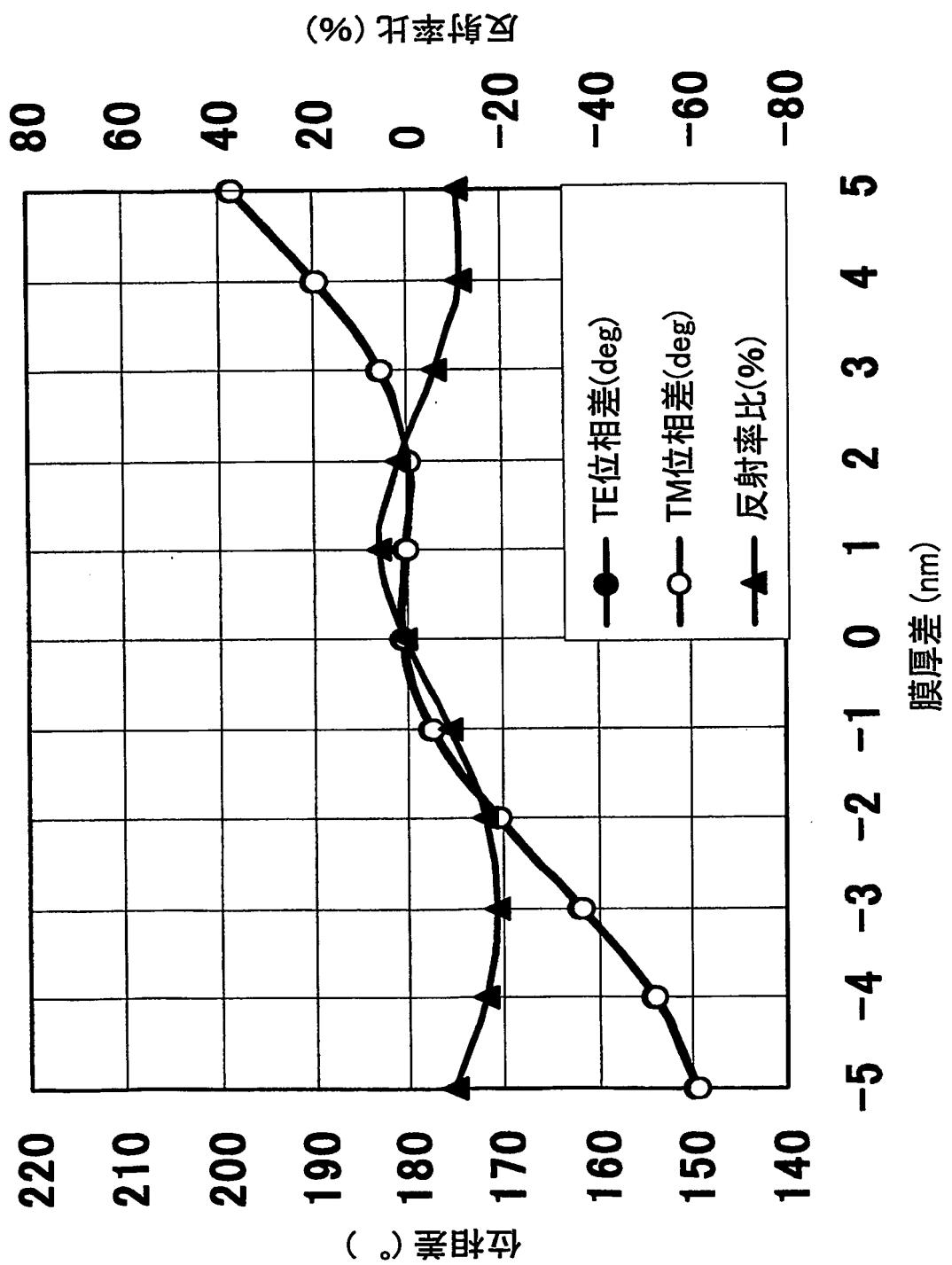


Fig.43

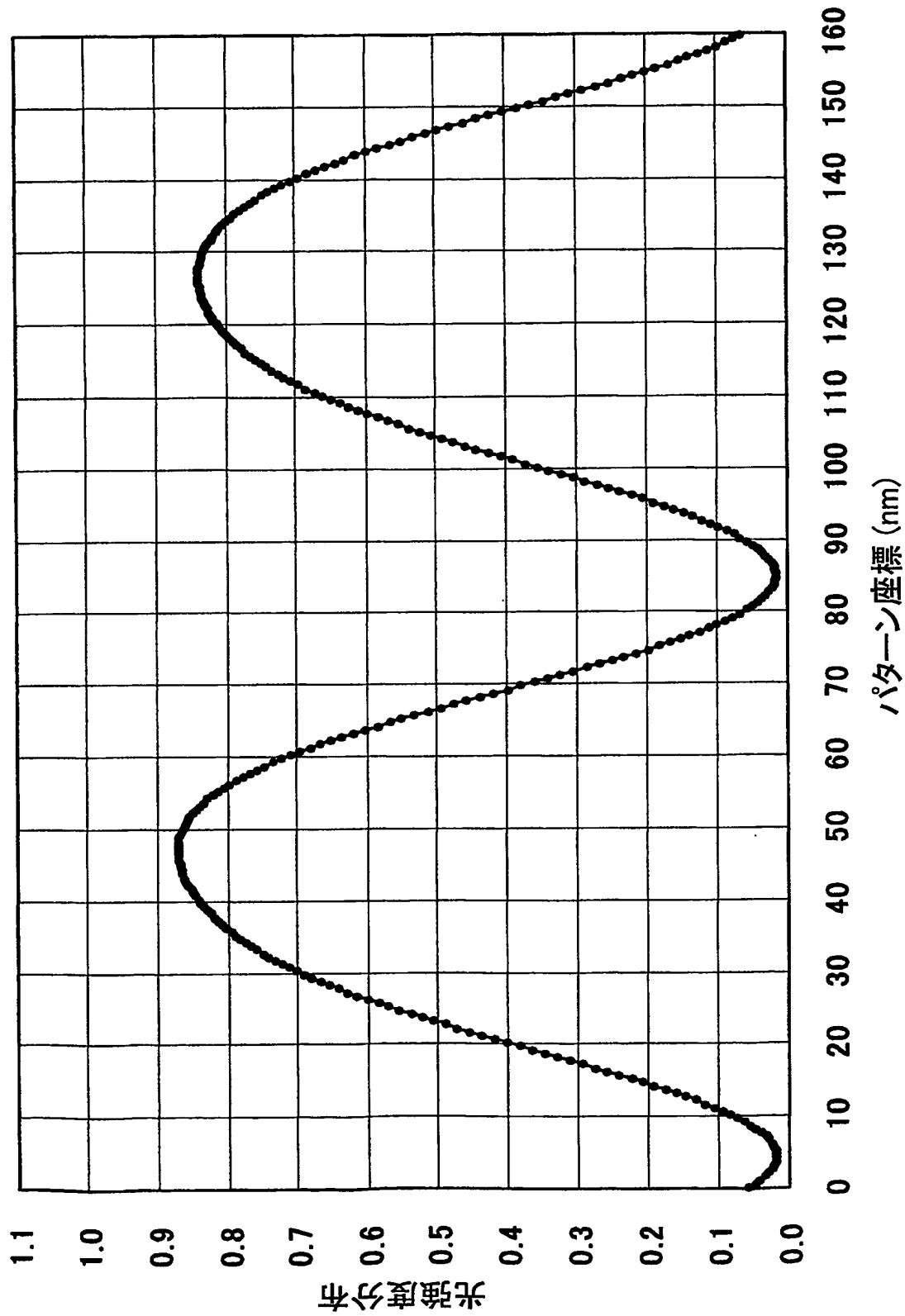


Fig.44

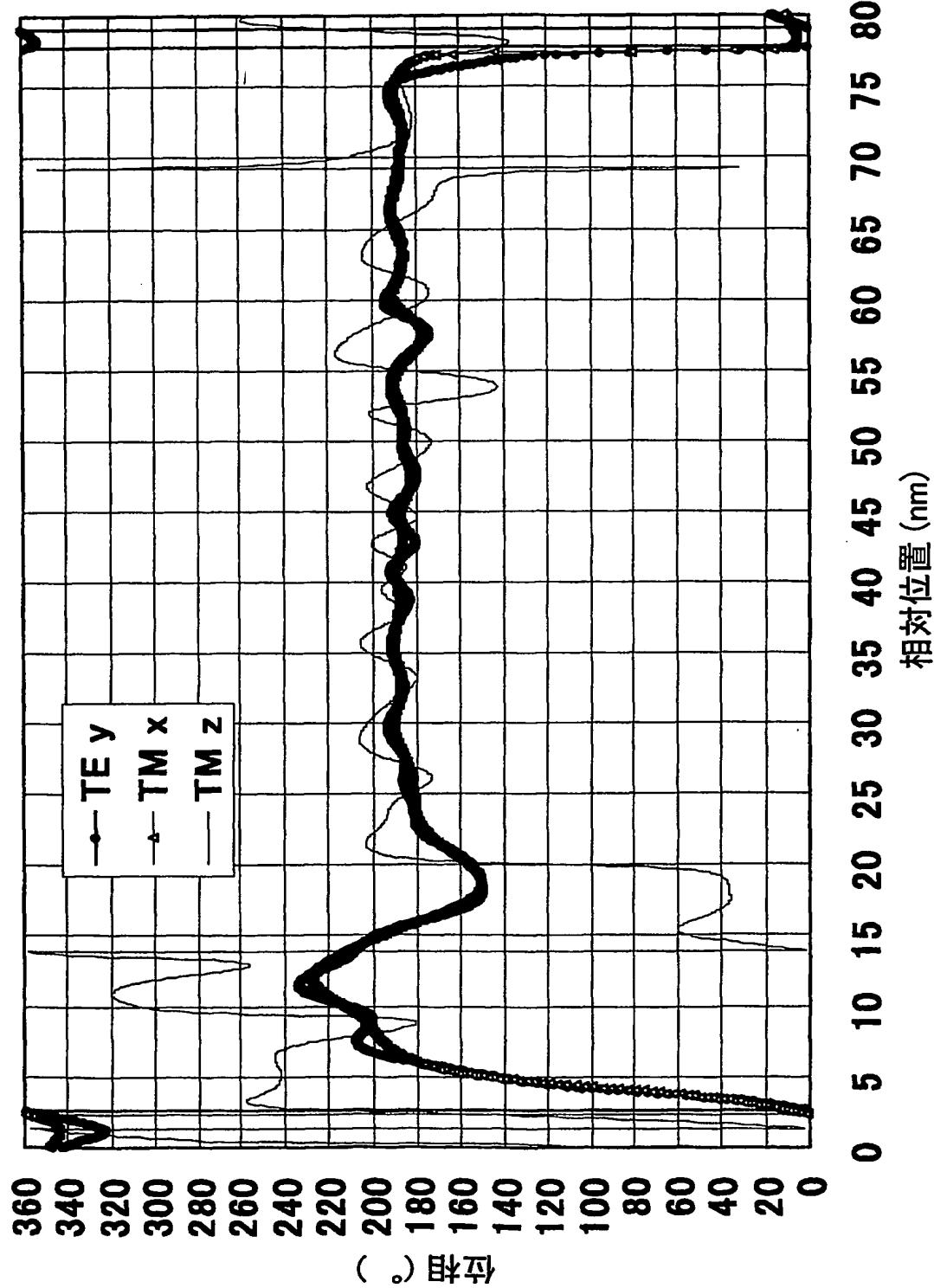


Fig.45

46/48

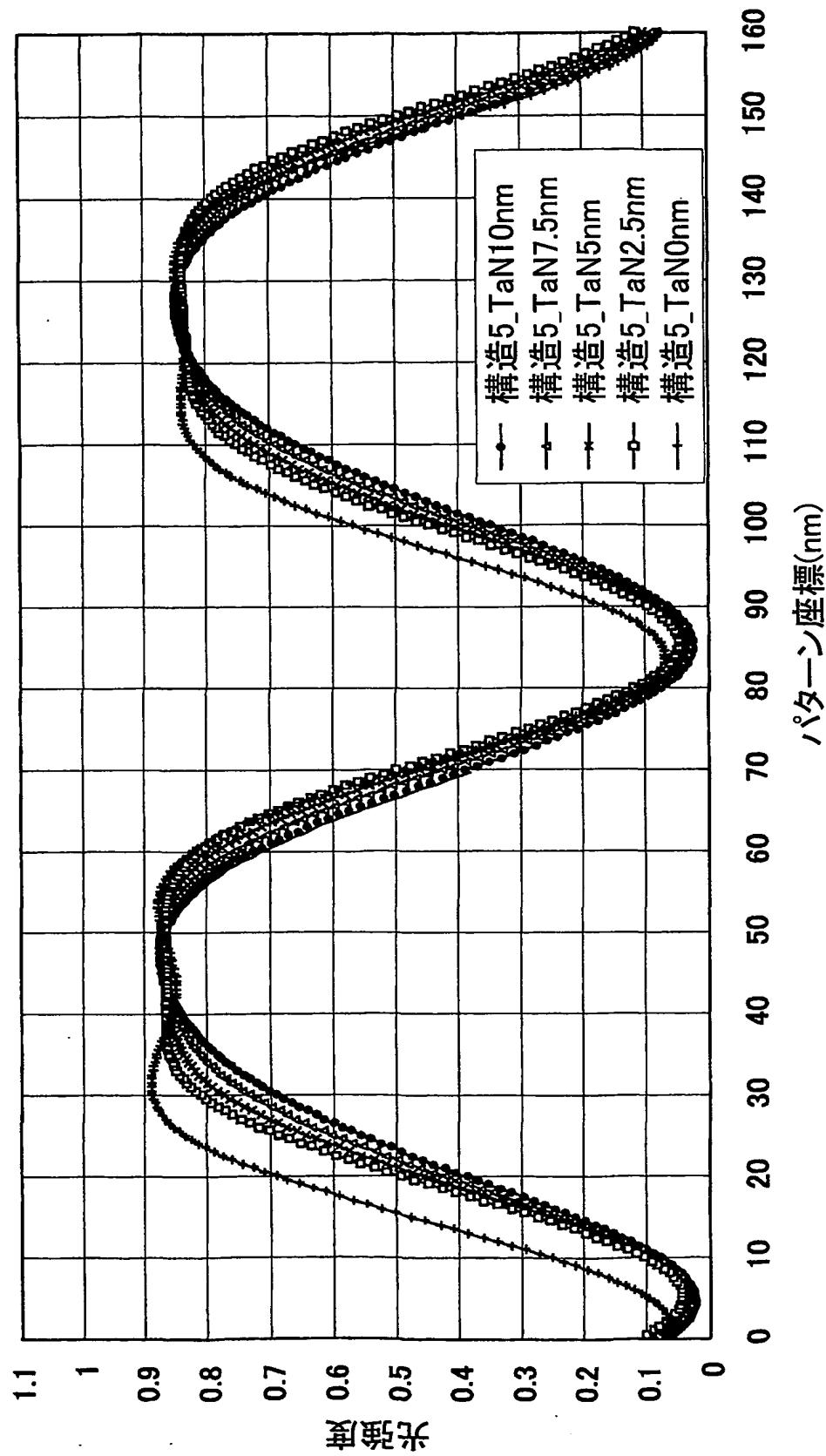


Fig.46

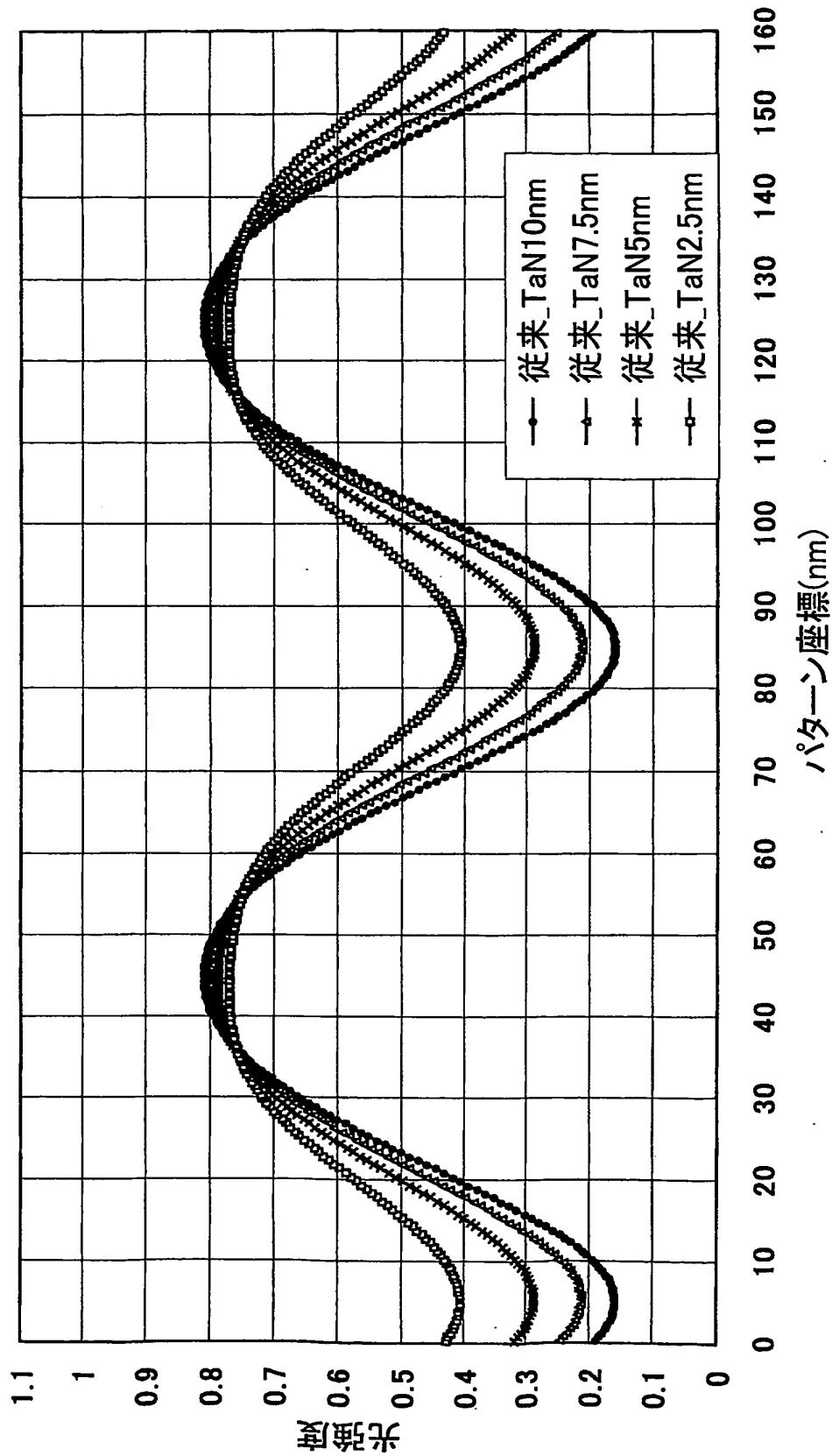


Fig.47

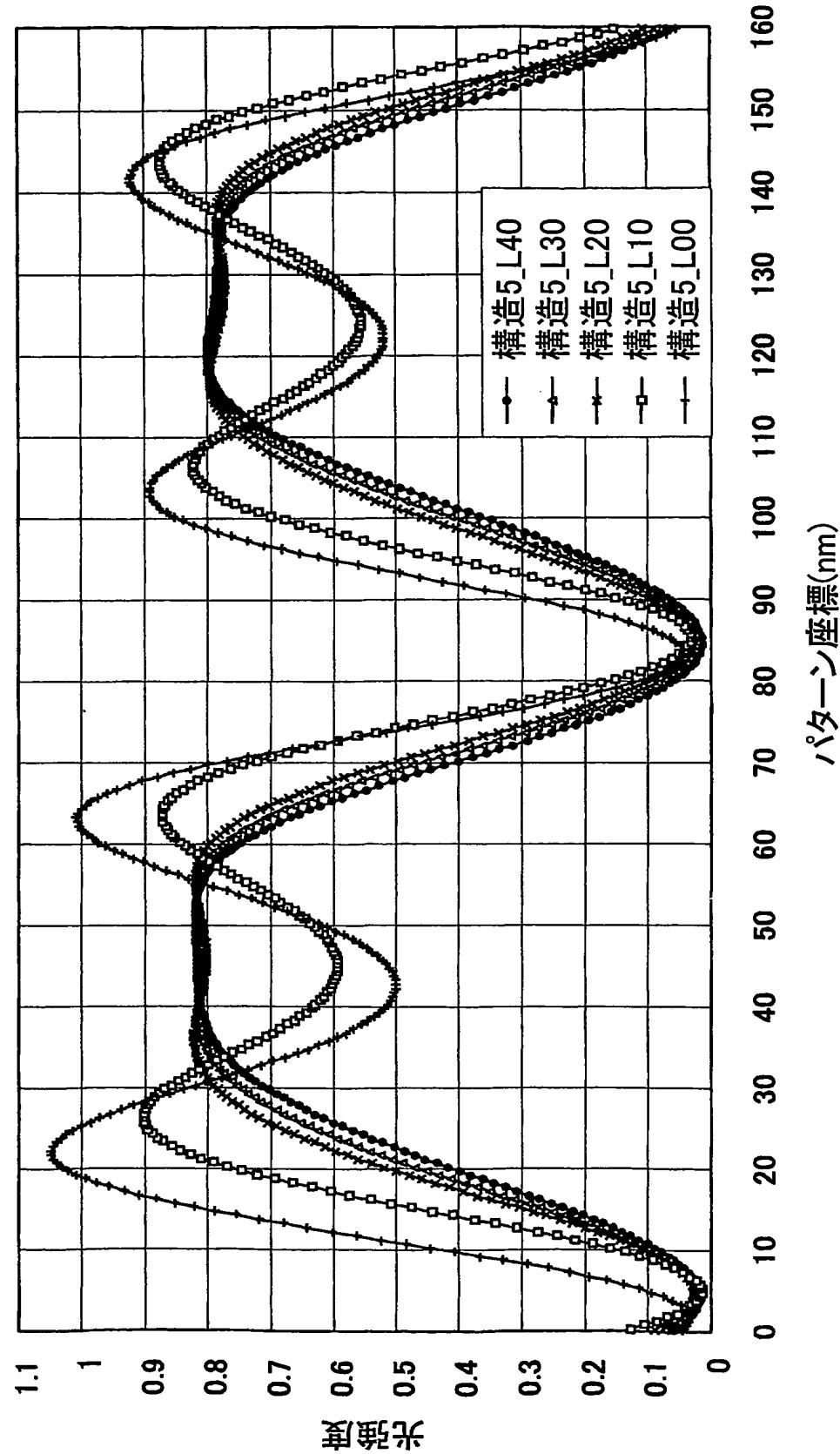


Fig.48

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/08377

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
Int.Cl⁷ G03F1/16, H01L21/027

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ G03F1/08, G03F1/16, H01L21/027

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched
 Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2003
 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2003 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2003

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 5399448 A (Nikon Corp.), 21 March, 1995 (21.03.95), Column 4, line 65 to column 7, line 11; Figs. 3, 4 & JP 5-134385 A Par. Nos. [0024] to [0033]; Figs. 4, 5	1-3, 5, 8-10, 12, 15-17, 20 4, 11 6, 7, 13, 14, 18, 19
Y		
A		
X	US 5641593 A (Canon Kabushiki Kaisha), 24 June, 1997 (24.06.97), Column 6, line 57 to column 7, line 40; Figs. 1, 3 & JP 7-114173 A Par. Nos. [0017] to [0021]; Figs. 1, 3	1, 2, 8-10, 12, 15-17, 20 3-5, 11 6, 7, 13, 14, 18, 19
Y		
A		

 Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
06 October, 2003 (06.10.03)Date of mailing of the international search report
21 October, 2003 (21.10.03)Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/08377

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP 708367 A1 (AT&T Corp.), 24 April, 1996 (24.04.96),	1,2,5,8-10, 12,15-17,20
Y	Column 5, line 2 to column 7, line 17; Figs. 1, 2	3,4,11
A	& JP 8-213312 A Par. Nos. [0020] to [0031]; Figs. 1, 2	6,7,13,14, 18,19
	& US 521031 A & DE 69501452 E	
Y	US 5514499 A (Kabushiki Kaisha Toshiba), 07 May, 1996 (07.05.96), Full text; all drawings	1-5,8-10,12, 15-17,20
	& JP 7-319147 A & KR 168134 B1	
P,X	EP 1260861 A1 (ASML Netherlands B.V.), 27 November, 2002 (27.11.02), Full text; all drawings	1-5,8-10,12, 15-17,20
P,Y	& JP 2003-59822 A & US 2003/31938 A1	11
P,A	& KR 2003006968 A	6,7,13,14, 18,19
Y	JP 7-110571 A (Toppan Printing Co., Ltd.), 25 April, 1995 (25.04.95), Abstract (Family: none)	3
Y	US 5294506 A (Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha), 15 March, 1994 (15.03.94), Abstract; column 2, lines 15 to 54 & JP 4-313754 A Abstract; Par. No. [0009]	3
Y	JP 4-214559 A (Dainippon Printing Co., Ltd.), 05 August, 1992 (05.08.92), Abstract (Family: none)	4
Y	JP 9-311431 A (Toppan Printing Co., Ltd.), 02 December, 1997 (02.12.97), Par. No. [0018] (Family: none)	11
Y	US 5700605 A (Kabushiki Kaisha Toshiba), 23 December, 1997 (23.12.97), Column 7, lines 51 to 56 & JP 8-314116 A Par. No. [0029] & KR 197771 B1 & TW 399247 A	11
Y	JP 8-202016 A (Sony Corp.), 09 August, 1996 (09.08.96), Abstract (Family: none)	11
A	US 2002/045108 A1 (Byoung-taek Lee et al.), 18 April, 2002 (18.04.02), Abstract & JP 2002-122981 A & KR 2002029590 A	1-20

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP03/08377

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 6178221 B1 (Advanced Micro Devices, Inc.), 23 January, 2001 (23.01.01), Abstract (Family: none)	1-20

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/08377

Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

2. Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

3. Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

Claims 1-20 has as a common feature a phase shift mask comprising a reflection multi-layer film substrate for reflecting a exposure light, and a first region and a second region formed on the substrate, wherein respective film thicknesses and complex refractive indexes of a formed film in the first region and a formed film in the second region are set so as to produce a specified phase difference between the reflection light of an exposure light in the first region and the reflection light of an exposure light in the second region.

However, the common feature is well known prior art and is not a special technical feature within the meaning of PCT Rule 13.2, second (continued to extra sheet)

1. As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.

2. As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.

3. As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

4. No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.

No protest accompanied the payment of additional search fees.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP03/08377

Continuation of Box No.II of continuation of first sheet(1)

sentence. In addition, there exists no other common feature to be considered to be a special technical feature within the meaning of PCT Rule 13.2, second sentence, therefore no technical relationship within the meaning of PCT Rule 13 can be found among those different inventions

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. C1' G03F1/16, H01L21/027

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. C1' G03F1/08, G03F1/16, H01L21/027

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922-1996年
 日本国公開実用新案公報 1971-2003年
 日本国実用新案登録公報 1996-2003年
 日本国登録実用新案公報 1994-2003年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	US 5399448 A (Nikon Corporation) 1995. 0 3. 21 第4欄第65行-第7欄第11行、図3、4	1-3, 5, 8-10, 12, 15-17, 20
Y	& JP 5-134385 A 【0024】-【0033】、図 4、5	4, 11 6, 7, 13, 14, 18, 19
A		
X	US 5641593 A (Canon Kabushiki kaisha) 1997. 06. 24 第6欄第57行-第7欄第40行、図1、3	1, 2, 8-10, 12, 15-17, 20
Y	& JP 7-114173 A 【0017】-【0021】、図 1、3	3-5, 11 6, 7, 13, 14, 18, 19
A		

 C欄の続きにも文献が列挙されている。 パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す
もの

「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日
以後に公表されたもの

「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行
日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する
文献(理由を付す)

「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって
出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論
の理解のために引用するもの

「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明
の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以
上の文献との、当業者にとって自明である組合せに
よって進歩性がないと考えられるもの

「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

06. 10. 03

国際調査報告の発送日

21.10.03

国際調査機関の名称及び先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官(権限のある職員)

伊藤 昌哉



2M 8808

電話番号 03-3581-1101 内線 3274

C (続き) 関連すると認められる文献		関連する請求の範囲の番号
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	
X	EP 708367 A1 (AT&T Corp.) 1996. 04. 24 第5欄第2行-第7欄第17行、図1、2	1, 2, 5, 8-10, 12, 15-17, 20
Y	&JP 8-213312 A 【0020】-【0031】、図 1, 2	3, 4, 11
A	&US 521031 A &DE 69501452 E	6, 7, 13, 14, 18, 19
Y	US 5514499 A (Kabushiki Kaisha Toshiba) 199 6. 05. 07 全文、全図 &JP 7-319147 A &KR 168134 B1	1-5, 8-10, 12, 15-17, 20
PX	EP 1260861 A1 (ASML Netherlands B.V.) 200 2. 11. 27 全文、全図	1-5, 8-10, 12, 15-17, 20
PY	&JP 2003-59822 A	11
PA	&US 2003/31938 A1 &KR 2003006968 A	6, 7, 13, 14, 1 8, 19
Y	JP 7-110571 A (凸版印刷株式会社) 1995. 0 4. 25 要約 (ファミリーなし)	3
Y	US 5294506 A (Mitsubishi Denki Kabushiki Kaish a) 1994. 03. 15 要約、第2欄第15行-第54行 &JP 4-313754 A 要約、【0009】	3
Y	JP 4-214559 A (大日本印刷株式会社) 1992. 08. 05 要約 (ファミリーなし)	4
Y	JP 9-311431 A (凸版印刷株式会社) 1997. 1 2. 02 【0018】 (ファミリーなし)	11
Y	US 5700605 A (Kabushiki Kaisha Toshiba) 199 7. 12. 23 第7欄第51行-第56行 &JP 8-314116 A 【0029】 &KR 197771 B1 &TW 399247 A	11
Y	JP 8-202016 A (ソニー株式会社) 1996. 0 8. 09 要約 (ファミリーなし)	11
A	US 2002/045108 A1 (Byoung-taek Lee et al.) 2002. 04. 18 要約 &JP 2002-122981 A &KR 2002029590 A	1-20
A	US 6178221 B1 (Advanced Micro Devices, Inc.) 2001. 01. 23 要約 (ファミリーなし)	1-20

第Ⅰ欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見 (第1ページの2の続き)

法第8条第3項 (PCT 17条(2)(a)) の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。

1. 請求の範囲 _____ は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。つまり、
2. 請求の範囲 _____ は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、
3. 請求の範囲 _____ は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に従って記載されていない。

第Ⅱ欄 発明の単一性が欠如しているときの意見 (第1ページの3の続き)

次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。

請求の範囲1～20は、露光光を反射する反射多層膜基板と、当該反射多層膜基板上に形成された第1領域及び第2領域とを具備するとともに、前記第1領域の形成膜および前記第2領域の形成膜における各膜厚および各複素屈折が、前記第1領域での露光光の反射光と前記第2領域での露光光の反射光とで所定の位相差が生じるように設定されている位相シフトマスクを共通事項として有している。

しかし、上記共通事項は、従来から知られている先行技術であり、PCT規則13.2の第2文の意味において、特別な技術的特徴ではない。また、PCT規則13.2の第2文の意味において特別な技術的特徴と考えられる他の共通事項は存在しないので、それらの相違する発明の間にPCT規則13の意味における技術的な関係を見いだすことはできない。

1. 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求の範囲について作成した。
2. 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。
3. 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
4. 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。

追加調査手数料の異議の申立てに関する注意

追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあつた。
 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかつた。